การประขุกต์ใช้เทคนิคการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าและเทคนิคการสบัตเตอริงในการสร้างแอคชั่วเอเตอร์ ลักษณะคานสองชั้นแบบโลหะผสมจำรูป

นายเอกยุทธ ว่องวีระยุทธ์

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกรื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเกรื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2555

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บทคัดย่อและแฟ้มข้อมูลฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ที่ให้บริการในคลังปัญญาจุฬาฯ (CUIR)

เป็นแฟ้มข้อมูลของนิสิตเจ้าของวิทยานิพนธ์ที่ส่งผ่านทางบัณฑิตวิทยาลัย

The abstract and full text of theses from the academic year 2011 in Chulalongkorn University Intellectual Repository(CUIR)

are the thesis authors' files submitted through the Graduate School.

APPLICATION OF ELECTROPLATING AND SPUTTERING TECHNIQUES IN FABRICATION OF SHAPE MEMORY ALLOY BIMORPH ACTUATOR

Mr.Eakayoot Wongweerayoot

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Engineering Program in Mechanical Engineering Department of Mechanical Engineering Faculty of Engineering Chulalongkorn University Academic Year 2012 Copyright of Chulalongkorn University

| หัวข้อวิทยานิพนธ์ | การประขุกต์ใช้เทคนิคการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าและ | | |
|---------------------------------|---|--|--|
| | เทคนิคการสปัตเตอริงในการสร้างแอคชั่วเอเตอร์ | | |
| | ลักษณะคานสองชั้นแบบโลหะผสมจำรูป | | |
| โดย | นายเอกยุทธ ว่องวีระยุทธ์ | | |
| สาขาวิชา | วิศวกรรมเครื่องกล | | |
| อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.อลงกรณ์ พิมพ์พิณ | | |

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วน หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

> _____คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เถิศหิรัญวงศ์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

_____ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย์ คร.กุณฑินี มณีรัตน์)

____อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.อลงกรณ์ พิมพ์พิณ)

กรรมการ

(อาจารย์ คร.วีระยุทธ ศรีธุระวานิช)

____กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์ คร. ใชยณรงค์ จักรธรานนท์)

เอกยุทธ ว่องวีระยุทธ์ : การประยุกต์ใช้เทคนิคการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าและเทคนิคการ สปัตเตอริงในการสร้างแอคชัวเอเตอร์ลักษณะคานสองชั้นแบบโลหะผสมจำรูป. (APPLICATION OF ELECTROPLATING AND SPUTTERING TECHNIQUES IN FABRICATION OF SHAPE MEMORY ALLOY BIMORPH ACTUATOR) อ.ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์หลัก : ผศ. ดร.อลงกรณ์ พิมพ์พิณ, 119 หน้า.

้งานวิจัยนี้มีแนวคิดในการพัฒนากระบวนการสร้างไมโครแอกชัวเอเตอร์แบบโลหะผสมจำรูปที่มี ้ ลักษณะเป็นกานสองชั้นซึ่งประกอบด้วยนิทินอลกับทองแดง โดยกระบวนการสร้างเป็นกระบวนการที่ง่ายไม่ ้ ซับเซ้อนและไม่ใช้แผ่นซิลิกอนเทคนิคที่พัฒนาขึ้นมาริ่มจากสร้างโครงสร้างทองแจงแบบลอยตัวที่มีความหนา 12 ้ไมโกรเมตร ด้วยเทคนิคการชบโลหะไฟฟ้าเคมืองบนแผ่นสเตนเอสที่มีการสร้างแบบหล่อด้วยโฟโต้รีซิสเป็น ฐปร่างของไมโครแอคชั่วเอเตอร์อยู่ด้านบน หลังจากนั้นจึงนำไปถ้างด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ซึ่งจะทำ ให้ โกรงสร้างทองแคงหลดออกมา ในขั้นตอนต่อไปจึงนำโกรงสร้างทองแคงแบบลอยตัวไปเคลือบฟิล์มนิทินอลที่ ความหนา 5 ไมโครเมตร ด้วยเทกนิคการสปัตเตอริง แล้วจึงนำไมโครแอกชัวเอเตอร์ ไปทำการอบฟิล์มนิทินอลที่ อุณหภูมิสูงด้วยเตาอบแบบหลอดควอทซ์ โดยมีก๊าซอาร์กอนไหลผ่าน ไมโครแอคชั่วเอเตอร์ที่สร้างขึ้นมีรูปร่าง คล้ายตัวยุคว่ำประกอบด้วยขา2 ข้าง (0.25x22 ตารางมิลลิเมตร)และส่วนปลาย (3x3 ตารางมิลลิเมตร) งานวิจัยได้ทำ การทคลองอบฟิล์มนิทินอลที่อุณหภูมิ 500,600 และ 650 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 30 นาที และทำการทคสอบ คณลักษณะจำเพาะของฟิล์มนิทินอลด้วยวิธีต่างๆพบว่า การอบฟิล์มนิทินอลที่อณหภมิ 600 และ 650 องศา เซลเซียส สามารถสร้างฟิล์มนิทินอลที่มีโครงสร้างผลึกได้ แต่จะเกิดออกไซด์บนผิวฟิล์มหลังการอบแล้ว หลังจาก นั้นได้นำไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ไม่ทำการอบและทำการอบด้วยแบบหล่อคอนกรีตลักษณะแบนราบและโค้ง (รัศมี ความโค้ง 22 มิลลิเมตร) ที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส มาทำการทคสอบค้วยการวัคระยะกระคกเมื่อเพิ่มอุณหภูมิ ้โดยการให้ความร้อนแก่ไมโครแอคชั่วเอเตอร์โดยตรงพบว่า ไมโกรแอกชั่วเอเตอร์ที่ทำการอบจะมีระยะกระคกที่สูง กว่าไมโครแอคชั่วเอเตอร์ที่ไม่ทำการอบแต่ลักษณะในการอบส่งผลต่อระยะกระดกของไมโครแอคชั่วเอเตอร์เพียง เล็กน้อยเท่านั้น โดยที่ระยะกระดกของไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ไม่ทำการอบกับไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการอบ ้ด้วยแบบหล่อแบนราบและ โค้งที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส จะมีค่าเท่ากับ 0.57, 0.94 และ 0.84 มิลลิเมตร ตามลำดับ หลังจากนั้นจึงทำการทคสอบวัคระยะกระคกของไมโครแอคชั่วเอเตอร์ ด้วยการจ่ายกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 0.50-1.25 แอมแปร์ ในช่วงความถี่ตั้งแต่ 0.5-2.5 เฮิร์ ทซแก่ ไมโกรแอกชัวเอเตอร์ พบว่า ระยะระหว่างระยะกระดกสูงสุดกับ ระยะกระดกต่ำสุดของไมโกรแอกชัวเอเตอร์ที่ไม่ทำการอบกับไมโกรแอกชัวเอเตอร์ที่อบด้วยแบบหล่อแบนราบ และ โค้ง ที่กระแสไฟฟ้า 1.25 แอมแปร์และความถี่ 0.5 เฮิร์ ทช จะมีค่าเท่ากับ 0.12, 1.7 และ 1.3 มิลลิเมตร ตามลำคับ ภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล ลายมือชื่อนิสิต สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ปีการศึกษา 2555

5370391521 : MAJOR MECHANICAL ENGINEERING

KEYWORDS : MICRO-ACTUATOR / SHAPE MEMORY ALLOY / BIMORPH / FABRICATION PROCESS / ELECTROPLATING TECHNIQUE / SPUTTERING TECHNIQUE

EAKAYOOT WONGWEERAYOOT : APPLICATION OF ELECTROPLATING AND SPUTTERING TECHNIQUES IN FABRICATION OF SHAPE MEMORY ALLOY BIMORPH ACTUATOR. ADVISOR : ASSIST. PROF. ALONGKORN PIMPIN, Ph.D., 119 pp.

This study aims to develop a new fabrication process of SMA nitinol-copper bimorph actuator that is simple and does not require a silicon substrate. For proposed fabrication process, a 12-um freestanding copper's structure is initially formed by electroplating technique to deposit copper on stainless substrate between photoresist molds. After achieving the desired thickness, the photoresist mold is removed using Sodium Hydroxide to release copper's structure. Consequently, a 5-um nitinol thin film is deposited on freestanding copper's structure by sputtering technique, and the crystallization is then performed at high temperature in a quartz tube furnace with argon overflow. The geometry of actuator is designed as reverse U shape including two legs (0.25x22 mm²) and square tip (3x3 mm²). The effect of the crystallization is investigated under various temperature conditions, i.e. 500, 600 and 650 °C, for 30 minutes and pre-stressing condition inside mold, i.e. straight and curve molds (radius of curvature of 22 mm). With X-ray diffraction, Energy-dispersive spectroscopy and Differential scanning calorimetry, the results show that, crystallizing temperature at 600 and 650° C are able to organize crystal structure of nitinol. However, oxide on surface is still unavoidable after crystallization. To compare the performance of actuator at these different crystallization conditions, three bimorph actuators, i.e. without crystallization, with crystallization at 650°C in straight and curve molds, are tested in two experiments. In the first experiment, the deflection of actuator while applying temperature between 20-100°C to actuator directly is examined. The results show that, crystallized actuators have larger deflection than that without crystallization. In addition, the effect of pre-stressing condition on the deflection is relatively small. The deflection of the actuator without crystallization and that is crystallized in straight and curve molds are 0.57, 0.94 and 0.84 mm at 80°C, respectively. In the second experiment, the deflection of actuator while applying current of 0.50-1.25 A at frequency of 0.5-2.5 Hz is examined. The results are quite similar to the previous experiment. The deflection amplitude of the actuator without crystallization actuator and that is crystallized in straight and curve molds are 0.12, 1.7 and 1.3 mm at 1.25 A and 0.5 Hz, respectively.

 Department :
 Mechanical Engineering
 Student's Signature

 Field of Study :
 Mechanical Engineering
 Advisor's Signature

 Academic Year :
 2012

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยการช่วยเหลือจากท่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ พิมพ์พิณ" ซึ่งท่านได้เสียสละทั้งเวลางานและเวลาส่วนตัวให้ กวามรู้ กำแนะนำและแลกเปลี่ยนกวามกิดเห็น ทั้งด้านงานวิจัยและการดำเนินชีวิตที่เป็นประโยชน์ ยิ่ง ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ได้ผลักดันผู้วิจัยให้มีกำลังใจในการทำงานวิจัยฉบับนี้

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ คร.วีระยุทธ ศรีธุระวานิช ที่ช่วยให้คำปรึกษาและ คำแนะนำต่างๆในการแก้ปัญหา ทำให้วิทยานิพนธ์สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก "ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" จากกองทุน รัชคาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 18 (2/2555)

ขอขอบพระคุณคร.อนุรัตน์ วิศิษฎ์สรอรรถ และนักวิจัยของหน่วยปฏิบัติงานนาโน อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอบคุณพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.ธาชาย เหลืองวรนันท์ และนิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และขอขอบคุณนิสิตของห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์เอ็นจิเนียริง ภาควิชา วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้สนับสนุนและเอื้อเฟื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการทดลองต่างๆ ทำให้งานวิจัยนี้สำเร็จได้ด้วยดี

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ณ ห้องปฏับิติการวิจัยเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาคและนาโน เทคโนโลยีแห่งนี้ ผู้วิจัยได้รับกำลังใจ ความสุข ความเอื้อเฟื้อ และคำแนะนำมากมายจาก พี่ เพื่อน และน้องในห้องปฏิบัติการเป็นอย่างดี ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งแค่ พี่กฤษณ์กร ประไพพิทยาคุณ พี่กรกช เพชรดี พี่ภากร นนทิวัฒน์วณิช พี่ปริญเอก ร่มไตรรัตน์ พี่เชาวนพันธ์ เหล็กจำ พี่สมพงษ์ เจริญบูลย์วิวัฒน์ พี่เกษม ตันธนะศิริวงศ์ พี่ในห้องปฏิบัติการที่ช่วยเหลือและให้กำปรึกษาในการ ทำงานวิจัยด้วยความยินดีมาตลอด ขอขอบคุณเพื่อนๆ นายเกริกฐากูร พันธ์พัฒนกุล นายสรายุทธ แสวงผล รวมถึงเพื่อนที่เรียนปริญญาโทมาด้วยกันทุกคน ที่คอยให้กำลังใจและร่วมฟ้นฝ่าอุปสรรค ตลอดการทำงานมาด้วยกัน และขอขอบคุณน้องวิศวกรรมนาโนรุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ที่คอยให้ กำลังใจและสร้างกวามสนุกสนานแก่ผู้วิจัยมาตลอด

เหนือสิ่งอื่นใดผู้วิจัยต้องขอกราบขอบพระคุณ นายไพบูลย์ ว่องวีระยุทธ์ และนางลัดดา ว่องวีระยุทธ์ บิดา-มารดาของผู้วิจัยที่ได้เลี้ยงดูและให้การสนับสนุนในทุกๆด้านมาโดยตลอด ทำให้ ผู้วิจัยประสบความสำเร็จในวันนี้

สารบัญ

| | | หน้า |
|---------|------|---|
| บทคัดย่ | อภาษ | มาไทยง |
| บทคัดย่ | อภาษ | มาอังกฤษจ |
| กิตติกร | รมปร | ะกาศน |
| สารบัญ | | |
| สารบัญ | ตารา | រ លូ |
| สารบัญ | ภาพ | ນີ |
| บทที่ 1 | บทเ | ຳ1 |
| | 1.1 | ที่มาและความสำคัญ1 |
| | 1.2 | หลักการของไมโครแอคชั่วเอเตอร์2 |
| | 1.3 | หลักการ โลหะผสมจำรูปและการประยุกต์ใช้งานที่ผ่านมา |
| | 1.4 | ปัญหาของการสร้างไมโครแอคชั่วเอเตอร์แบบคานสองชั้น |
| | 1.5 | กระบวนการสร้างไมโครแอคชั่วเอเตอร์ที่ใช้นิทินอลเป็นส่วนประกอบ |
| | | 1.5.1 กระบวนการเคลือบผิวด้วยนิทินอล16 |
| | | 1.5.2 กระบวนการอบหลังจากเคลือบผิวด้วยนิทินอล |
| | 1.6 | แนวทางในการคำเนินงานวิจัย |
| | 1.7 | วัตถุประสงค์ |
| | 1.8 | ขอบเขตงานวิจัย |
| | 1.9 | ประโยชน์ที่คาดว่าจะใด้รับ |
| | 1.10 | ระเบียบขั้นตอนการวิจัย |
| บทที่ 2 | แนว | คิดเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของไมโครแอคชัวเอเตอร์ |
| | 2.1 | การศึกษาระยะกระคกของใมโครแอคชั่วเอเตอร์ด้วยระเบียบวิธีการทาง |
| | | ใฟในต์อิลิเมนต์ |
| | 2.2 | การศึกษาการถ่ายเทความร้อนของไมโครแอคชั่วเอเตอร์แบบโลหะผสมจำรูปที่มี |
| | | ลักษณะเป็นกานสองชั้น |
| | 2.3 | สรุปผลการศึกษาพารามิเตอร์ของไมโครแอคชั่วเอเตอร์ |
| บทที่ 3 | กระ | บวนการสร้างไมโครแอคชั่วเอเตอร์ |
| | 3.1 | กระบวนการสร้างโครงสร้างทองแคงแบบลอยตัว |

| | | | หน้า |
|--------------|-----------------------|--|-------|
| | 3.1.1 | ขั้นตอนการสร้างแบบหล่อ | 35 |
| | 3.1.2 | ข้อจำกัดในการสร้างแบบหล่อ | 37 |
| | 3.1.3 | ขั้นตอนการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าเคมี | 38 |
| | 3.1.4 | ข้อจำกัดในขั้นตอนการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าเคมี | 41 |
| 3.2 | กระบว | วนการเคลือบผิวด้านบนของโครงสร้างทองแดงแบบลอยตัวด้วยนิทินอล | 43 |
| | 3.2.1 | ขั้นตอนการเกลือบผิวด้วยนิทินอล | 43 |
| | 3.2.2 | ข้อจำกัดในขั้นตอนการเกลือบผิวด้วยนิทินอล | 44 |
| | 3.2.3 | ขั้นตอนการอบฟิล์มนิทินอล | 45 |
| | 3.2.4 | ข้อจำกัดในขั้นตอนการอบฟิล์มนิทินอล | 47 |
| 3.3 | อิทธิผ | ลของการอบฟิล์มที่อุณหภูมิสูงต่อคุณลักษณะจำเพาะของนิทินอล | 48 |
| | 3.3.1 | การทดสอบด้วยเครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ | 49 |
| | 3.3.2 | การทดสอบฟิล์มนิทินอลด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงาน | 51 |
| | 3.3.3 | การทดสอบฟิล์มนิทินอลด้วยเครื่องวัดการถ่ายเทความร้อน | 57 |
| 3.4 | สรุปผ | ลการสร้างไมโครแอคชัวเอเตอร์แบบใหม่ | 60 |
| บทที่4 การ | ทคสอบ | ไมโครแอคชั่วเอเตอร์ | 64 |
| 4.1 | การทศ | าสอบการตอบสนองเชิงสถิตย์ | 65 |
| 4.2 | สรุปผ | ลการทคสอบการตอบสนองเชิงสถิตย์ | 68 |
| 4.3 | การทศ | าสอบการตอบสนองเชิงจลน์ | 71 |
| 4.4 | สรุปผ | ลการทคสอบการตอบสนองเชิงจลน์ | 75 |
| 4.5 | การปร | ะะยุกต์ใช้งานไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่สร้างขึ้น | 79 |
| 4.6 | สรุปผ | ลการทคสอบไมโครแอคชั่วเอเตอร์ | 82 |
| บทที่ 5 สรุบ | ุ่มผลการ ^ะ | วิจัย | 84 |
| รายการอ้างอื | ว้ง | | 90 |
| ภาคผนวก | ••••• | | 93 |
| ภาค | เผนวก ก | า วัสดุอุปกรณ์ในกระบวนการสร้างไมโครแอคชัวเอเตอร์ | 94 |
| ภาค | เผนวก เ | เ เครื่องมือที่ใช้ในการทคสอบคุณลักษณะจำเพาะของไมโคร | |
| | | แอกชัวเอเตอร์ | . 106 |
| ภาค | เผนวก ค | า การทคสอบไมโครแอคชัวเอเตอร์เบื้องต้น | . 110 |
| ภาค | เผนวก ง | ชุดอุปกรณ์และการจัดการผลในการทดสอบไมโครแอคชั่วเอเตอร์ | . 114 |

| | หน้า |
|----------------------------|------|
| ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์ | 119 |

สารบัญตาราง

| | หา | น้ำ |
|--------------|---|-----|
| ตารางที่ 1.1 | เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของพารามิเตอร์ที่สำคัญของหลักการต่างๆที่นำมาประยุกต์ใช้ | |
| | กับใมโครแอคชั่วเอเตอร์ | .4 |
| ตารางที่ 2.1 | คุณสมบัติของเงิน ทองแคงและนิกเกิล | 22 |
| ตารางที่ 2.2 | รายละเอียดในการกำหนดค่าภายในโปรแกรมไฟในต์อิลิเมนต์ ANSYS | 23 |
| ตารางที่ 2.3 | คุณสมบัติของวัสดุในการทำนายระยะกระดกด้วยโปรแกรมไฟในต์อิลิเมนต์ | |
| | ANSYS | 24 |
| ตารางที่ 2.4 | พารามิเตอร์ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงก่าความยาวของคานร่วมกับความหนา | |
| | ของทองแคงในโปรแกรมไฟไนต์อิลิเมนต์ ANSYS | 25 |
| ตารางที่ 2.5 | พารามิเตอร์สำหรับการศึกษาการถ่ายเทความร้อนของไมโครแอคชั่วเอเตอร์ | 31 |
| ตารางที่ 2.6 | พารามิเตอร์ในการศึกษาการถ่ายเทความร้อนของไมโครแอคชั่วเอเตอร์โดย | |
| | เปลี่ยนแปลงก่าความกว้างของกานร่วมกับกวามหนาของทองแดง | 32 |
| ตารางที่ 3.1 | พารามิเตอร์ในการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าเคมี | 40 |
| ตารางที่ 3.2 | พารามิเตอร์สำหรับการทดลองในขั้นตอนการอบฟิล์มนิทินอล | 49 |
| ตารางที่ 3.3 | กระบวนการสร้างโครงสร้างทองแดงแบบลอยตัว | 62 |
| ตารางที่ 3.4 | ขั้นตอนการเคลือบผิวด้วยนิทินอล | 63 |
| ตารางที่ 3.5 | ขั้นตอนการอบฟิล์มนิทินอล | 63 |
| ตารางที่ 4.1 | การเปรียบเทียบความร้อนที่ถ่ายเทระหว่างขาของไมโครแอคชัวเอเตอร์กับฮอต | |
| | เพลตและอากาศภายนอก | 71 |
| ตารางที่ 4.2 | พารามิเตอร์ในการทดสอบการตอบสนองเชิงจลน์ | 73 |
| ตารางที่ 4.3 | อุณหภูมิของไมโครแอคชั่วเอเตอร์ที่ทำการอบเมื่อได้รับการจ่ายกระแสไฟฟ้า | |
| | ต่างๆที่ความถี่ 0.5 เฮิร์ทซ | 79 |

สารบัญภาพ

| | ห | เน้า |
|-------------|--|------|
| ภาพที่ 1.1 | กราฟระหว่างแรงกระทำสูงสุดกับระยะขยับสูงสุดของแอคชัวเอเตอร์ [1] | 3 |
| ภาพที่ 1.2 | กราฟระหว่างความถี่สูงสุดในการใช้งานและระยะขยับสูงสุดของ | |
| | แอกชัวเอเตอร์ [1] | 3 |
| ภาพที่ 1.3 | กราฟการเปลี่ยนแปลงเฟสของวัสคุโลหะผสมจำรูป | 6 |
| ภาพที่ 1.4 | โครงสร้างผลึกของวัสคุโลหะผสมจำรูป | 7 |
| ภาพที่ 1.5 | ปั๊มขนาดเล็กที่มีนิทินอลทำหน้าที่เป็นไคอะแฟรม [5] | 7 |
| ภาพที่ 1.6 | วาล์วขนาคเล็กที่มีนิทินอลทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมแผ่นเมมเบรน [6] | 7 |
| ภาพที่ 1.7 | วาล์วนิทินอลขนาคเล็กที่มีการเปิดปิดการใหลงากภายนอกของท่อลำเลียง | |
| | ของเหลว [7] | 8 |
| ภาพที่ 1.8 | ตะขอนิทินอลขนาดเล็ก [8] | 8 |
| ภาพที่ 1.9 | ลักษณะการขยับตัวหรือการกระคกของใมโครแอคชัวเอเตอร์ที่มีลักษณะเป็น | |
| | คานสองชั้น | 9 |
| ภาพที่ 1.10 | กรงเล็บขนาดเล็ก [9] | .10 |
| ภาพที่ 1.11 | ไมโครแอคชั่วเอเตอร์ที่มีลักษณะคล้ำยหูรูด [10] | .10 |
| ภาพที่ 1.12 | อุปกรณ์หยิบจับขนาดเล็ก [11] | .10 |
| ภาพที่ 1.13 | กระบวนการสร้างใมโครแอคชั่วเอเตอร์ในงานวิจัย Luo et al. [9] | .13 |
| ภาพที่ 1.14 | กระบวนการสร้างในงานวิจัยของ Kim et al. [12] | .13 |
| ภาพที่ 1.15 | กระบวนการสร้างไมโครแอคชั่วเอเตอร์ในงานวิจัยของ Qu et al. [13] | .14 |
| ภาพที่ 1.16 | กระบวนการสร้างไมโครแอคชั่วเอเตอร์ในงานวิจัยของ Lin et al. [14] | .14 |
| ภาพที่ 1.17 | กระบวนการสร้างไมโครแอคชั่วเอเตอร์ในงานวิจัยของ Bullen et al. [15] | .15 |
| ภาพที่ 1.18 | กระบวนการสร้างไมโครแอคชั่วเอเตอร์ในงานวิจัยของ Gill et al. [11] | .15 |
| ภาพที่ 1.19 | ลักษณะการเสียหายของไมโครแอคชั่วเอเตอร์ในงานวิจัยของ Gill et al. [11] | .16 |
| ภาพที่ 1.20 | หลักการทำงานของเทคนิคการสปัตเตอริง | .17 |
| ภาพที่ 1.21 | กระบวนการสร้างไมโครแอคชั่วเอเตอร์แบบใหม่ที่นำเสนอในงานวิจัยนี้ | .19 |
| ภาพที่ 2.1 | ลักษณะของคานที่นำมาศึกษาในโปรแกรมไฟในต์อิลิเมนต์ ANSYS | .24 |
| ภาพที่ 2.2 | แนวคิดในการหาระกระของคานจากการคำนวณ | .25 |

| | ٦ | าน้ำ |
|-------------|--|------|
| ภาพที่ 2.3 | ลักษณะการกระดกของคานที่มีทองแดงหนา 12 ไมโครเมตรในโปรแกรมไฟไนต์ | |
| | อิลิเมนต์ ANSYS | 27 |
| ภาพที่ 2.4 | ระยะกระดกของคานเมื่อทำการเปลี่ยนแปลงความหนาของทองแดงโดยมี | |
| | ความหนาของนิทินอลเท่ากับ 5 ใมโครเมตรที่อุณหภูมิต่างๆ โดยระเบียบวิธีการ | |
| | ไฟไนต์อิลิเมนต์ (เส้นทึบ) และการคำนวณ (เส้นประ) | 28 |
| ภาพที่ 2.5 | รูปแบบการนำความร้อนทางเดียว (One-dimensional heat conduction) | 29 |
| ภาพที่ 2.6 | กราฟแสดงความสัมพันธ์ระยะเวลาที่อุณหภูมิของไมโครแอคชัวเอเตอร์มีค่า | |
| | เท่ากับ 80 องศาเซลเซียสกับขนาคต่างๆของไม โครแอกชัวเอเตอร์ | 32 |
| ภาพที่ 3.1 | กระบวนการสร้าง โครงสร้างทองแคงแบบลอยตัว | 34 |
| ภาพที่ 3.2 | แผ่นสเตนเลสที่ผ่านการขัดด้วยกระดาษทรายน้ำ | 36 |
| ภาพที่ 3.3 | แผ่นแบบลวคลายที่ใช้ในกระบวนการสร้างลวคลายค้วยแสง | 37 |
| ภาพที่ 3.4 | แผ่นสเตนเลสหลังจากการสร้างแบบหล่อ | 37 |
| ภาพที่ 3.5 | งนาดขาของไมโครแอคชั่วเอเตอร์ในขั้นตอนการสร้างแบบหล่อ | 38 |
| ภาพที่ 3.6 | ใดอะแกรมของการชุบ โลหะด้วยไฟฟ้าเคมี | 39 |
| ภาพที่ 3.7 | โครงสร้างทองแคงลอยตัวที่งานวิจัยนี้ได้ทำการสร้างขึ้น | 41 |
| ภาพที่ 3.8 | ภาพตัดขวางของโครงสร้างทองแดงลอยตัวซึ่งมีความหนาเท่ากับ | |
| | 12.2±0.8 ใมโครเมตร | 41 |
| ภาพที่ 3.9 | ลักษณะของไมโครแอคชั่วเอเตอร์หลังจากทำการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าเคมีโดยจ่าย | |
| | กระแสไฟฟ้ามากกว่า 0.5 แอมแปร์ | 42 |
| ภาพที่ 3.10 | กระบวนการเคลือบผิวค้านบนของโครงสร้างทองแคงแบบลอยตัวค้วยนิทินอล | |
| | และการอบที่อุณหภูมิสูง | 43 |
| ภาพที่ 3.11 | ลักษณะการวางโครงสร้างทองแคงแบบลอยตัวบนฐาน | 44 |
| ภาพที่ 3.12 | ภาพตัดขวางของไมโครแอคชั่วเอเตอร์ โดยนิทินอลบนโครงสร้างทองแคง | |
| | ลอยตัวมีความหนาเท่ากับ 5.8±0.4 ใมโครเมตร | 45 |
| ภาพที่ 3.13 | แผนผังของเตาอบแบบหลอคควอทซ์โคยมีก๊าซอาร์กอนไหลผ่าน | 46 |
| ภาพที่ 3.14 | ลักษณะการจัควางไมโครแอคชั่วเอเตอร์ภายในแบบหล่อคอนกรีต | 47 |
| ภาพที่ 3.15 | แบบหล่อคอนกรีตและลักษณะการวางไมโครแอคชั่วเอเตอร์ภายในแบบหล่อ | |
| | คอนกรีต | 47 |
| ภาพที่ 3.16 | ลักษณะของผิวฟิล์มนิทินอลบน โครงสร้างทองแคง | 49 |

หน้า

ଶ୍

| ภาพที่ 3.17 | ผลการทคสอบของเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ของไมโครแอคชัวเอเตอร์ |
|-------------|---|
| | ที่ทำการอบ ณ อุณหภูมิต่างๆ51 |
| ภาพที่ 3.18 | พื้นผิวของฟิล์มนิทินอล |
| ภาพที่ 3.19 | ผลการทคสอบด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงานของฟิล์มนิทินอลที่ไม่ |
| | ทำการอบ54 |
| ภาพที่ 3.20 | ผลการทคสอบด้วยเครื่องวิเคราะห์ชาตุเชิงพลังงานของฟิล์มนิทินอลที่ทำการอบ |
| | ที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 30 นาที54 |
| ภาพที่ 3.21 | แสดงตำแหน่งการทดสอบด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงานที่ด้านตัดขวางของ |
| | ใมโครแอคชั่วเอเตอร์ |
| ภาพที่ 3.22 | อัตราส่วนของธาตุบนด้านตัดขวางของฟิล์มนิทินอลที่ไม่ทำการอบ ณ ตำแหน่ง |
| | ต่างๆ (ภาพที่ 3.21(ก)) |
| ภาพที่ 3.23 | อัตราส่วนของธาตุบนค้านตัดขวางของฟิล์มนิทินอลที่ทำการอบที่อุณหภูมิ 650 |
| | องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 30 นาที ณ ตำปหน่งต่างๆ (ภาพที่ 3.21(ข))56 |
| ภาพที่ 3.24 | ผลทดสอบเปรียบเทียบการถ่ายเทความร้อนของฟิล์มนิทินอลที่ไม่ทำการอบและ |
| | ทำการอบที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 30 นาที |
| ภาพที่ 3.25 | ผลการทคสอบการถ่ายเทความร้อนของฟิล์มนิทินอล |
| ภาพที่ 4.1 | ลักษณะในการจับยึดไมโครแอคชั่วเอเตอร์สำหรับในการทดสอบ |
| ภาพที่ 4.2 | อุปกรณ์ในการทคสอบการตอบสนองเชิงสถิติ |
| ภาพที่ 4.3 | ลักษณะการกระคกของไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่อุณหภูมิ 25 และ 90 |
| | องศาเซลเซียส |
| ภาพที่ 4.4 | ระยะกระคกของไมโครแอคชั่วเอเตอร์เมื่อทำการเพิ่ม-ลคอุณหภูมิด้วยเครื่อง |
| | ฮอตเพลต70 |
| ภาพที่ 4.5 | การเปรียบเทียบระยะกระดกต่ออุณหภูมิของไมโครแอคชัวเอเตอร์แบบต่างๆ71 |
| ภาพที่ 4.6 | อุปกรณ์ในการทคสอบการตอบสนองเชิงจลน์72 |
| ภาพที่ 4.7 | ระยะกระดกของไมโครแอคชัวอเตอร์เมื่อทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ |
| | ไมโครแอคชั่วเอเตอร์ที่ความถี่ 0.5 เฮิร์ทซ ด้วยขนาดของกระแสไฟฟ้ากลื่น |
| | สี่เหลี่ยมต่างๆ |
| ภาพที่ 4.8 | ลักษณะการกระดกของใมโครแอคชั่วเอเตอร์หลังจากการจ่ายกระแสไฟฟ้า |
| | 1.00 แอมแปร์ ที่ความถี่ 0.5 เฮิร์ทซ77 |

| | หน้า |
|-------------|--|
| ภาพที่ 4.9 | ระยะกระดกของไมโครแอคชั่วเอเตอร์เมื่อทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ความถี่ต่างๆ78 |
| ภาพที่ 4.10 | อุปกรณ์หยิบจับขนาดเล็กที่สร้างขึ้น80 |
| ภาพที่ 4.11 | หลักการการใช้งานอุปกรณ์หยิบจับขนาดเล็กที่สร้างขึ้น |
| ภาพที่ 4.12 | การจับเม็ด โฟม |
| ภาพที่ 4.13 | การจับชิ้นพลาสติก |

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด โดยมีแนวโน้มที่จะสร้างอุปกรณ์ที่มี งนาดที่เล็กลง เพื่อเพิ่มสมรรถนะของอุปกรณ์ให้สูงขึ้นและลดต้นทุนในการผลิต ดังนั้นเทคโนโลยี ระบบไฟฟ้าเครื่องกลจุลภาค (micro electro-mechanical system, MEMS) จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ ในการผลิตอุปกรณ์และวัสดุขนาดเล็ก เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าเครื่องกลจุลภาคสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทตามลักษณะการใช้งานคือ ไมโครเซนเซอร์ (microsensor) และไมโครแอคชัวเอเตอร์ (microactuator) ตัวอย่างอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ใช้งานในลักษณะแบบเซนเซอร์ ได้แก่ เครื่องตรวจวัด ความดันขนาดเล็ก (pressure sensor) เกรื่องตรวจวัดความเร่งขนาดเล็ก (accelerometer) เป็นต้น ส่วนอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ใช้งานในลักษณะไมโครแอคชัวเอเตอร์ ได้แก่ ปั้มขนาดเล็ก (micropump) อุปกรณ์สวิตซ์ซิ่งเชิงแสง (micromirror) วาล์วขนาดเล็ก (microvalve) มือจับขนาดเล็ก (microgripper) และอุปกรณ์รบกวนการไหลของของไหลขนาดเล็ก เป็นต้น โดยอุปกรณ์ทั้งสอง อย่างมีการนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ และอุตสาหกรรมทางการแพทย์ เป็นต้น

ในงานวิจัยนี้สนใจในไมโครแอคชัวเอเตอร์ในเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าเครื่องกลจุลภาค โดย ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ให้ความสนใจจะมีลักษณะเป็นคานสองชั้น (bimorph) และใช้หลักการ โลหะผสมจำรูป (shape memory alloy) เข้ามาประยุกต์ใช้งาน เนื่องจากมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน แต่อย่างไรก็ตามการสร้างไมโครแอคชัวเอเตอร์แบบโลหะผสมจำรูปที่มีลักษณะเป็นคานสองชั้น โดยทั่วไปมีความซับซ้อนและทำให้อาจจะเกิดการเสียหายแก่ไมโครแอคชัวเอเตอร์หรือตัวชิ้นงาน ได้ง่ายในระหว่างการผลิต ทำให้ก่าใช้จ่ายสูงและมีระยะเวลาในการสร้างนาน สาเหตุหนึ่งของความ ซับซ้อนคือกระบวนการสร้างไมโครแอคชัวเอเตอร์โดยทั่วไปคังกล่าวจำเป็นต้องสร้างบนแผ่น ซิลิกอนและต้องอาศัยการกัดชิ้นงานจากค้านล่าง (under Etching) เพื่อปล่อยไมโครแอคชัวเอเตอร์ ให้เป็นอิสระ

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงนำเสนอกระบวนการสร้างไมโครแอกชัวเอเตอร์แบบใหม่โดยไม่ใช้ แผ่นซิลิกอน เพื่อหลีกเลี่ยงกระบวนการสร้างที่ซับซ้อนและความเสียหายของตัว ไมโครแอกชัวเอเตอร์หรือชิ้นงานเอง โดยกระบวนการสร้างไมโครแอกชัวเอเตอร์แบบใหม่จะ ประกอบด้วยกระบวนการสร้างเพียง 2 ขั้นตอนหลักคือ กระบวนการสร้างโครงสร้างทองแดงแบบ ลอยตัว (freestanding) โดยนำเทกนิกการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าเกมี (electroplating technique) มา ประยุกต์ใช้ และกระบวนการเคลือบผิวด้านบนของโครงสร้างโดยนำเทคนิคการสปัตเตอริง (sputtering technique) มาประยุกต์ใช้งาน นอกจากนั้นในงานวิจัยนี้จะมีการศึกษาพารามิเตอร์ที่มีผล ต่อสมรรถนะของไมโครแอคชัวเอเตอร์แบบโลหะผสมจำรูปที่มีลักษณะเป็นคานสองชั้น ตัวอย่างเช่น คุณลักษณะจำเพาะของนิทินอล คุณสมบัติเชิงกลของไมโครแอคชัวเอเตอร์ เป็นต้น โดยข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยจะมีประโยชน์ในการสร้างไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่มีความสมรรถนะที่ดี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานเป็นไมโครแอคชัวเอเตอร์สำหรับงานวิศวกรรมในหลากหลาย รูปแบบได้

1.2 หลักการของไมโครแอคชั่วเอเตอร์

จากงานวิจัยของ Bell et al. [1] ที่ผ่านมาใด้มีการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์หลักการต่างๆ ที่มีการนำมาประยุกต์ใช้กับไมโครแอคชัวเอเตอร์ซึ่งแสดงในภาพที่ 1.1 และ ภาพที่ 1.2 โดยรูป ดังกล่าวแสดงถึงพารามิเตอร์ที่สำคัญของไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ส่งผลต่อสมรรถนะซึ่ง ประกอบด้วย 3 พารามิเตอร์หลักที่สำคัญคือ แรงกระทำสูงสุด (maximum force) ระยะขยับสูงสุด (maximum displacement) และความถี่สูงสุดในการใช้งาน (maximum frequency) จากรูปทั้งสอง สามารถสรุปค่าเฉลี่ยของแรงกระทำ ค่าเฉลี่ยของระยะขยับ และค่าเฉลี่ยของความถี่ในการใช้งาน ของไมโครแอคชัวเอเตอร์แต่ละหลักการได้ดังตารางที่ 1.1

ในการใช้งานทั่วไปไมโครแอคชัวเอเตอร์ควรจะมีสมรรถนะในการทำงานดังนี้คือ มีระยะ การขยับหรือระยะกระดกที่สูงและมีความถี่ในการใช้งานที่สูง เพื่อที่จะทำให้ไมโครแอคชัวเอเตอร์ นี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งจากตารางที่ 1.1 จะเห็นได้ว่า มีหลักการทั้งหมด 5 หลักการที่มีแนวโน้มที่ดีในสมรรถนะที่กล่าวถึง ได้แก่หลักการดังนี้กือ Piezoelectric expansion, Shape memory alloy, Fluid expansion, Electromagnetic และ External magnetic field แต่อย่างไรก็ ตามแต่ละหลักการยังมีข้อจำกัดในหลายๆด้าน ตัวอย่างเช่น ในหลักการ Electromagnetic จำเป็นต้องมีการติดตั้งแม่เหล็กลงไปทำให้ไม่สามารถสร้างอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กได้ ในหลักการ Piezoelectric จำเป็นต้องใช้ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่สูง ในหลักการ Fluid expansion ไม่สามารถใช้ใน สภาวะอุณหภูมิที่สูงได้ เนื่องจากจะทำให้ของเหลวในระบบเกิดการเปลี่ยนสถานะกลายเป็นก๊าซ สำหรับหลักการ External field ก็ไม่สามารถนำไปใช้งานในสภาวะที่อุณภูมิสูงได้เพราะจะทำให้ สนามแม่เหล็กเสื่อมลงไป ดังนั้นหลักการที่เหมาะสำหรับในการสร้างไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่มี สมรรถนะที่สูงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบคือ Shape memory alloy หรือหลักการโลหะผสมจำรูป



ภาพที่ 1.1 กราฟระหว่างแรงกระทำสูงสุดกับระยะขยับสูงสุดของแอกชัวเอเตอร์ [1]



ภาพที่ 1.2 กราฟระหว่างความถี่สูงสุดในการใช้งานและระยะขยับสูงสุดของแอกชัวเอเตอร์ [1]

| Principle | Displacement (mm) | Frequency (Hz) | Force (N) | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------|-----------|--|--|
| Electrostatic | | | | | |
| - Scratch drive | 0.7 | 0.225 | 0.002 | | |
| - Impact actuator | 3 | 0.003 | 0.00005 | | |
| - Electrostatic relay | 0.007 | $4x10^{5}$ | 0.00005 | | |
| Piezoelectric | | | | | |
| - Piezoelectric bimorph | 0.0015 | $4x10^{5}$ | 0.00004 | | |
| - Piezoelectric expansion | 0.015 | 8×10^3 | 0.001 | | |
| Thermal | Thermal | | | | |
| - Thermal bimorph | 0.015 | 900 | 0.00007 | | |
| - Solid expansion | 0.001 | 5×10^5 | 0.006 | | |
| - Shape memory alloy | 0.05 | 54 | 0.7 | | |
| - Fluid expansion | 0.09 | 50 | 0.5 | | |
| - State change | 0.01 | 63 | 0.65 | | |
| Magnetic | | | | | |
| - Electromagnetic | 0.06 | 100 | 0.00003 | | |
| - External field | 0.3 | 5×10^3 | 0.0001 | | |

ตารางที่ 1.1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของพารามิเตอร์ที่สำคัญของหลักการต่างๆที่นำมาประยุกต์ใช้กับ ใมโครแอกชัวเอเตอร์

จากการเปรียบเทียบข้างต้นจะเห็นได้ว่าหลักการโลหะผสมจำรูปเป็นหลักการหนึ่งใน หลายๆหลักการที่มีความเหมาะสมสำหรับนำมาประยุกต์ใช้กับไมโครแอคชัวเอเตอร์ เนื่องจาก หลักการโลหะผสมจำรูปจะมีแอคชัวเอเตอร์ที่กระทัดรัดเนื่องจากไม่ต้องมีอุปกรณ์ควบคุมจำนวน มากโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนทำให้สะควกต่อการประกอบอุปกรณ์และการควบคุมในการใช้งานทำ ได้ง่ายในทางตรงกันข้ามหลักการโลหะผสมจำรูปก็มีข้อเสียบางประการเช่น ประสิทธิภาพ ทางด้านพลังงานที่ต่ำ (<10%) เนื่องจากพลังงานส่วนใหญ่ต้องเปลี่ยนรูปไปอยู่ในรูปของความร้อน เพื่อใช้ในการเปลี่ยนเฟสของวัสดุ ความไวในการตอบสนองที่ก่อนข้างต่ำและพฤติกรรมของวัสดุที่ ไม่เป็นเชิงเส้น แต่อย่างไรก็ตามหลักการโลหะผสมจำรูปก็ยังมีข้อดีกว่าหลักการอื่นๆคือ อัตราส่วน ระหว่างกำลังงานต่อน้ำหนักอยู่ในระดับสูง [2] จึงทำให้หลักการโลหะผสมจำรูปเป็นทางเลือกที่ดี สำหรับนำมาประยุกต์ใช้งานที่ต้องการไมโครแอคชั่วเอเตอร์ขนาดเล็กแต่มีกำลังงานสูงและยัง สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นไมโครแอคชั่วเอเตอร์ในรูปแบบต่างๆได้มากมาย

1.3 หลักการโลหะผสมจำรูปและการประยุกต่ใช้งานที่ผ่านมา

วัสดุโลหะผสมจำรูปเป็นวัสดุที่มีการเปลี่ยนโครงสร้างได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ที่ อุณหภูมิต่ำ เฟสของวัสดุโลหะผสมจำรูปจะเป็นมาร์เทนไซต์ (martensite) มีค่ามอดูลัสของยัง (young's modulus) และความเค้น (tensile stress) ในวัสดุก่อนข้างต่ำ ดังแสดงในภาพที่ 1.3 ซึ่งทำให้ วัสดุโลหะผสมจำรูปในเฟสมาร์เทนไซต์มีลักษณะอ่อนนุ่มและเหนียวสามารถออกแรงกระทำให้ บิดงอเป็นรูปร่างต่างๆได้ง่าย และหากวัสดุโลหะผสมจำรูปถูกทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นจนสูงกว่า อุณหภูมิเปลี่ยนรูป (transformation temperature) จะมีการเปลี่ยนแปลงเฟสจากมาร์เทนไซต์เป็น ออสเทนไนต์ (austenite) ซึ่งทำให้วัสดุมีความแข็งแรงมากขึ้น โดยจะมีค่ามอดูลัสของยังและ ความเค้นในวัสดุเพิ่มขึ้น [3][4]

หากพิจารณาลักษณะของโครงสร้างจุลภาค (microstructure) หรือโครงสร้างผลึก (crystal structure) ของวัสดุโลหะผสมจำรูป จากภาพที่ 1.4 จะเห็นได้ว่า โครงสร้างของวัสดุโลหะผสมจำรูป ก่อนการเปลี่ยนแปลงรูปร่างจะเป็นโครงสร้างแบบทวินด์มาร์เทนไซต์ (twinned martensite) เมื่อทำ การดัดแปลงรูปร่างหรือมีแรงกระทำกับวัสดุโลหะผสมจำรูป นอกจากลักษณะของ วัสดุโลหะผสมจำรูปที่ปรากฏจะเปลี่ยนไปแล้ว โครงสร้างภายในจะเปลี่ยนไปเป็นมาร์เทนไซต์ที่ถูก เปลี่ยนแปลงรูปร่าง (deformed martensite) แต่เมื่อทำให้วัสดุโลหะผสมจำรูปร้อนขึ้นจนอุณหภูมิสูง ถึงอุณหภูมิเปลี่ยนรูป โครงสร้างของวัสดุโลหะผสมจำรูปจะเปลี่ยนไปเป็นออสเทนไนต์ ซึ่งจะ ส่งผลให้รูปร่างของวัสดุโลหะผสมจำรูปมีลักษณะเหมือนรูปร่างเดิมก่อนที่จะถูกแรงภายนอกมา กระทำ เมื่อปล่อยให้วัสดุโลหะผสมจำรูปเย็นลง โครงสร้างของวัสดุโลหะผสมจำรูปจะกลับไปเป็น ทวินด์มาร์เทนไซต์อีกครั้งแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเลย

วัสดุโลหะผสมจำรูปนี้มีหลายชนิด เช่น Cu-Zn-Al, Au-Cd, Ni-Ti-Cu และโลหะผสมกลุ่ม เหล็กอีกหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Ni-Ti หรือนิทินอลเป็นวัสดุโลหะผสมระหว่างนิกเกิลกับ ใททาเนียมซึ่งมีคุณสมบัติที่เด่นและมีการใช้งานกันแพร่หลายกว่าวัสดุโลหะผสมจำรูปชนิดอื่น เช่น อุณหภูมิในการใช้งานที่ไม่สูงนัก มีระยะขยับที่สูง มีแรงกระทำใช้งานที่สูง ทนต่อการกัดกร่อนและ มีความต้านทานทางไฟฟ้าที่สูง ซึ่งนิทินอลในหลักการของโลหะผสมจำรูปนี้สามารถนำไป ประยุกต์ใช้เป็นไมโครแอคชัวเอเคอร์ได้หลากหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น ปั๊มขนาดเล็ก [5] ที่มี นิทินอลทำหน้าที่เป็นไดอะแฟรมเพื่อทำการดูดและส่งของไหลตามที่ต้องการ ดังแสดงในภาพที่ 1.5 โดยปั๊มขนาดเล็กแบบโลหะผสมจำรูปนี้จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในระบบลำเลียงยา อีกตัวอย่างหนึ่งคือวาล์วขนาดเล็ก [6] ที่มีนิทินอลทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมแผ่นเมมเบรนโดยนำ คุณสมบัติของนิทินอลไปประยุกต์ในการเปิด – ปิดของวาล์ว ดังแสดงดังภาพที่ 1.6 โดยเมื่อเพิ่ม ความร้อนให้นิทินอลจะทำให้นิทินอลมีอุณหภูมิสูงขึ้น นิทินอลจะหดตัวทำให้แผ่นเมมเบรนขยับ ขึ้นเป็นการเปิดวาล์วและเมื่ออุณหภูมิของนิทินอลเย็นลง นิทินอลจะยึดกลับที่ตำแหน่งเดิมทำให้ แผ่นเมมเบรนขยับลงเป็นการปิดวาล์ว วาล์วยังมีหลายรูปร่างตัวอย่างหนึ่งคือวาล์วที่ใช้สำหรับท่อ ของเหลวขนาดเล็ก [7] ดังแสดงในภาพที่ 1.7 โดยแผ่นนิทินอลขนาดเล็กจะทำหน้าที่เป็นเหมือน วาล์วในการเปิด - ปิดการลำเลียงของสารแต่มีการควบคุมโดยการหนีบสายยางลำเลียงของเหลว นอกจากนั้นไมโครแอคชัวเอเตอร์แบบโลหะผสมจำรูปที่ใช้นิทินอลกีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ หลายรูปแบบ เช่น ตะขอนิทินอลขนาดเล็ก [8] แสดงในภาพที่ 1.8 เป็นการสร้าง ใมโครแอคชัวเอเตอร์แบบโครงสร้างสองชั้นระหว่างนิทินอลกับไททาเนียมที่มีรูปแบบเป็นตะขอ โดยมีหลักการใช้งานคือที่อุณหภูมิต่ำตะขอจะมีรูปร่างคล้ายด้วซี เมื่อเพิ่มอุณหภูมิตะขอนิทินอลจะ หดกลับและทำการจับยึดสิ่งที่ต้องการได้ สำหรับโครงสร้างแบบกานสองชั้นนี้จะทำให้ ไมโครแอคชัวเอเตอร์มีสมรรถนะสูงขึ้นและออกแบบให้มีความซับซ้อนมากขึ้นได้ซึ่งจะมี ความเหมาะสมกับงานทางวิศวกรรมในรูปแบบหลากหลายมากขึ้น





ภาพที่ 1.4 โครงสร้างผลึกของวัสดุโลหะผสมจำรูป



ภาพที่ 1.5 ปั๊มขนาคเล็กที่มีนิทินอลทำหน้าที่เป็นไคอะแฟรม [5]



ภาพที่ 1.6 วาล์วขนาคเล็กที่มีนิทินอลทำหน้าที่เป็นตัวกวบกุมแผ่นเมมเบรน [6]



ภาพที่ 1.7 วาล์วนิทินอลขนาคเล็กที่มีการเปิดปิดการใหลงากภายนอกของท่อลำเลียงของเหลว [7]



ภาพที่ 1.8 ตะงอนิทินอลงนาคเล็ก [8]

1.4 ปัญหาของการสร้างไมโครแอคชั่วเอเตอร์แบบคานสองชั้น

ใมโครแอคชัวเอเตอร์ที่มีลักษณะเป็นคานสองชั้นนี้จะประกอบด้วยวัสดุสองชนิดที่ แตกต่างกันนำมาซ้อนทับกันอยู่โดยวัสดุสองชนิดนี้มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน (coefficient of thermal expansion, CTE) ไม่เท่ากัน โดยมีหลักการการใช้งานดังนี้คือ เมื่อทำการเพิ่ม อุณหภูมิให้กับไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่มีลักษณะเป็นคานสองชั้นนี้ ไมโครแอคชัวเอเตอร์จะเกิดการ ขยับหรือเกิดการกระดกโดยมีทิศทางในการขยับเข้าหาวัสดุที่มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวที่ต่ำกว่า เมื่อทำการเพิ่มอุณหภูมิ วัสดุทั้งสองชนิดจะขยายตัวแต่วัสดุที่มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวที่มากกว่า จะมีการขยายตัวมากกว่าอีกวัสดุหนึ่ง จึงทำให้ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่มีลักษณะเป็นคานสองชั้นเกิด การขยับตัวหรือการกระดกขึ้นไปในทิศทางที่วัสดุที่มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวน้อยกว่า ตัวอย่างเช่น ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่มีลักษณะเป็นคานสองชั้นที่ประกอบด้วยทองแดงกับนิกเกิล ซ้อนทับกันอยู่ โดยที่ทองแดงและนิกเกิลมีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเท่ากับ 16.5x10⁻⁶ °C⁻¹ และ 13.1x10⁻⁶ °C⁻¹ ตามลำดับ เมื่อทำการเพิ่มอุณหภูมิให้กับไมโครแอคชัวเอเตอร์แล้วไมโครแอคชัวเอเตอร์ จะเกิดการขยับหรือกระดกขึ้นโดยมีทิศทางในการขยับเข้าหานิกเกิลที่มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัว น้อยกว่าดังแสดงการกระดกของไมโครแอคชัวเอเตอร์แบบคานสองชั้นในภาพที่ 1.9 สำหรับคาน สองชั้นจะประกอบด้วยวัสดุโลหะผสมจำรูปประกอบติดกับวัสดุอีกชนิดหนึ่งซึ่งสามารถเลือกวัสดุ ได้หลากหลายตามการใช้งานที่ต้องการเช่น DLC PDMS และ polyimide เป็นด้น

ไมโครแอคชัวเอเตอร์แบบโลหะผสมจำรูปที่มีลักษณะเป็นคานสองชั้นนี้เป็นอีกประเภท หนึ่งที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในหลากหลายรูปแบบ เนื่องจากไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่มีลักษณะเป็น คานสองชั้นจะสามารถควบคุมทิศทางในการขยับได้แน่นอน มีแรงกระทำในการใช้งานที่สูงและ ยังถือว่าเป็นรูปแบบของไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ไม่ซับซ้อน ตัวอย่างเช่น กรงเล็บขนาดเล็ก (microcages) [9] ดังแสดงในภาพที่ 1.10 ซึ่งประกอบด้วย DLC กับนิทินอลเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ใน การจับวัสดุขนาดเล็กๆ ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่มีลักษณะคล้ายหูรูด (sphincter actuator) [10] ดังแสดงในภาพที่ 1.11 นำมาประยุกต์ใช้งานในทางการแพทย์ ไมโครแอคชัวเอเตอร์ในงานวิจัยนี้มี ลักษณะเป็นคานสองชั้นซึ่งประกอบด้วย PDMS กับวัสดุโลหะผสมจำรูป หรืออุปกรณ์หยิบจับ ขนาดเล็ก (microwrapper) [11] ดังแสดงในภาพที่ 1.12 ไมโครแอคชัวเอเตอร์ในงานวิจัยนี้มีลักษณะ เป็นกานสองชั้นที่ประกอบด้วย polyimideกับนิทินอล โดยจะนำมาประยุกต์ใช้งานในทาง ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ในการหยิบจับวัสดุทางชีวภาพขนาดเล็กๆ เป็นด้น



ภาพที่ 1.9 ลักษณะการขยับตัวหรือการกระดกของไมโครแอกชัวเอเตอร์ที่มีลักษณะเป็นคานสองชั้น (ก) รูปร่างที่อุณหภูมิต่ำ (ข) รูปร่างที่อุณหภูมิสูง



ภาพที่ 1.10 กรงเลี้บขนาคเล็ก [9]





(ก) (ป)
 ภาพที่ 1.11 ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่มีลักษณะคล้ายหูรูด [10]
 (ก) รูปร่างที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส (ป) รูปร่างที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส



ภาพที่ 1.12 อุปกรณ์หยิบจับงนาคเล็ก [11]

แต่อย่างไรก็ตามจากงานวิจัยที่ผ่านมา กระบวนการสร้างไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่มีลักษณะ กานสองชั้นจะก่อนข้างมีกระบวนการสร้างที่ชับซ้อน ซึ่งจะเห็นได้จากในงานวิจัยต่างๆ ด้วอย่างเช่น กระบวนการสร้างไมโครแอคชัวเอเตอร์ในงานวิจัย Luo et al. [9] เป็นการสร้าง ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่มีลักษณะเป็นคานสองชั้นที่ประกอบด้วย DLC (Diamond like Carbon) กับ นิกเกิล เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นมือจับขนาดเล็ก ดังแสดงในภาพที่ 1.13 โดยเริ่มจากการปลูกฟิล์ม DLC ลงบนซิลิกอนแล้วจึงทำการปลูกฟิล์มทองแดงลงบน DLC อีกครั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การยึดเกาะบนผิวฟิล์ม DLC หลังจากนั้นทำกระบวนการสร้างลวดลายด้วยแสง (photolithography) และปลูกฟิล์มนิกเกิลตามลวดลายที่สร้างขึ้น จากนั้นทำการกัดชิ้นงานแบบแห้ง (dry etching) ด้วย ออกซิเจนพลาสม่า ในขั้นตอนสุดท้ายจึงกัดชิ้นงานจากด้านล่างเพื่อทำให้ชิ้นงานหลุดออกมา ซึ่ง จากกระบวนการสร้างไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่มีลักษณะเป็นกานสองชั้นในงานวิจัยของ Luo et al. จะเห็นได้ว่า กระบวนการสร้างมีความซับซ้อน โดยที่มีการเพิ่มขั้นตอนในการปลูกฟิล์มทองแดง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะของ DLC อีกทั้งยังมีขั้นตอนอีกหลายขั้นตอนในการสร้างซึ่ง อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นงานหรือไมโครแอกชัวเอเตอร์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการ กัดชิ้นงานจากด้านล่างอาจจะส่งผลทำให้ชิ้นงานเกิดการหักหรือเสียหายในระหว่างกระบวนการ สร้างด้วย

อีกตัวอย่างหนึ่งเป็นกระบวนการสร้างในงานวิจัยของ Kim et al. [12] สำหรับ ใมโครแอคชัวเอเตอร์ที่มีลักษณะเป็นคานสองชั้นที่ประกอบด้วยนิกเกิลและซิลิกอนในไตรด์เพื่อ ประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์สวิตซ์ซิ่งเชิงแสง จากภาพที่ 1.14 เป็นกระบวนการสร้างไมโครแอคชัวเอเตอร์ ในงานวิจัยนี้ โดยในขั้นตอนแรกจะทำการปลูกฟิล์มซิลิกอนไดออกไซด์ แล้วทำกระบวนการสร้าง ลวดลายด้วยแสงและกัดซิลิกอนไดออกไซด์ตามลวดลายที่สร้างขึ้น หลังจากนั้นทำการปลูกฟิล์ม นิกเกิลและทำการ lift off ตามลำดับ ต่อจากนั้นทำการปลูกชั้นฟิล์มซิลิกอนในไตรด์และทำ กระบวนการสร้างลวดลายด้วยแสงและกัดชิ้นงานด้วยเครื่องกัดชิ้นงานแบบรีแอกทีฟไอออนเอชชิ่ง (reactive ion etching, RIE) หลังจากนั้นทำกระบวนการสร้างลวดลายด้วยแสง ทำการปลูกฟิล์ม นิกเกิลและทำการ lift off ตามลำดับ ในขั้นตอนสุดท้ายทำการกัดชิ้นงานด้วย MERIE (magnetically enhanced reactive ion etching) และ XeF₂ ตามลำดับเพื่อให้ได้ชิ้นงานออกมา ซึ่งจากกระบวนการ สร้างไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่มีลักษณะเป็นคานสองชั้นในงานวิจัยของ Kim et al. จะเห็นได้ว่า กระบวนการสร้างจะมีความยุ่งยากและซับซ้อนเป็นอย่างมาก มีกระบวนการสร้างลวดลายด้วยแสง และต้องทำการกัดชิ้นงานในหลายขั้นตอน อีกทั้งยังใช้เวลานานในการสร้างอีกด้วย

กระบวนการสร้างไมโครแอคชั่วเอเตอร์ในงานวิจัยของ Qu et al. [13] และ Lin et al. [14] แสดงดังภาพที่ 1.15 และ ภาพที่ 1.16 ตามลำดับ เป็นการสร้างไมโครแอคชั่วเอเตอร์ที่ลักณะเป็น คานสองชั้น ซึ่งในกระบวนการสร้างของทั้งสองงานวิจัยนี้จะใช้แผ่นซิลิกอนเป็นฐานในการสร้าง และในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการสร้างจะทำการกำจัดชั้นรองพื้นในการสร้าง (sacrificial layer) ออก ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เสี่ยงทำให้เกิดการเสียหายแก่ไมโกรแอกชัวเอเตอร์ที่สร้างขึ้น เนื่องจาก การจำกัดชั้นรองพื้นในการสร้างจำเป็นต้องใช้วิธีการกัดชิ้นงานจากด้านล่าง สารละลายที่ใช้อาจไป กัดชิ้นงานส่วนอื่นจนทำให้เกิดการเสียหายได้

ส่วนในกระบวนการสร้างไมโครแอคชัวเอเตอร์ในงานวิจัยของ Bullen et al. [15] แสดง ดังภาพที่ 1.17 เป็นกระบวนการสร้างไมโครแอคชัวเอเตอร์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานเป็น ส่วนประกอบของเซนเซอร์ โดยในขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างจะต้องกัดขึ้นงานด้วยวิธีการกัด แบบ EDP จากด้านหน้าของแผ่นซิลิกอน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เสี่ยงต่อการเกิดการเสียหายต่อชิ้นงานได้ เนื่องจากสารละลายที่ใช้ในการกัดชิ้นงานอาจจะเข้าไปกัดชิ้นงานโดยตรงทำให้ชิ้นงานเกิดการ เสียหายหรือพังลงมาได้ นอกจากนี้ในกระบวนการสร้างไมโครแอคชัวเอเตอร์ในงานวิจัยของ Gill et al. [11] แสดงดังภาพที่ 1.18 เป็นกระบวนการสร้างไมโครแอคชัวเอเตอร์ในงานวิจัยของ ตัวเกิดการเสียหายต่อชิ้นงานจากขั้นตอนที่สอง ในกระบวนการสร้างไมโกรแอคชัวเอเตอร์เพื่อนำไป ประยุกต์ใช้งานเป็นมือจับขนาดเล็ก ในกระบวนการสร้างของงานวิจัยนี้มีขั้นตอนที่สอง นี้เป็น การกัดชิ้นงานด้วยสาระลาย (wet etching) เพื่อทำการกำจัดชั้นรองพื้น แต่เนื่องจากบริเวณขั้นบันได ระหว่างชั้นรองพื้นกับ นิทินอลมีรูเลีกๆอยู่ จึงทำให้สารละลายที่ใช้ในการกัดชิ้นงานใหญ่ขึ้นและ ทำให้นิทินอลเกิดการพังลงในที่สุด ดังแสดงในภาพที่ 1.19 เป็นด้น



ภาพที่ 1.13 กระบวนการสร้างไมโครแอคชัวเอเตอร์ในงานวิจัย Luo et al. [9]



ภาพที่ 1.14 กระบวนการสร้างในงานวิจัยของ Kim et al. [12]



ภาพที่ 1.15 กระบวนการสร้างไมโครแอคชัวเอเตอร์ในงานวิจัยของ Qu et al. [13]



ภาพที่ 1.16 กระบวนการสร้างไมโครแอคชัวเอเตอร์ในงานวิจัยของ Lin et al. [14]



ภาพที่ 1.17 กระบวนการสร้างไมโครแอคชัวเอเตอร์ในงานวิจัยของ Bullen et al. [15]





ภาพที่ 1.19 ลักษณะการเสียหายของใมโครแอคชัวเอเตอร์ในงานวิจัยของ Gill et al. [11]

1.5 กระบวนการสร้างไมโครแอคชั่วเอเตอร์ที่ใช้นิทินอลเป็นส่วนประกอบ

นิทินอลเป็นวัสดุโลหะผสมระหว่างนิกเกิลกับไททาเนียมที่มีคุณลักษณะจำเพาะที่ดีใน หลายด้านได้แก่ มีคุณสมบัติการเปลี่ยนรูปและคืนรูปได้ (shape memory alloy effect, SMA effect) และสภาพยึดหยุ่นยิ่งยวด (superelasticity) นอกจากนี้นิทินอลยังมีคุณสมบัติที่เค่นอีกมากมายที่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายตามที่ได้กล่าวไปแล้ว ตัวอย่างเช่น มีอุณหภูมิในการใช้ งานที่ไม่สูงนัก มีระยะขยับที่สูง มีแรงกระทำใช้งานที่สูง ทนต่อการกัดกร่อนและมีความด้านทาน ทางไฟฟ้าที่สูง สำหรับการสร้างฟิล์มนิทินอลเพื่อใช้งานเป็นไมโครแอคชัวเอเตอร์ จะประกอบด้วย สองกระบวนการหลักเพื่อทำให้ฟิล์มนิทินอลทีคุณสมบัติตามที่ต้องการคือ กระบวนการเคลือบผิว ด้วยนิทินอล (sputtering deposition) และกระบวนการอบหลังการเคลือบผิวด้วยนิทินอล (post-sputtering annealing) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.5.1 กระบวนการเคลือบผิวด้วยนิทินอล

การเคลือบผิวด้วยนิทินอลสามารถทำได้หลายวิธี เช่น เทคนิคการสปัตเตอริง เทคนิคการยิง ด้วยเลเซอร์ (laser ablation) เทคนิคการปลูกฟิล์มด้วยลำไอออน (ion beam deposition) การเคลือบผิวด้วยพลาสมาอาร์กอน (arc plasma ion plating) เทคนิคการสเปรย์พลาสมา (spray plasma) เทคนิคการระเหย (flash evaporation) เป็นต้น โดยที่เทคนิคเหล่านี้มีอุปสรรคในการสร้าง เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ความหนาและองค์ประกอบของฟิล์มไม่สม่ำเสมอ ใช้ระยะเวลานานใน การปลูกฟิล์มเนื่องจากมีอัตราการปลูกฟิล์มที่ต่ำ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามเทคนิคเหล่านี้ก็ยังเป็นที่ นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งในงายวิจัยนี้จะใช้เทคนิคการสปัตเตอริงในการเคลือบผิวด้วยนิทินอล โดยเทคนิคสปัตเตอริงจำเป็นต้องทำภายใต้ความคันสูญญากาศที่ต่ำมากๆ และพลังงานที่สูงเพื่อทำ ให้ประจุของอาร์กอนเข้าไปชนกับ target นิทินอลจนทำให้อนุภาคของนิทินอลหลุดออกและ เคลื่อนที่ไปตามทิศทางสนามไฟฟ้าและเคลือบอยู่กับผิวชิ้นงาน ภาพที่ 1.20 แสดงไดอะแกรมของ การทำงานของเทคนิคสปัตเตอริง สำหรับเงื่อนไขในการเคลือบผิวด้วยนิทินอลด้วยเทคนิค การสปัตเตอริงจะกล่าวถึงในขั้นตอนกระบวนการสร้างต่อไป แต่อย่างไรก็ตามฟิล์มนิทินอลที่ เคลือบอยู่บนผิวชิ้นงานนี้จะมีโครงสร้างอมอฟัสซึ่งเป็นโครงสร้างที่ไม่มีคุณสมบัติของวัสคุโลหะ ผสมจำรูปอยู่ จึงจำเป็นต้องทำกระบวนการอบเพื่อทำให้โครงสร้างของฟิล์มนิทินอลเปลี่ยนไปเป็น โครงสร้างผลึกซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีคุณสมบัติของวัสคุโลหะผสมจำรูปปรากฏอยู่



1.5.2 กระบวนการอบหลังจากเคลือบผิวด้วยนิทินอล

กระบวนการอบนิทินอลเป็นกระบวนการที่สำคัญซึ่งเป็นกระบวนการอบที่อุณหภูมิสูงทำ ให้นิทินอลเปลี่ยนโครงสร้างจากอมอฟัส (amorphous) เป็นโครงสร้างผลึก (crystalline structure) โดยทั่วไปกระบวนการอบนิทินอลจะอบที่อุณหภูมิสูงกว่า 450 องศาเซลเซียส เพราะจะทำให้ กุณสมบัติการเปลี่ยนรูปและคืนรูปได้ (shape memory alloy effect, SMA effect) และสภาพยืดหยุ่น ยิ่งยวด (superelasticity) ปรากฏขึ้น กระบวนการอบสามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น อบในเตา ภายใต้สูญญากาศที่สูง (high vacuum) [5] [16] [17] อบโดยเทคนิคการยิงเลเซอร์ [18] และอบในเตา อบแบบหลอดควอทซ์โดยมีก๊าซไหลผ่าน [7] ซึ่งจากงานวิจัยที่ผ่านมาระยะเวลาและอุณหภูมิในการ อบมีความแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ในงานวิจัยของ Chung และ Chan [16] จะทำการอบฟิล์ม นิทินอล (ความหนา 5 ไมโครเมตร) ในเตาอบสูญญากาศภายใต้ความดัน 2x10⁻⁶ มิลลิบาร์และ อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 30 นาที ในงานวิจัยของ Fu et al. [17] ทำการอบชิ้นงานที่มี ลักษณะเป็นคานสองชั้นซึ่งประกอบด้วย DLC กับฟิล์มนิทินอล (ความหนา 800 นาโนเมตร) ในเตาอบสูญญากาศภายใต้อุณหภูมิ 480 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 30 นาที ส่วนในงานวิจัยของ Makino et al. [5] ทำการอบฟิล์มนิทินอล (ความหนา 6 ไมโครเมตร) ในเตาอบสูญญากาศภายใต้ อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เป็นด้น และจากงานวิจัยที่ผ่านมากล่าวถึง แฟกเตอร์หลักที่มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะจำเพาะของนิทินอล คือ ความเป็นโครงสร้างผลึกของ นิทินอล อัตราส่วนระหว่างไททาเนียมกับนิกเกิล (Ti:Ni ratio) ของนิทินอล และช่วงอุณหภูมิใน การเปลี่ยนรูปร่าง (transformation temperature) เป็นด้น ซึ่งแฟกเตอร์คังกล่าวสามารถควบคุมจาก อุณหภูมิและระยะเวลาในการอบฟิล์มนิทินอลได้

1.6 แนวทางในการดำเนินงานวิจัย

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะทำการพัฒนากระบวนการสร้างไมโครแอคชัวเตอร์แบบโลหะ ผสมจำรูปที่มีลักษณะเป็นคานสองชั้นด้วยวิธีการที่ง่ายไม่ซับซ้อนโดยไม่ใช้ซิลิกอน วัสดุที่ใช้เป็น วัสดุโลหะผสมจำรูปคือ นิทินอลและทองแดง เนื่องจากทองแดงเป็นโลหะที่มีราคาถูก มีคุณสมบัติ เชิงกลที่ดีและสามารถใช้กระบวนการผลิตได้หลากหลายวิธี หลังจากนั้นจะทำการศึกษา พารามิเตอร์ของไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ส่งผลต่อสมรรถนะของไมโครแอคชัวเอเตอร์เพื่อหารูปร่าง และขนาดที่เหมาะสำหรับในการทำงานวิจัยนี้ แล้วจึงนำแนวคิดจากการศึกษาพารามิเตอร์ของ ไมโครแอคชัวเอเตอร์ดังกล่าวมาทำการสร้างไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่มีลักษณะเป็นคานสองชั้นด้วย กระบวนการสร้างแบบใหม่โดยไม่ใช้แผ่นซิลิกอน เพื่อหลีกเลี่ยงกระบวนการสร้างที่ซับซ้อนและ การเกิดความเสียหายของไมโครแอคชัวเอเตอร์หรือชิ้นงานเอง ซึ่งในกระบวนการสร้างแบบใหม่นี้ ประกอบด้วยกระบวนการในการสร้างเพียงสองขั้นตอนหลักคือ กระบวนการสร้างโครงสร้าง ทองแดงแบบลอยตัวและกระบวนการเกลือบผิวด้านบนของโครงสร้างทองแดงแบบลอยตัวด้วย นิทินอลโดยมีรายละเอียดของกระบวนการสร้างไมโครแอกชัวเอเตอร์ดังภาพที่ 1.21

นอกจากนี้ในงานวิจัยยังทำการศึกษาพารามิเตอร์ที่สำคัญที่มีผลต่อคุณสมบัติของนิทินอล ในขั้นตอนการอบไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่มีนิทินอลเป็นส่วนประกอบโดยจะทำการเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิสำหรับการอบในเตาอบแบบหลอดควอทซ์โดยมีก๊าซอาร์กอนไหลผ่านเพื่อทำความเข้าใจ พารามิเตอร์ของการอบฟิล์มนิทินอลในเตาอบแบบหลอดควอทซ์ที่ทำให้ได้คุณลักษณะจำเพาะของ นิทินอลที่ดี พร้อมทั้งทำการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคต่างๆ คือ เทคนิคการเลี้บวเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray diffraction, XRD) เทคนิคการวิเคราะห์ชาตุเชิงพลังงาน (Energy dispersive spectroscopy, EDS) และเทคนิคการวัดการถ่ายเทความร้อน (Differential scanning calorimetry, DSC) อีกทั้งยัง ทำการศึกษาอิทธิพลของการดัดชิ้นงาน (pre-stressing) ระหว่างการอบต่อคุณสมบัติเชิงกลของ ใมโครแอคชั่วเอเตอร์ โดยจะทำการวิเคราะห์ด้วยวิธีการวัดระยะกระดก (deflection) ทั้งแบบ สตาติกส์และแบบไดนามิกส์



Sputtering Ni-Ti thin film and crystallization

ภาพที่ 1.21 กระบวนการสร้างไมโครแอคชัวเอเตอร์แบบใหม่ที่นำเสนอในงานวิจัยนี้

1.7 วัตถุประสงค์

พัฒนากระบวนการสร้างแอคชั่วเอเตอร์แบบโลหะผสมจำรูปที่มีลักษณะเป็นคานสองชั้น โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าเคมีและเทคนิคสปัตเตอริง

1.8 ขอบเขตงานวิจัย

 ศึกษาพารามิเตอร์เกี่ยวกับรูปร่างของใมโครแอคชัวเอเตอร์ที่มีผลต่อสมรรถนะของ ใมโครแอคชัวเอเตอร์แบบโลหะผสมจำรูปที่มีลักษณะเป็นคานสองชั้น ออกแบบ กระบวนการสร้างและสร้างใมโครแอคชัวเอเตอร์แบบโลหะผสมจำรูปที่มีลักษณะเป็น คานสองชั้นโดยใช้เทคนิคการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าเคมีและเทคนิคสปัตเตอริงมาประยุกต์ใช้ งาน

- ศึกษาอุณหภูมิของการอบที่มีผลต่อคุณสมบัติของวัสดุโลหะผสมจำรูปที่สร้างขึ้นด้วย เทคนิคต่างๆ ได้แก่ คุณสมบัติความเป็นโครงสร้างผลึก อัตราส่วนระหว่างไททาเนียมกับ นิกเกิลและช่วงอุณหภูมิในการเปลี่ยนรูปร่าง เป็นต้น
- ทดสอบสมรรถนะของไมโครแอคชั่วเอเตอร์แบบโลหะผสมจำรูปที่มีลักษณะเป็นคาน สองชั้นที่สร้างขึ้น ได้แก่ ระยะกระดกด้วยการเพิ่มอุณหภูมิให้กับไมโครแอคชั่วเอเตอร์ โดยตรงและด้วยการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่มีรูปแบบสี่เหลี่ยมให้กับไมโครแอคชัวเอเตอร์

1.9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

กระบวนการสร้างไมโครแอคชัวเอเตอร์แบบใหม่ที่นำเทคนิคการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าเคมี และเทคนิคการสปัตเตอริงที่สามารถลดความซับซ้อนของขั้นตอนในกระบวนการผลิตและลด ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการสร้าง นอกจากนั้นยังมีประโยชน์สำหรับ กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ต้องการลดต้นทุนการผลิตและลดขั้นตอน กระบวนการสร้าง และรวมไปถึงกลุ่มนิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจที่ต้องการนำข้อมูลไป ประยุกต์ใช้ในงานวิจัยอื่นๆเพิ่มเติม

1.10 ระเบียบขั้นตอนการวิจัย

- ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในงานรูปแบบ ต่างๆ เช่น ไมโครปั้ม วาล์วขนาดเล็ก มือจับขนาดเล็ก เป็นต้น
- ศึกษาขนาดและรูปร่างของไมโครแอคชั่วเอเตอร์ด้วยวิธีการไฟไนต์อิลิเมนต์และ การคำนวณการถ่ายเทความร้อนเพื่อคำนวณหาระยะกระดกของไมโครแอคชัวเอเตอร์
- ออกแบบกระบวนการสร้างและสร้างไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่มีลักษณะแบบคานสองชั้น ตามขนาดและรูปร่างที่ได้ศึกษาไว้ด้วยกระบวนการสร้างที่ไม่ใช้แผ่นซิลิกอน ในกระบวนการสร้าง
- ศึกษาการอบฟิล์มนิทินอลด้วยเตาอบแบบหลอดควอทซ์โดยมีก๊าซอาร์กอนไหลผ่าน พร้อม ทั้งทำการวัดคุณสมบัติของฟิล์มนิทินอลหลังจากทำการอบด้วยเครื่องมือต่างๆ

- ปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนในกระบวนการสร้าง
- ทดสอบไมโครแอกชัวเอเตอร์ที่สร้างขึ้นด้วยการทดสอบการตอบสนองเชิงสถิตย์และ การทดสอบการตอบสนองจลน์
- สรุปผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะพร้อมจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์

บทที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของไมโครแอคชัวเอเตอร์

ในงานวิจัยนี้จะทำการสร้างแอกชัวเอเตอร์แบบโลหะผสมจำรูปที่มีลักษณะเป็นคาน สองชั้นที่ประกอบด้วยวัสดุโลหะผสมจำรูปคือนิทินอลและโลหะอีกชนิดหนึ่งคือทองแดง ซึ่งจาก ตารางที่ 2.1 เมื่อทำการเปรียบเทียบคุณสมบัติของวัสดุทั้ง เงิน ทองแดง และนิเกิล สรุปได้ว่า ทองแดงเหมาะสมมากกว่าสำหรับนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่มีลักษณะ เป็นคานสองชั้น ซึ่งทองแดงเป็นโลหะที่มีคุณสมบัติที่ดีในหลายด้านเช่น มีค่าการถ่ายเทความร้อน (thermal conductivity) ที่ดี มีค่าความจุความร้อนจำเพาะ (specific heat) ที่สูง และมีค่าสัมประสิทธิ์ การขยายตัวที่สูง เป็นต้น นอกจากนี้ทองแดงเป็นวัสดุที่ราคาถูกและสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับ เทคนิคในการสร้างได้หลากหลาย ดังนั้นทองแดงจึงเป็นโลหะที่ถูกนำมาประกอบติดกับนิทินอล เพื่อสร้างเป็นไมโครแอกชัวเอเตอร์ลักษณะคานสองชั้นในการศึกษานี้

ในบทนี้จะทำการศึกษาพารามิเตอร์ของไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่มีผลต่อสมรรถนะของ ไมโครแอคชัวเอเตอร์ พารามิเตอร์ที่จะทำการศึกษาคือ ความหนาของทองแดง ความกว้างของ ไมโครแอคชัวเอเตอร์และความขาวของไมโครแอคชัวเอเตอร์ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็นสอง การศึกษาคือ การศึกษาระยะกระดกของไมโครแอคชัวเอเตอร์ด้วยระเบียบวิธีการทาง ไฟในต์อิลิเมนต์และการศึกษาการถ่ายเทความร้อนของไมโครแอคชัวเอเตอร์แบบโลหะผสมจำรูปที่ มีลักษณะเป็นกานสองชั้น

| Properties | Silver, Ag | Copper, Cu | Nickel, Ni |
|---|------------|------------|------------|
| Specific density (g/cc) | 9.30 | 8.94 | 8.88 |
| Specific heat (J/kg.K) | 234 | 385 | 460 |
| Thermal conductivity (W/m.K) | 419 | 398 | 60.7 |
| Tensile strength (MPa) | 124 | 33.3 | 59.0 |
| Modulus of elasticity (GPa) | 76 | 124 | 207 |
| Poisson ration | 0.37 | 0.34 | 0.31 |
| Shear modulus (GPa) | 27.8 | 48 | 76 |
| Coefficient of thermal expansion (ppm/°C) | 19.6 | 16.5 | 13.1 |

ตารางที่ 2.1 คุณสมบัติของเงิน ทองแคงและนิกเกิล
2.1 การศึกษาระยะกระดกของไมโครแอคชั่วเอเตอร์ด้วยระเบียบวิธีการทาง ไฟในต์อิลิเมนต์

รูปภาพที่ 2.1(ก) แสดงลักษณะของไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่จะทำการศึกษาในงานวิจัยนี้ ด้วยลักษณะของไมโครแอคชัวเอเตอร์ดังกล่าวทำให้จำลองเป็นกานเส้นตรงที่แสดงในภาพที่ 2.1(ข) ได้ เมื่อทำการยึดปลายด้านหนึ่งของไมโครแอคชัวเอเตอร์ไว้และทำการเพิ่มอุณหภูมิให้กับ ไมโครแอคชัวเอเตอร์ในลักษณะนี้จะทำให้ปลายอีกข้างหนึ่งเกิดการโก่งตัวขึ้นในแนวคิ่งเช่นกัน

การศึกษาระยะกระดกของไมโครแอคชัวเอเตอร์ด้วยระเบียบวิธีการทางไฟในต์อิลิเมนต์นี้ มีวัตถุประสงก์เพื่อหาขนาดของไมโครแอคชัวเอเตอร์แบบโลหะผสมจำรูปที่มีลักษณะเป็นกานสอง ชั้นที่เหมาะสม ซึ่งในงานวิจัยนี้จะใช้โปรแกรมไฟในต์อิลิเมนต์ ANSYS เข้ามาช่วยในการทำนาย ระยะกระดกโดยนำแนวคิดการทำนายระยะกระดกของไมโกรแอคชัวเอเตอร์อย่างง่ายจากงานวิจัย ของกฤษกรณ์ ประไพพิทยาคุณ [19] มาประยุกต์ใช้คือ ในสภาวะที่เพิ่มอุณหภูมิของนิทินอล (Ni:Ti = 50:50) จาก 25 องศาเซลเซียสเป็น 80 องศาเซลเซียส โดยที่มีรูปร่างของไมโครแอคชัวเอเตอร์ ก่อนเพิ่มอุณหภูมิมีลักษณะแบบแบนราบและสมมติให้รูปร่างของไมโกรแอคชัวเอเตอร์มีลักษณะ เป็นคานตรงเท่านั้น สำหรับการกำหนดโปรแกรมไฟในต์อิลิเมนต์ ANSYS จะทำการกำหนด ก่าสภาวะต่างๆ ดังตารางที่ 2.2 โดยอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมเป็น 25 องศาเซลเซียส พร้อมทั้งกำหนด การสร้างเมช (mesh) แบบอัตโนมัติด้วยโหมด "proximity and curvature" ดังแสดงตัวอย่างของ การสร้างเมชในภาพที่ 2.1(ค) จากนั้นทำการกำหนดปลายด้านหนึ่งเป็น "fixed support" สำหรับ บริเวณที่ประกบกันระหว่างนิทินอลกับทองแดงจะทำการกำหนดแบบ "bonded" และกำหนด การกำนวณเป็นแบบไม่เชิงเส้นหรือกำหนดให้เป็น "large deformation" จากนั้นกำหนดอุณหภูมิ ของนิทินอลและทองแดงเป็น 80 องศาเซลเซียส แล้วจึงทำการกำนวณเพื่อหาระขะกระดกของกาน ที่จะเกิดขึ้น

| Parameter | Condition |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Environment temperature | 25°C |
| Mesh | Auto (Proximity and curvature) |
| Fixed support | One end of the beam |
| Contact region (nitinol/copper) | Bonded |
| Large deflection | On |

ตารางที่ 2.2 รายละเอียดในการกำหนดค่าภายในโปรแกรมไฟในต์อิลิเมนต์ ANSYS



ภาพที่ 2.1 ลักษณะของคานที่นำมาศึกษาในโปรแกรมไฟในต์อิลิเมนต์ ANSYS (ก) ไมโคร แอคชัวเอเตอร์ที่ทำการสร้าง (ข) รูปร่างคานที่มีลักษณะสองชั้น (ค) ลักษณะคานในโปรแกรม

| Properties | Nitinol, NiTi | Copper, Cu |
|--|---------------|------------|
| Specific density (g/cc) | 6.45 | 8.94 |
| Coefficient of thermal expansion (ppm/°C) | -88 | 16.5 |
| Modulus of elasticity (GPa) | 30 | 124 |
| Possion's ratio | 0.3 | 0.34 |
| Bulk modulus (GPa) | 25 | 140 |
| Shear modulus (GPa) | 11.53 | 48 |

ตารางที่ 2.3 คุณสมบัติของวัสคุในการทำนายระยะกระดกด้วยโปรแกรมไฟไนต์อิลิเมนต์ ANSYS

ในหัวข้อนี้จะศึกษาผลของความหนาของทองแดงที่มีผลต่อระยะกระดกของคานโดยใช้ กุณสมบัติต่างๆของวัสดุดังตารางที่ 2.3 สำหรับความกว้างของคานจะไม่มีผลต่อการกระดกใน ทิศทางตั้งฉากกับโครงสร้างในลักษณะนี้และสำหรับความยาวของคานจะส่งผลทำให้ระยะกระดก สูงขึ้นหากมีความยาวของคานมากขึ้น โดยในการศึกษาจะทำการเปลี่ยนแปลงความหนาของ ทองแดงเป็น 12, 25, 50, 75 และ 100 ไมโครเมตรในขณะที่เปลี่ยนอุณหภูมิของคานที่ 50, 100 และ 125 องศาเซลเซียส โดยมีความกว้างของคานคงที่เท่ากับ 250 ไมโครเมตร ความยาวของคานคงที่ เท่ากับ 22.5 มิลลิเมตรและความหนาของนิทินอลคงที่เท่ากับ 5 ไมโครเมตร โดยแสดงพารามิเตอร์ ในการศึกษาดังตารางที่ 2.4 รวมเป็นการศึกษาทั้งหมด 15 กรณี

ตารางที่ 2.4 พารามิเตอร์ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่าความยาวของคานร่วมกับความหนาของ ทองแคงในโปรแกรมไฟในต์อิลิเมนต์ ANSYS

| Copper's | Cantilever's | Cantilever's | Nitinol | Тетр | erature | (°C) |
|----------------|--------------|--------------|----------------|------|---------|------|
| Thickness (µm) | length (mm) | width (µm) | thickness (µm) | | | |
| 12 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 50 | 22.5 | 250 | 5 | 50 | 100 | 125 |
| 75 | | | | | | |
| 100 | | | | | | |

นอกจากนี้ในหัวข้อนี้ได้ทำการหาระยะกระดกของคานด้วยการคำนวณระยะรัศมีจาก สมการคานคอม โพสิทร่วมกับแนวคิดในภาพที่ 2.2 โดยใช้พารามิเตอร์สำหรับการคำนวณ ดังตารางที่ 2.3 และตารางที่ 2.4 ซึ่งรายละเอียดของสมการแสดงดังสมการที่ 2.1 ถึงสมการที่ 2.4



ภาพที่ 2.2 แนวคิดในการหาระกระของคานจากการคำนวณ

$$r = \frac{t\{3(1+m)^2 + (1+mn)[m^2 + (1/mn)]\}}{(\alpha_2 - \alpha_1)(T - T_0)(1+m^2)}$$
(2.1)

r คือรัสมีความโค้งของระยะกระดกของคาน

t คือความหนาโดยรวมของคาน

m คืออัตราส่วนของความหนาระหว่างวัสดุที่มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทาง
 ความร้อนต่ำต่อวัสดุที่มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนสูง

n คืออัตราส่วนของค่ามอดูลัสของยังระหว่างวัสดุที่มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทาง ความร้อนต่ำต่อวัสดุที่มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนสูง

- $lpha_1$ คือก่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางกวามร้อนต่ำ
- $lpha_2$ คือก่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางกวามร้อนสูง
- *T* คืออุณหภูมิของคาน
- T_0 คืออุณหภูมิเริ่มต้นของคาน

$$\theta = \frac{l}{r} \tag{2.2}$$

l คือความยาวของคาน

$$a = \frac{r}{\cos \theta} \tag{2.3}$$

$$Z = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)}{(a - r)} \tag{2.4}$$

Z คือระยะกระคกของคาน

จากการคำนวณด้วยระเบียบวิธีไฟในต์อิลิเมนต์พบว่า เมื่อคานมีอุณหภูมิสูงขึ้นคานจะ ยึดตัวออกเนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนของวัสดุทั้งสองพร้อมกับคาน กระดกขึ้นแสดงในภาพที่ 2.3(ก) แต่หากอุณหภูมิของคานสูงเกินไปจะทำให้คานยึดตัวออกและ กระดกจนเสียรูปจึงทำให้คานมีระยะกระดกลดลงแสดงในภาพที่ 2.3(ข) และภาพที่ 2.3(ค) จากนั้น นำค่าระยะกระดกสูงสุด ของคานมาวิเคราะห์ภาพที่ 2.4 ซึ่งแสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง กวามหนาของทองแคงร่วมกับระยะกระคกของคานที่อุณหภูมิต่างๆจากระเบียบวิธีการไฟในต์ อิลิเมนต์ (เส้นทึบ) และการคำนวณ (เส้นประ)พบว่าที่อุณหภูมิเท่ากันเมื่อความหนาของทองแดง เพิ่มขึ้น คานจะมีระยะกระคกที่ลคลง แต่ที่ความหนาของทองแดงเท่ากัน หากอุณหภูมิของ กานสูงขึ้น ระยะกระคกของกานจะสูงขึ้นเช่นกัน และเมื่อทำการเปรียบเทียบระยะกระคกของคาน ด้วยระเบียบวิธีการทางไฟในต์อิลิเมนต์กับระยะกระคกของคานที่สภาวะเดียวกันพบว่า ระยะกระคกของกานจากคำนวณจะมีค่าน้อยกว่า ระยะกระคกของคานที่สภาวะเดียวกันพบว่า ระยะกระคกของกานจากคำนวณจะมีค่าน้อยกว่า ระยะกระคกจากวิธีการทางไฟในต์อิลิเมนต์ เล็กน้อยแต่มีแนวโน้มของระยะกระคกที่เหมือนกัน นอกจากนั้นยังสังเกตได้ว่าที่ความหนาทองแคง 12ไมโครเมตร คานจะมีระยะกระคกที่มากกว่า 22.5 มิลลิเมตรซึ่งเป็นความยาวของคาน เนื่องจาก เมื่อคานได้รับความร้อนแล้ว คานจะมีการยึดตัวออกด้วยทำให้เป็นไปได้ว่าคานจะกระคกด้วย ระยะที่มากกว่าความยาวก่อนได้รับความร้อน

จากผลการศึกษาระยะกระดกของคานแบบโลหะผสมจำรูปที่มีลักษณะเป็นคานสองชั้นที่ ประกอบด้วยนิทินอลกับทองแดงซ้อนทับกันอยู่ในโปรแกรมไฟในต์อิลิเมนต์ ANSYS จะเห็นได้ว่า ความหนาของทองแดงมีผลต่อระยะกระดกของคานเป็นอย่างมาก โดยที่อุณหภูมิเดียวกัน หากความหนาของทองแดงลดลง 50% ระยะกระดกของคานจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 250%



ภาพที่ 2.3 ลักษณะการกระดกของคานที่มีทองแดงหนา 12 ไมโครเมตรในโปรแกรมไฟไนต์ อิลิเมนต์ ANSYS (ก) 50 องศาเซลเซียส (ข) 100 องศาเซลเซียส (ค) 125 องศาเซลเซียส



ภาพที่ 2.4 ระยะกระดกของกานเมื่อทำการเปลี่ยนแปลงกวามหนาของทองแดง โดยมีความหนาของ นิทินอลเท่ากับ 5 ไมโครเมตรที่อุณหภูมิต่างๆ โดยระเบียบวิธีการไฟไนต์อิลิเมนต์ (เส้นทึบ) และการกำนวณ (เส้นประ)

2.2 การศึกษาการถ่ายเทความร้อนของไมโครแอคชั่วเอเตอร์แบบโลหะผสมจำรูปที่มี ลักษณะเป็นคานสองชั้น

การถ่ายเทความร้อนของไมโครแอคชัวเอเตอร์จะส่งผลต่อความถี่ในการใข้งานของ ไมโครแอคชัวเอเตอร์โดยตรงเนื่องจากไมโครแอคชัวเอเตอร์มีความร้อนสะสมมากและมีอุณหภูมิ สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว นิทินอลจะเปลี่ยนเฟสได้เร็วขึ้นและทำให้ไมโครแอคชัวเอเตอร์กระดกเร็วตาม ไปด้วย ในการศึกษาการถ่ายเทความร้อนของไมโครแอคชัวเอเตอร์นี้จะทำการวิเคราะห์การเก็บ สะสมความร้อนของไมโครแอคชัวเอเตอร์ด้วยการวิเคราะห์ระบบที่ถูกจำลองดังภาพที่ 2.5

เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านไมโครแอคชัวเอเตอร์จะเกิดความร้อน เนื่องจากการที่อิเล็กตรอน วิ่งผ่านตัวต้านทาน โดยสามารถหาขนาดความร้อนที่เกิดขึ้นได้จากสมการที่ 2.5

$$\dot{Q} = I_A^2 R_A \tag{2.5}$$

- $\dot{m{Q}}$ คือความร้อนที่เกิดขึ้นในไมโครแอกชัวเอเตอร์
- I_A คือกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับไมโครแอคชัวเอเตอร์
- R_A คือความต้านทานของไมโครแอคชัวเอเตอร์



ภาพที่ 2.5 รูปแบบการนำความร้อนทางเดียว (One-dimensional heat conduction)

โดยที่

$$R_A = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \tag{2.6}$$

 R_1 คือความต้านทานของทองแดง

 R_2 คือความต้านทานของนิทินอล

โดยที่ *R* ของทั้งสองชนิดขึ้นอยู่กับความยาวและพื้นที่หน้าตัดของวัสดุ ซึ่งสามารถหาได้จาก สมการที่ 2.7

$$R = \rho_E \frac{L}{A} \tag{2.7}$$

 ho_E คือค่าความต้านทานทางไฟฟ้าของวัสดุ

L คือความยาวของวัสดุที่กระแสไฟฟ้าผ่าน

A คือพื้นที่หน้าตัดของวัสดุที่กระแสไฟฟ้าผ่าน

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \dot{q} = \rho_A c_p \frac{\partial T}{\partial t}$$
(2.8)

 $\frac{\partial T}{\partial x}$ คือการนำความร้อนในทิศทางแกน X

- \dot{q} คืออัตราการเกิดความร้อนต่อปริมาตร
- ho_A คือความหนาแน่นของไมโครแอคชั่วเอเตอร์
- Cp คือความจุความร้อนจำเพาะของไมโครแอคชัวเอเตอร์
- $\frac{\partial T}{\partial t}$ คืออัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิต่อเวลา

โดยที่

$$\dot{q} = \frac{\dot{Q}}{V_A} \tag{2.9}$$

 $V_{\mathcal{A}}$ คือปริมาตรของใมโครแอคชั่วเอเตอร์

$$\rho_A = \frac{(\rho_1 V_1 + \rho_2 V_2)}{V_A} \tag{2.10}$$

- ho_1 คือความหนาแน่นของทองแดง
- V_1 คือปริมาตรของทองแดง
- ho_2 คือความหนาแน่นของนิทินอล
- V_2 คือปริมาตรของนิทินอล

$$c_p = \frac{m_1 c_{p,1} + m_2 c_{p,2}}{m} \tag{2.11}$$

- *m* คือมวลของคาน
- m_1 คือมวลของทองแดง
- $\mathcal{C}_{p,1}$ คือความจุกวามร้อนจำเพาะของทองแดง
- m_2 คือมวลของนิทินอล
- $\mathcal{C}_{p,2}$ คือความจุกวามร้อนจำเพาะของนิทินอล

การวิเคราะห์การเก็บสะสมความร้อนของไมโครแอคชัวเอเตอร์จะทำการวิเคราะห์โดย การจำลองในรูปแบบที่มีการนำความร้อนในทิศทางเดียว สามารถเขียนได้ตามสมการที่ 2.8 เมื่อทำ การวิเคราะห์โดยการจำลองที่สภาวะคงตัว (ไม่มีการนำความร้อนภายในวัตถุ) จะสามารถลดรูป สมการและเขียนได้ตามสมการที่ 2.12

$$\Delta T = \frac{I_A^2 R_A}{V \rho_A c_p} t \tag{2.12}$$

 ΔT คืออุณหภูมิของไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่เกิดขึ้น t คือเวลาที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับไมโครแอคชัวเอเตอร์

ในการศึกษาการถ่ายเทความร้อนของไมโครแอคชัวเอเตอร์จะทำการคำนวณปริมาณการ เก็บสะสมความร้อนจากสมการที่ 2.12 และใช้พารามิเตอร์ในการคำนวณคังในตารางที่ 2.5 ในการคำนวณนี้จะทำการเปลี่ยนแปลงความหนาของทองแคงเป็น 12, 25, 75 และ 100 ไมโครเมตร โดยมีความยาวของคานคงที่ 22.5 มิลลิเมตร ความกว้างของคานคงที่เท่ากับ 250 ไมโครเมตรและ ความหนาของนิทินอลคงที่ 5 ไมโครเมตร โดยแสดงพารามิเตอร์ในศึกษาคังตารางที่ 2.6 และใช้ กระแสไฟฟ้าในการจ่ายแบบจำลองต่างๆ

กราฟแสดงความสัมพันธ์ของความหนาของทองแดงต่อระยะเวลาในการเพิ่มอุณหภูมิของ ใมโครแอคชัวเอเตอร์จาก 25 ถึง 80 องศาเซลเซียสด้วยกระแสไฟฟ้าขนาดต่างๆแสดงดังภาพที่ 2.6 พบว่า เมื่อความหนาของทองแดงลดลง ระยะเวลาในการเพิ่มอุณหภูมิจะลดลงเช่นกัน และเมื่อ การจ่ายกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ระยะเวลาในการเพิ่มอุณหภูมิจะลดลงเช่นกัน โดยที่ความหนาของ ทองแดงเท่ากับ 12 ใมโครเมตรที่การจ่ายกระแสไฟฟ้า 1, 2 และ 3 แอมแปร์ จะมีระยะเวลาใน การเพิ่มอุณหภูมิของไมโครแอคชัวเอเตอร์จาก 25 ถึง 80 องศาเซลเซียสเท่ากับ 0.4, 0.1 และ 0.04 วินาทีตามลำดับ

| Properties | Nitinol, NiTi | Copper, Cu |
|-------------------------|---------------|------------|
| Specific density (g/cc) | 6.45 | 8.94 |
| Specific heat (J/kg.K) | 837 | 385 |
| Electrical Resistivity | 0.82 | 0.017 |
| (ppm.ohm.m) | 0.82 | 0.017 |

| d | 9 | ° 0 | e a | 2 1 | e v | ທ ຈ | é | đ |
|-------------|---------|-------|---------|---------------|------------|---------|-------------|-----|
| ตารางท์ 2.5 | พารามเต | อรสาเ | งรบการค | ใกษาการถายเทเ | ความร้อนขอ | ง เม เร | ารแอคชวเอเด | าอร |

| ตารางที่ 2.6 | พารามิเตอร์ในการศึก | าษาการถ่ายเทควา | เมร้อนของไมโครเ | เอคชัวเอเตอร์ โดย |
|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| เปลี่ยนแปลงค่าค | าวามกว้างของคานร่วมก้ | ข้ากวามหนาของทอ | องแดง | |

| Cantilever's length | Cantilever's width | Nitinol thickness | Copper thickness |
|---------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|
| (mm) | (μm) | (μm) | (μm) |
| 22.5 | | 12 25 5 | 12 |
| | 250 | | 25 |
| | 250 | | 5 |
| | | | 100 |



ภาพที่ 2.6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระยะเวลาที่อุณหภูมิของไมโครแอคชัวเอเตอร์มีค่า เท่ากับ 80 องศาเซลเซียสกับขนาคต่างๆของไมโครแอคชั่วเอเตอร์

สรุปผลการศึกษาพารามิเตอร์ของใมโครแอคชัวเอเตอร์ 2.3

ในบทนี้ได้ทำการศึกษาพารามิเตอร์ที่มีผลต่อสมรรถนะของไมโครแอคชัวเอเตอร์แบบ ้โลหะผสมจำรูปที่มีลักษณะแบบคานสองชั้น ซึ่งไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการศึกษานี้ประกอบด้วย ้นิทินอลและทองแดงซ้อนทับกัน โดยแบ่งการศึกษาออกเป็นสองการศึกษาคือ การศึกษาระยะ กระดกของไมโครแอคชั่วเอเตอร์ด้วยระเบียบวิธีการทางไฟในต์อิลิเมนต์และการศึกษาระยะเวลาใน การการถ่ายเทความร้อนของไมโครแอคชั่วเอเตอร์แบบโลหะผสมจำรูปที่มีลักษณะเป็นคานสองชั้น โคยมีพารามิเตอร์ที่ทำการเปลี่ยนแปลงค่าคือ ความหนาของทองแคงเพียงพารามิเตอร์เดียว

จากการศึกษาระยะกระดกของไมโครแอคชัวเอเตอร์ด้วยระเบียบวิธีการทาง ไฟในต์อิลิเมนต์ โดยสมมติให้รูปร่างของไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการศึกษามีลักษณะเป็นกานที่มี การเปลี่ยนแปลงความหนาของทองแดงขณะที่เปลี่ยนอุณหภูมิต่างๆจะเห็นได้ว่า ที่อุณหภูมิเท่ากัน เมื่อความหนาของทองแดงเพิ่มขึ้น คานจะมีระยะกระดกที่ลดลง แต่ที่ความหนาของทองแดงเท่ากัน หากอุณหภูมิของคานสูงขึ้น ระยะกระดกของคานจะสูงขึ้นเช่นกัน โดยที่อุณหภูมิเดียวกันหากความ หนาของทองแดงลดลง 50% ระยะกระดกของคานจะสูงขึ้นเช่นกัน โดยที่อุณหภูมิเดียวกันหากความ หนาของทองแดงลดลง 50% ระยะกระดกของคานจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 250% และจากการศึกษา การถ่ายเทความร้อนของคานด้วยการคำนวณโดยกำหนดรูปร่างของไมโครแอคชัวเอเตอร์แบบ โลหะผสมจำรูปที่มีลักษณะเป็นคานสองชั้นจะเห็นได้ว่า หากความหนาของทองแดงลดลง ระยะเวลาในการเพิ่มอุณหภูมิจะลดลงและหากทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ระยะเวลาในการเพิ่ม อุณหภูมิจะลดลงเช่นกัน โดยที่ความหนาของทองแดงเท่ากับ 12 ไมโครเมตรที่การจ่ายกระแสไฟฟ้า 1, 2 และ 3 แอมแปร์ จะมีระยะเวลาในการเพิ่มอุณหภูมิของไมโครแอคชัวเอเตอร์จาก 25 ถึง 80 องศาเซลเซียสเท่ากับ 0.4, 0.1 และ 0.04 วินาทีตามลำดับ

การศึกษาระขะกระคกด้วยระเบียบวิธีการทางไฟไนต์อิลิเมนต์และการศึกษาการถ่ายเท ความร้อนสามารถสรุปได้ว่า ไมโครแอคชัวเอเตอร์แบบโลหะผสมจำรูปที่มีลักษณะเป็นคานสอง ชั้นที่มีความหนาของทองแดงที่บางจะทำให้ไมโครแอคชัวเอเตอร์มีระยะกระคกที่ดีและมีการถ่ายเท ความร้อนหรือความถี่ในการใช้งานที่สูงด้วยเช่นกัน สำหรับรูปร่างของไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่จะ นำไปสร้างต่อไปจะมีรูปร่างเป็นลักษณะเหมือนตัวยูคว่ำประกอบด้วยขาของไมโครแอคชัวเอเตอร์ สี่เหลี่ยมจัสตุรัสด้านบนและสีเหลี่ยมจัสตุรัสด้านล่าง 2 ชิ้น ซึ่งรูปร่างที่จะนำไปสร้างในบทถัดไป เป็นรูปร่างนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายตัวอย่างเช่น อุปกรณ์หยิบจับขนาดเล็ก ไมโครเซนเซอร์และอุปกรณ์รบกวนการไหลของของไหล เป็นด้น

บทที่ 3 กระบวนการสร้างไมโครแอคชัวเอเตอร์

กระบวนการสร้างไมโครแอคชัวเอเตอร์โดยทั่วไปจะทำการสร้างบนแผ่นซิลิกอนซึ่งทำให้ กระบวนการสร้างโดยส่วนใหญ่แล้วมีขั้นตอนที่ซับซ้อน [9][12] และอาจจะเกิดการเสียหายต่อ ไมโครแอคชัวเอเตอร์หรือชิ้นง่ายได้ง่าย[11] [13][14][15] เพื่อหลีกเลี่ยงกระบวนการสร้างที่ ซับซ้อนและความเสียที่จะเกิดขึ้นกับไมโครแอคชัวเอเตอร์ งานวิจัยนี้จึงนำเสนอกระบวนการสร้าง ไมโครแอคชัวเอเตอร์แบบใหม่โดยไม่ใช้แผ่นซิลิกอนในกระบวนการสร้าง โดยในกระบวนการ สร้างแบบใหม่นี้จะประกอบด้วยกระบวนการในการสร้างเพียงสองขั้นตอนหลักคือ กระบวนการ สร้างโครงสร้างทองแดงแบบลอยตัวและกระบวนการเกลือบผิวด้านบนของโครงสร้างทองแดง แบบลอยตัวด้วยนิทินอล สำหรับบทนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดกระบวนการสร้างไมโครแอคชัวเอเตอร์ ในขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งข้อจำกัดในการสร้างไมโครแอกชัวเอเตอร์ในแต่ละขั้นตอนด้วย

3.1 กระบวนการสร้างโครงสร้างทองแดงแบบลอยตัว

ในงานวิจัยนี้นำเสนอกระบวนการสร้างโครงสร้างทองแคงแบบลอยตัวด้วยเทคนิคการชุบ โลหะด้วยไฟฟ้าเคมืลงบนแผ่นสเตนเลสที่มีการสร้างแบบหล่อตามลวดลายที่ต้องการไว้ ใน กระบวนการสร้างโครงสร้างทองแคงแบบลอยตัวนี้สามารถแบ่งออกได้เป็นสองขั้นตอนย่อยคือ ขั้นตอนการสร้างแบบหล่อและขั้นตอนการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าเคมี ดังภาพที่ 3.1



ภาพที่ 3.1 กระบวนการสร้างโครงสร้างทองแคงแบบลอยตัว (ก) สร้างแบบหล่อของโฟโต้รีซิส (ข) สร้าง ฟิล์มทองแคงด้วยกระบวนการไฟฟ้าเคมี (ค) ล้างแบบหล่อออกจะทำให้โครงสร้างทองแคงแยกตัวออก

3.1.1 ขั้นตอนการสร้างแบบหล่อ

การสร้างแบบหล่อเพื่อให้ได้รูปร่างของไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ต้องการ ในขั้นตอนการ สร้างแบบหล่อนี้ได้นำแนวคิคในการสร้างชิ้นงานระดับไมโครสเกลมาประยุกต์ใช้ในขั้นตอน โดย กระบวนการที่นำประยุกต์ใช้คือกระบวนการสร้างลวดลายด้วยแสง เป็นกระบวนการเปลี่ยน คุณสมบัติของฟิล์มโฟโต้รีซิส (photoresist) ด้วยการฉายแสง เพื่อสร้างแบบหล่อที่มีขนาดอยู่ใน ระดับไมโครสเกลที่ต้องการ สำหรับรายละเอียดในขั้นตอนการสร้างแบบหล่อมีดังนี้

- เตรียมแผ่นซับสเตรต (substrate): ทำการขัดผิวของแผ่นสเตนเลสด้วยกระคาษทรายน้ำ โดย ทำการขัดด้วยกระคาษทรายน้ำตั้งแต่เบอร์หยาบไปจนถึงเบอร์ละเอียด (เบอร์ 800, 1000, 1200, 1500 และ 2000 ตามลำดับ) ทำให้พื้นผิวของแผ่นสเตนเลสมีก่าความขรุขระเท่ากับ 0.112 ไมโครเมตร ดังภาพที่ 3.2 ซึ่งการขัดผิวของของแผ่นสเตนเลสนี้จะส่งผลถึงการหลุด ออกของโครงสร้างทองแดงที่ด้องการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าเคมี เนื่องจากพื้นที่ผิวสัมผัส ระหว่างทองแดงกับแผ่นสเตนเลสลดน้อยลง จึงทำให้แรงยึดเหนี่ยวจึงลดลงด้วย ช่วยทำให้ โครงสร้างทองแดงหลุดออกมาจากแผ่นสเตนเลสได้
- 2. การติดฟิล์มโฟโด้ริซิส: การเกลือบแผ่นสเตนเลสที่ทำการบัดแล้วใช้เป็นแผ่นซับสเตรต ด้วยฟิล์มโฟโด้ริซิส โดยในงานวิจัยนี้จะใช้ฟิล์มโฟโด้ริซิสที่มีลักษณะเป็นแบบฟิล์มแข็ง (dry film) และมีคุณสมบัติเป็นเนกาทีฟ (negative photoresist, รายละเอียดการใช้งานแสดง ในภาคผนวก ก) ในการติดฟิล์มโฟโด้ริซิสแบบฟิล์มแข็ง เริ่มต้นด้วยการตัดฟิล์มโฟโตรีซิส นี้ให้มีขนาดใหญ่กว่าแผ่นสเตนเลสเล็กน้อย จากนั้นทำติดฟิล์มโฟโด้ริซิสลงแผ่น สเตนเลสด้วยเครื่องรีดฟิล์มไวแสง (รายละเอียดการใช้งานแสดงในภาคผนวก ก) ที่ อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เพื่อทำให้ฟิล์มโฟโด้ริซิสติดแน่นกับแผ่นสเตนเลสที่ ทำการบัดผิวไว้แล้ว
- การสร้างแบบหล่อ: เนื่องจากในงานวิจัยนี้ต้องการสร้างไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ระดับ ไมโครสเกล ดังนั้นขั้นตอนนี้จะนำกระบวนการสร้างลวดลายด้วยแสงมาประยุกต์ใช้ใน ขั้นตอน โดยนำแผ่นแบบลวดลาย (mask) ซึ่งมีรูปร่างของไมโครแอกชัวเอเตอร์ที่ต้องการ วาดอยู่ แสดงดังภาพที่ 3.3 (ในงานวิจัยนี้จัดทำแผ่นลวดลายด้วยการวาดลวดลายขึ้นใน โปรแกรม solid work จากนั้นจึงทำการพิมพ์ด้วยเลเซอร์ปริ้นเตอร์ลงบนแผนใส) วางไว้

ด้านบนของฟิล์มโฟโด้ริซิสที่ทำการดิดลงบนแผ่นสเตนเลสแล้ว โดยในการติดแผ่น ลวดลายลงบนฟิล์มโฟโด้ริซิสนี้จำเป็นด้องทำการดิดแผ่นลวดลายให้เรียบสนิทกับฟิล์มเพื่อ ป้องกันการหักเหของแสงที่ทำการฉายทำให้ขนาดของแบบหล่อที่สร้างขึ้นมีขนาดใหญ่ขึ้น หลังจากนั้นทำการฉายแสงยูวี (UV light) เป็นเวลา 20 วินาที ด้วยกล่องฉายยูวี (รายละเอียด การใช้งานแสดงในภาคผนวก ก) ส่วนของฟิล์มโฟโด้รีซิสที่กระทบกับแสง คุณสมบัติจะ เปลี่ยนไปทำให้ทำปฏิกิริยากับตัวทำละลาย (developer) ได้ช้า ในทางตรงกันข้ามส่วนของ ฟิล์มโฟโด้รีซิสที่ไม่กระทบกับแสงซึ่งมีลวดลายของแผ่นแบบกั้นอยู่ ฟิล์มจะทำปฏิกิริยา กับตัวทำละลายได้อย่างรวดเร็ว เมื่อทำการฉายแสงยูวีเสร็จ ทำการลอกแผ่นลวดลายออก จากแผ่นสเตนเลสและนำไปแช่ในตัวทำละลายโซเดียมไบการ์บอเนต (Na₂CO₃) จนฟิล์ม ส่วนที่ไม่กระทบแสงหลุดออกทำให้เกิดรูปร่างของลวดลายตามแผ่นลวดลาย หลังจากนั้น นำแผ่นสเตนเลสที่ทำการสร้างลวดลายแล้วไปล้างทำความสะอาดด้วยน้ำและนำไปอบที่ อุณหภูมิ 120 องสาเซลเซียสเป็นเวลา 7 นาทีด้วยเกรื่องฮอตแพลต (hot plate) เพื่อระเทยน้ำ ที่อยู่บนแผ่นสเตนเลสอดกและเป็นการทำให้ฟิล์มโฟโด้รีซิสแข็งตัวและยึดดิดกับ แผ่นสเตนเลสได้ลีขึ้น ภาพที่ 3.4 แสดงแผ่นสเตนเลสที่มีฟิล์มโฟโด้รัซิสเกลือบอยู่ด้านบน และได้ทำการสร้างลวดลายเรียบร้อยแล้ว



(ก) (ข) ภาพที่ 3.2 แผ่นสเตนเลสที่ผ่านการขัดด้วยกระดาษทรายน้ำ (ก) ก่อนขัด (ข) หลังขัด



ภาพที่ 3.3 แผ่นแบบลวดลายที่ใช้ในกระบวนการสร้างลวดลายด้วยแสง



ภาพที่ 3.4 แผ่นสเตนเลสหลังจากการสร้างแบบหล่อ

3.1.2 ข้อจำกัดในการสร้างแบบหล่อ

หลังจากทำขั้นตอนการสร้างแบบหล่อเสร็จจึงได้ทำการตรวจสอบขนาดแบบหล่อของ ใมโครแอคชัวเอเตอร์บนแบบที่สร้างขึ้นพบว่า ขนาดขาของไมโครแอคชัวเอเตอร์ในแบบหล่อมี ขนาดที่ใหญ่กว่าขนาดขาของไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ได้ทำการออกแบบ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงทำ การสืบค้นด้วยการตรวจวัดขนาดขาของไมโครแอคชัวเอเตอร์ในแบบหล่อที่สร้างขึ้น ขนาดขาของ ไมโกรแอกชัวเอเตอร์ที่ทำการวาดด้วยโปรแกรม solid work และขนาดขาของไมโกรแอกชัวเอเตอร์ บนแผ่นลวดลาย ภาพที่ 3.5 แสดงการเปรียบเทียบขนาดของแต่ละขนาดของชิ้นงานต่างๆเพื่อหา สาเหตุและข้อจำกัดในขั้นตอนการสร้างแบบหล่อนี้ เมื่อทำการเปรียบเทียบขนาดขาของ ไมโกรแอกชัวเอเตอร์บนแผ่นลวดลายกับขนาดขาของไมโกรแอกชัวเอเตอร์ในแบบหล่อบน แผ่นสเตนเลสจะมีก่ากวามผิดพลาดเพียง 1% ในทางตรงกันข้ามเมื่อทำการเปรียบเทียบขนาดของ ไมโกรแอกชัวเอเตอร์บนแผ่นลวดลายกับขนาดไมโกรแอกชัวเอเตอร์ที่ทำการวาดในโปรแกรม solid work จะมีก่ากวามผิดพลาดถึง 320% จากการเปรียบเทียบขนาดขาของไมโกรแอกชัวเอเตอร์ ในลักษณะนี้ สามารถสรุปได้ว่ากวามผิดพลาดที่ทำให้ขนาดแบบหล่อของไมโกรแอกชัวเอเตอร์ มินลักษณะนี้ สามารถสรุปได้ว่ากวามผิดพลาดที่ทำให้ขนาดแบบหล่อของไมโกรแอกชัวเอเตอร์ มินลักษณะนี้ สามารถสรุปได้ว่ากวามผิดพลาดที่ทำให้ขนาดแบบหล่อของไมโกรแอกชัวเอเตอร์ มินลักษณะนี้ สามารถสรุปได้ว่ากวามผิดพลาดที่ทำให้ขนาดแบบหล่อของไมโกรแอกชัวเอเตอร์ มินาดที่ใหญ่กว่าที่ทำการออกแบบ เป็นผลจากการที่โปรแกรม solid work ที่ใช้ในการวาดแบบแผ่น ลวดลายนี้อาจจะไม่เหมาะสมสำหรับการวาดระดับไมโกรสเกล ซึ่งถือเป็นข้อกำจัดในด้านของ การใช้โปรแกรมในการวาดแผ่นลวดลาย หากต้องการวาดแผ่นลวดลายที่อยู่ระดับไมโกรสเกล จำเป็นด้องเปลี่ยนโปรแกรมในการวาด เช่น AutoCAD เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามแผ่นลวดลายที่ใช้ ในขั้นตอนการสร้างแบบหล่อก็สามารถนำมาใช้งานในขั้นตอนการสร้างแบบหล่อได้ แต่ด้อง กำนึงถึงขนาดของแบบหล่อที่จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นประมาณ 5 เท่า



ภาพที่ 3.5 ขนาดขาของไมโครแอกชัวเอเตอร์ในขั้นตอนการสร้างแบบหล่อ (ก) แบบที่วาคใน โปรแกรม solid work (ข) แบบบนแผ่นลวคลาย (ก) แบบในแบบหล่อบนแผ่นสเตนเลส

3.1.3 ขั้นตอนการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าเคมี

ขั้นตอนการชุบโลหะค้วยไฟฟ้าเคมีเป็นขั้นตอนการเคลือบโลหะจากอิเล็กโทรคหนึ่งลงบน อิเล็กโทรคอีกฝั่งหนึ่งที่จุ่มอยู่ในสารละลายอิเล็กโตรไลท์และมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับระบบ โดยที่อิเล็กตรอนจะวิ่งจากขั้วแอโนคที่เป็นชิ้นโลหะที่ต้องการเคลือบผ่านไปยังขั้วแคโทคที่เป็น ชิ้นงานที่ต้องการเคลือบโลหะหรือแผ่นสเตนเลสที่ทำการสร้างแบบหล่อแล้ว ในกระบวนการ ดังกล่าวไอออนบวกจากขั้วแอโนดวิ่งผ่านสารละลายอิเล็กโตรไลท์มาเกาะยังชิ้นงานที่ขั้วแกโทดได้ สำหรับในงานวิจัยนี้จะทำการเกลือบทองแดงซึ่งเป็นชิ้นโลหะที่ต้องการเกลือบลงบนแผ่นสเตนเลส ที่ได้ทำการสร้างแบบหล่อขึ้นในขั้นตอนที่ผ่านมาแล้ว และใช้สารละลายกอปเปอร์ซัลเฟต (CuSO₄) เป็นสารละลายอิเล็กโตรไลท์สำหรับการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าเกมีของทองแดง ไดอะแกรมของการ ชุบโลหะด้วยไฟฟ้าเกมีได้แสดงดังภาพที่ 3.6 (รายละเอียดการใช้งานแสดงในภากผนวก ก) หลังจากทำการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าเกมีจนได้กวามหนาตามที่ต้องการแล้ว จึงนำแบบหล่อบน แผ่นสเตนเลสไปล้างออกด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เพื่อทำให้ได้ชิ้นงานหรือ โกรงสร้างทองแดงลอยตัวตามที่ต้องการ



ภาพที่ 3.6 ใดอะแกรมของการชุบโลหะด้วยใฟฟ้าเคมี

ในขั้นตอนการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าเคมีด้องทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปในระบบเพื่อทำ ให้ไอออนของทองแดงจากขั้วแอโนคไปเกาะยังแผ่นสเตนเลส ดังนั้นในขั้นตอนการชุบโลหะด้วย ไฟฟ้าเคมีจึงจำเป็นต้องหากระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมเพื่อทำให้สามารถสร้างโครงสร้างทองแดง ลอยตัวได้ โดยในงานวิจัยนี้ได้ใช้แนวคิคในการจ่ายกระแสไฟฟ้าในการชุบโลหะไฟฟ้าจาก กวามสัมพันธ์ระหว่างก่ากระแสไฟฟ้าต่อหน่วยพื้นที่ (current density) ในหน่วยมิลลิแอมแปร์ต่อ ตารางเซนติเมตรกับอัตราการปลูกฟิล์มของทองแดง (copper deposition rate) ในหน่วยไมโครเมตร ต่อชั่วโมงของการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าเคมีในงานวิจัยของภากร นนทิวัฒน์วณิช [20] มาประยุกต์ใช้ งาน ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ทำทดลองการจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อทำให้ได้โครงสร้างทองแดงแบบลอยตัวที่ บางลงในระดับต่ำกว่า 50 ไมโครเมตร โดยมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าและพารามิเตอร์ต่างๆ ดังตารางที่ 3.1

| พารามิเตอร์ | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 |
|---|------------|------------|------------|
| กระแสไฟฟ้า (มิลลิแอมแปร์) | 500 | 500 | 500 |
| พื้นที่ในการปลูกฟิล์มทองแคง (ตารางเซนติเมตร) | 32.59 | 32.59 | 11.34 |
| เวลาในการชุบโลหะด้วย กระบวนการไฟฟ้าเคมี(ชั่วโมง) | 1 | 3 | 1.25 |
| ความหนาของโครงสร้างทองแดง (ไมโครเมตร) | 7.23±1.1 | 21.14±3.4 | 12.28±0.82 |

ตารางที่ 3.1 พารามิเตอร์ในการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าเคมี

จากการทดลองจ่ายกระแสไฟฟ้าในการชุบโลหะด้วยกระบวนการไฟฟ้าเคมีพบว่า การทดลองจ่ายกระแสไฟฟ้าตามพารามิเตอร์ครั้งที่หนึ่ง สามารถสร้างโครงสร้างทองแดงลอยตัวที่มี ความหนาประมาณ 7 ไมโครเมตรได้ แต่ไม่สามารถนำมาใช้งานต่อได้ เนื่องจากโครงสร้างทองแดง ลอยตัวที่สร้างขึ้นไม่มีความแข็งแรงพอที่จะนำมาใช้งาน การทดลองจ่ายกระแสไฟฟ้าตาม พารามิเตอร์ครั้งที่สองพบว่า สามารถสร้างโครงสร้างทองแดงลอยตัวที่มีความแข็งแรงที่มีความหนา ประมาณ 21 ไมโครเมตรได้ แต่เนื่องจากโครงสร้างทองแดงที่สร้างขึ้นนี้มีความหนาที่มากเกินไป จึงจำเป็นต้องทดลองเพิ่มเติมอีกหนึ่งครั้ง

การทดลองจ่ายกระแส ไฟฟ้าในครั้งที่สามนี้สามารถสร้างโครงสร้างทองแดงแบบลอยตัว ด้วยที่มีความแข็งแรงและมีความหนาประมาณ 12 ไมโครเมตรซึ่งบางลงมาได้ พารามิเตอร์ต่างๆ ใน การชุบโลหะด้วยกระบวนการไฟฟ้ามีเคมีดังนี้คือ ค่ากระแสไฟฟ้าต่อหน่วยพื้นที่เท่ากับ 44.1 มิลลิแอมแปร์ต่อตารางเซนติเมตร และอัตราการปลูกฟิล์มของทองแดงเท่ากับ 9.82 ไมโครเมตรต่อ ชั่วโมง โครงสร้างทองแดงลอยตัวที่สร้างขึ้นในครั้งที่สามนี้มีโครงสร้างที่แข็งแรงและรูปภาพของ ใมโครแอคชัวเอเตอร์แสดงดังภาพที่ 3.7 ซึ่งมีความหนาของโครงสร้างทองแดงลอยตัวโดยเฉลี่ย เท่ากับ 12.2±0.8 ไมโครเมตร และภาพตัดขวางของโครงสร้างทองแดงลอยตัวแสดงดังภาพที่ 3.8 ซึ่งเป็นรูปที่ถ่ายจากกล้องจุลทัศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน (Scanning electron microscopy, SEM)



ภาพที่ 3.7 โครงสร้างทองแคงลอยตัวที่งานวิจัยนี้ได้ทำการสร้างขึ้น



ภาพที่ 3.8 ภาพตัดขวางของโครงสร้างทองแดงลอยตัวซึ่งมีความหนาเท่ากับ 12.2±0.8 ไมโครเมตร

3.1.4 ข้อจำกัดในขั้นตอนการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าเคมี

ในขั้นตอนการชุบโลหะด้วยกระบวนการไฟฟ้าเคมีจำเป็นต้องจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปใน ระบบเพื่อทำให้เกิดการเหนี่ยวนำทำให้ไอออนบวกจากขั้วแอโนดซึ่งเป็นทองแดงวิ่งผ่าน สารละลายอิเล็กโตรไลท์มาเกาะยังชิ้นงานที่ขั้วแคโทดที่เป็นแผ่นสเตนเลสได้ โดยข้อจำกัดใน ขั้นตอนการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าเคมีนี้ต้องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่ำกว่า 0.5 แอมแปร์ เพื่อลดความเค้นที่ เกิดขึ้นระหว่างการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าเคมีซึ่งจะทำให้โครงสร้างทองแดงลอยตัวที่สร้างขึ้นเกิดการ เสียรูปร่างได้ ภาพที่ 3.9 แสดงไมโครแอกชัวเอเตอร์ที่ทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าสูงกว่า 0.5 แอมแปร์ จะเห็นได้ว่า ไมโครแอคชั่วเอเตอร์เกิดการบิดงอเสียรูปและมีบางส่วนที่เกิดการหักเสียหาย ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่เกิดความเสียหายแก่ไมโครแอคชั่วเอเตอร์ที่สร้างขึ้นในขั้นตอนการชุบโลหะด้วย ไฟฟ้าเคมีจำเป็นต้องจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่ำกว่า 0.5 แอมแปร์



ภาพที่ 3.9 ลักษณะของไมโครแอคชัวเอเตอร์หลังจากทำการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าเคมีโดยจ่าย กระแสไฟฟ้ามากกว่า 0.5 แอมแปร์

3.2 กระบวนการเคลือบผิวด้านบนของโครงสร้างทองแดงแบบลอยตัวด้วยนิทินอล

สำหรับในกระบวนการเคลือบผิวด้านบนของโครงสร้างทองแคงด้วยนิทินอลแสดง ดังภาพที่ 3.10 นี้สามารถแบ่งเป็นสองขั้นตอนย่อยคือ ขั้นตอนการเคลือบผิวด้วยนิทินอลด้วย กระบวนการสปัตเตอริงและขั้นตอนการอบฟิล์มนิทินอลที่อุณหภูมิสูง



Sputtering Ni-Ti thin film and crystallization

ภาพที่ 3.10 กระบวนการเคลือบผิวค้านบนของโครงสร้างทองแคงแบบลอยตัวค้วยนิทินอล และการอบที่อุณหภูมิสูง

3.2.1 ขั้นตอนการเคลือบผิวด้วยนิทินอล

ในงานวิจัขนี้จะทำการเคลือบผิวด้วยนิทินอลด้วยเครื่องสปิดเตอริง (รายละเอียดการใช้งาน แสดงในภาคผนวก ก) โดยเริ่มจากนำโครงสร้างทองแดงแบบลอยตัวที่สร้างขึ้นวางลงบนฐาน (base) ของเครื่องสปิดเตอริง โดยมีการวางโครงสร้างทองแดงลอยตัวดังภาพที่ 3.11 แล้วนำฐานที่มี โครงสร้างทองแดงลอยตัวเรียงอยู่เข้าไปวางภายในเครื่องสปิดเตอริง หลังจากนั้นทำการเปิดปัึม สูญญากาศเพื่อปรับสภาวะในเครื่องสปิตเตอริงให้มีความดัน 10⁻⁵ มิลลิบาร์ เมื่อได้ความดันภายใน เครื่องสปิตเตอริงตามที่ต้องการแล้ว ทำการปล่อยก๊าซอาร์กอนเข้าไปในเครื่องสปิตเตอริงจามี ความดันภายในเครื่องสปิตเตอริงคงที่ที่ 3x10⁻³ มิลลิบาร์ หลังจากนั้นทำความสะอาดชิ้นงานด้วย RF clean ที่กำลัง 75 วัตต์ เป็นเวลา 5 นาที และทำความสะอาดแผ่นนิทินอล (nitinol target) ที่มี อัตราส่วนระหว่างนิกเกิลและไททาเนียมเป็น 50:50 ด้วย DC magnetron sputtering ด้วย กระแสไฟฟ้า 0.2 แอมแปร์ เป็นเวลา 5 นาที แล้วจึงทำการเปิดชัตเตอร์เกทภายในเครื่องสปิตเตอริง เพื่อเริ่มสร้างฟิล์มนิทินอลลงบนโครงสร้างทองแดงลอยตัว โดยพลังงานที่ใช้ในการจ่ายให้ กับ target ซึ่งเป็นนิทินอลที่ 580 โวลต์ ทำให้มีอัตราการปลูกฟิล์มของนิทินอล (nitinol deposition rate) ที่ 1 ไมโครเมตรต่อชั่วโมง โดยในงานวิจัยนี้จะทำการเกลือบผิวด้วยนิทินอลด้วยเตรื่องสปิตเตอริงตามเทคนิก การสปิตเตอริงได้แสดงดังภาพที่ 1.20



ภาพที่ 3.11 ลักษณะการวางโครงสร้างทองแดงแบบลอยตัวบนฐาน

หลังจากทำการเคลือบผิวด้วยนิทินอลแล้ว ในงานวิจัยนี้ได้ทำการตรวจวัดความหนาของ ฟิล์มนิทินอลที่สร้างด้วยกล้องจุลทัศน์อิเล็กตรอนแบบสแกนพบว่า นิทินอลที่ทำการปลูกบน โกรงสร้างทองแดงจะมีความหนาเท่ากับ 5.8 ไมโครเมตร โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.4 ไมโครเมตรภาพที่ 3.12 แสดงภาพตัดขวางของโครงสร้างทองแดงและนิทินอล จากผลการวัดพบว่า ในขั้นตอนการเคลือบผิวด้วยนิทินอลทำให้เกิดฟิล์มนิทินอลที่ไม่สม่ำเสมอ ซึ่งอาจส่งผลต่อ กุณลักษณะจำเพาะของนิทินอลและกุณสมบัติเชิงกลของไมโครแอคชัวเอเตอร์ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ฟิล์มนิทินอลที่ทำการปลูกบนโครงสร้างทองแดงนี้และมีการยึดติดที่ดีระหว่างผิวของฟิล์มนิทินอล และผิวของโครงสร้างทองแดง

3.2.2 ข้อจำกัดในขั้นตอนการเคลือบผิวด้วยนิทินอล

จากการตรวจวัดความหนาของฟิล์มนิทินอลที่สร้างขึ้นพบว่า นิทินอลมีความหนาที่ไม่ สม่ำเสมอ อาจจะเกิดเนื่องจากเครื่องสบัตเตอริงที่ใช้ในขั้นตอนนี้มีความคันภายในเครื่องสบัตเตอริง ต่ำไม่เพียงพอ โดยทั่วไปความคันภายในเครื่องสบัตเตองริงที่ใช้ในขั้นตอนการเคลือบผิวด้วย นิทินอลต้องมีความคัน 5x10⁻⁶ - 1x10⁻⁷ มิลลิบาร์ [21][22][23] โดยความคันภายในเครื่องสบัตเตอริง ที่ต่ำนี้จะทำให้มีระยะทางอิสระ (mean free path, MFP) ที่เหมาะสมกับนิทินอล ซึ่งจะทำให้ได้ ความหนาของฟิล์มนิทินอลที่สม่ำเสมอได้



ภาพที่ 3.12 ภาพตัดขวางของไมโครแอคชั่วเอเตอร์ โดยนิทินอลบนโครงสร้างทองแคงลอยตัวมี ความหนาเท่ากับ 5.8±0.4 ไมโครเมตร

3.2.3 ขั้นตอนการอบฟิล์มนิทินอล

ขั้นตอนการอบฟิล์มนิทินอลนี้เป็นขั้นตอนสำคัญที่ทำให้โครงสร้างภายในนิทินอล เปลี่ยนแปลงจากอมอพืสเป็นโครงสร้างผลึก โดยทั่วไปในการอบฟิล์มนิทินอลจะทำการอบที่ อุณหภูมิสูงกว่า 450 องศาเซลเซียสเพื่อทำให้ฟิล์มนิทินอลมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายใน ซึ่ง ขั้นตอนการอบฟิล์มนิทินอลนี้สามารถทำได้หลายเทคนิค เช่น อบในเตาภายใต้สูญญากาศ ที่สูง [16][17][5] หรือ อบด้วยเทคนิคการยิงเลเซอร์พลังงานสูง [18] เป็นต้น

สำหรับในงานวิจัยนี้ทำการอบฟิล์มนิทินอลภายในเตาอบแบบหลอดควอทซ์ โดยมีก๊าซไหลผ่าน โดยไดอะแกรมของเตาอบแบบหลอดควอทซ์โดยมีก๊าซไหลผ่านได้แสดง ดังภาพที่ 3.13 (รายละเอียดการใช้งานแสดงในภาคผนวก ก) สาเหตุที่งานวิจัยนี้เลือกใช้เตาอบ แบบหลอดควอทซ์โดยมีก๊าซไหลผ่านเนื่องจากเตาอบแบบหลอดควอทซ์เป็นเตาอบที่ง่ายต่อการใช้ งานและเป็นเตาอบที่มีการควบคุมที่ไม่ซับซ้อน ในทางตรงกันข้ามเตาอบแบบหลอดควอทซ์ มีข้อเสียบางประการคือ เตาอบแบบหลอดควอทซ์มีอัตราการลดอุณหภูมิที่ต่ำ (slow cooling rate) และไม่สามารถอบชิ้นงานในจำนวนมากได้เนื่องจากพื้นที่ภายในหลอดกวอทซ์มีจำกัด



ภาพที่ 3.13 แผนผังของเตาอบแบบหลอดควอทซ์ โดยมีก๊าซอาร์กอนใหลผ่าน

ในงานวิจัยนี้จะทำการอบฟิล์มนิทินอลที่อยู่บนโครงสร้างทองแดงลอยตัวตามขั้นตอน ้ต่อไปนี้ โดยเริ่มแรกจะนำไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการเคลือบผิวนิทินอลแล้ววางภายในแบบหล่อ ้คอนกรีต ซึ่งในงานวิจัยนี้มีแบบหล่อสำหรับอบไมโครแอกชัวเอเตอร์สองแบบคือ แบบหล่อที่มี ลักษณะแบนราบ (flat mold) และแบบหล่อที่มีลักษณะ โค้ง (curve mold) แสคงคังภาพที่ 3.14(ก) และ ภาพที่ 3.14(ข) โดยที่แบบหล่อคอนกรีตที่ใช้ในการอบสร้างมาจากคอนกรีตทนไฟและแบบ หล่อที่มีลักษณะ โค้งจะมีรัศมีความ โค้งเท่ากับ 22 มิลลิเมตร สำหรับการวางไม โครแอคชัวเอเตอร์ ภายในแบบหล่อจะทำการวางโดยให้ผิวของนิทินอลอยู่ด้านบนของโครงสร้างทองแดงลอยตัวดัง ภาพที่ 3.14(ก) และ ภาพที่ 3.14(ข) แล้วจึงทำการประกอบแบบหล่อให้มีลักษณะดังภาพที่ 3.15(ก) และ ภาพที่ 3.15(ข) ตามลำดับ หลังจากนั้นนำแบบหล่อที่ภายในมีไมโครแอคชัวเอเตอร์บรรจุอยู่เข้า ้ไปในเตาอบแบบหลอดควอทซ์ และทำการกำจัดอากาศภายในเตาอบแบบหลอดควอทซ์ออกด้วย การเปิดปั้มดูดทำให้ภายในหลอดควอทซ์มีกวามดันเป็นลบ (negative pressure) แล้วจึงทำปิดปั้มดูด แล้วปล่อยก๊าซอาร์กอนเข้าไปในหลอดควอทซ์ทำให้ความดันภายในหลอดควอทซ์เป็นบวก (positive pressure) จากนั้นหยุดปล่อยก๊าซอาร์กอนแล้วทำการเปิดปั้มดูดเพื่อทำการกำจัดอากาศ ภายในหลอดควอทซ์อีกครั้ง โดยจะทำการกำจัดอากาศภายในหลอดควอทซ์ออกซ้ำ 3 รอบ หลังจาก ้นั้นทำการปล่อยก๊าซอาร์กอนไหลผ่านหลอดควอทซ์ให้ความดันภายในหลอดควอทซ์เป็นบวก ตลอดขั้นตอนการอบ สำหรับเหตุผลที่งานวิจัยนี้เลือกใช้ก๊าซอาร์กอน (Argon) เนื่องจาก ้ก๊าซอาร์กอนเป็นก๊าซที่มีราคาถูกและสามารถป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเคชั่นภายในเตาอบแบบ หลอคควอทซ์ซึ่งทำให้เกิดออกไซด์ขึ้นบนผิวฟิล์มนิทินอลได้ เมื่อทำการกำจัดอากาศภายใน หลอดควอทซ์เสร็จแล้วจึงทำการเปิดเตาอบโดยกำหนดอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิสำหรับการอบ ้ชิ้นงานที่ 10 องศาเซลเซียสต่อนาทีและกำหนดเวลาในการรักษาอุณหภูมิคงที่เป็นเวลา 30 นาที

หลังจากนั้นเมื่อครบตามกำหนดเวลาแล้วจึงปิดเตาอบและรอให้อุณหภูมิภายในเตาอบลดลงโดยมี อัตราการลดลงของอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 2.5 องศาเซลเซียสต่อนาที



ภาพที่ 3.14 ลักษณะการจัดวางไมโครแอคชัวเอเตอร์ภายในแบบหล่อคอนกรีต (ก) ที่มีลักษณะแบนราบ (ง) ที่มีลักษณะโค้ง



ภาพที่ 3.15 แบบหล่อคอนกรีตและลักษณะการวางไมโครแอคชั่วเอเตอร์ภายในแบบหล่อคอนกรีต (ก) ที่มีลักษณะแบนราบ (ง) ที่มีลักษณะโค้ง

3.2.4 ข้อจำกัดในขั้นตอนการอบฟิล์มนิทินอล

ในขั้นตอนการอบฟิล์มนิทินอลด้วยเตาอบแบบหลอดควอทซ์โดยมีก๊าซอาร์กอนไหลผ่าน ได้ทำการอบไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่อุณหภูมิสูงกว่า 450 องศาเซลเซียสเพื่อต้องการทำให้ โครงสร้างภายในของนิทินอลเปลี่ยนแปลงจากอมอฟัสเป็นโครงสร้างผลึก หลังจากทำการอบ ้เมื่อเตาอบได้เย็นลงถึงอุณหภูมิห้อง พบว่า สีของฟิล์มนิทินอลที่อยู่บนโครงสร้างทองแคงลอยตัว ้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสีเงิน (ก่อนอบ) เป็นสีทองเล็กน้อย (หลังอบ) แสดงดังภาพที่ 3.16(ก) และ ภาพที่ 3.16 (ข) ตามลำคับซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ระหว่างทำการอบฟิล์มนิทินอลที่อุณหภูมิสูงได้ ้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นขึ้นภายในหลอดควอทซ์ ซึ่งอาจจะเกิดเพราะไม่สามารถกำจัดออกซิเจน ้ออกจากหลอดควอทซ์ได้หมด หรือเกิดรอยรั่วเล็กๆระหว่างข้อต่อของระบบทำให้อากาศสามารถ ์ใหลเข้าไปในหลอคควอทซ์ได้ เป็นต้น ดังนั้นในการอบฟิล์มนิทินอลจำเป็นต้องกำนึงถึงการกำจัด ้อากาศภายในหลอดควอทซ์และข้อต่อของอุปกรณ์ต่างๆของระบบเพื่อทำให้ภายในหลอดควอทซ์ ปราศจากก๊าซออกซิเจนอย่างแน่นอน และยังต้องคำนึงถึงการปล่อยก๊าซอาร์กอนเข้าไปภายใน หลอดควอทซ์เพื่อทำให้กวามดันภายในหลอดกวอทซ์เป็นบวกที่สุงขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้มีก๊าซ ้ออกซิเจนเข้ามาในระบบได้ นอกจากการป้องกันออกซิเจนแล้วยังต้องคำนึงก๊าซที่ไม่พึงประสงค์ ้อื่นๆเข้าไปในหลอดควอทซ์และทำให้เกิดการปนเปื้อนได้ ภาพที่ 3.16(ค) แสดงผิวของฟิล์ม ้นิทินอลบนไมโครแอคชั่วเอเตอร์ที่เกิดการปนเปื้อนและเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นขึ้นระหว่างทำการ ้อบฟิล์มนิทินอลที่อุณหภูมิสูง เนื่องจากภายในหลอคควอทซ์มีก๊าซไม่พึงประสงค์และ ้ก๊าซออกซิเจนอยู่ภายในระหว่างทำการอบฟิล์มนิทินอล จึงทำให้ผิวของฟิล์มนิทินอลมีลักษณะเป็น สีทองปนกับสีม่วงและสีฟ้าซึ่งทำให้คุณสมบัติของนิทินอลเปลี่ยนไปและส่งผลต่อคุณสมบัติเชิงกล ของไมโครแอคชั่วเอเตอร์อีกด้วย

3.3 อิทธิผลของการอบฟิล์มที่อุณหภูมิสูงต่อคุณลักษณะจำเพาะของนิทินอล

งั้นตอนการอบฟิล์มนิทินอลในงานวิจัยนี้ได้ทำการทดลองเปลี่ยนอุณหภูมิในงานอบ ใมโครแอคชัวเอเตอร์เพื่อหาอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สามารถทำให้โครงสร้างภายในนิทินอล เปลี่ยนแปลงจากอมอฟัสเป็นโครงสร้างผลึกด้วยเตาอบแบบหลอดควอทซ์โดยมีก๊าซอาร์กอนไหล ผ่าน ในการทดลองมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในการอบฟิล์มนิทินอลสามก่ากือ 500, 600 และ 650 องศาเซลเซียส โดยมีระยะเวลาการอบคงที่เท่ากับ 30 นาที และมีพารามิเตอร์อื่นๆดังแสดง ในตารางที่ 3.2

หลังจากทำการอบฟิล์มนิทินอลที่อุณหภูมิต่างๆแล้ว ในงานวิจัยนี้จะทำการศึกษา แฟกเตอร์หลักที่มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะจำเพาะของนิทินอลคือ ความเป็นโครงสร้างผลึกของ นิทินอล อัตราส่วนระหว่างไททาเนียมกับนิกเกิลและช่วงอุณหภูมิในการเปลี่ยนรูปร่าง ด้วย เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray diffraction, XRD) เครื่องวิเคราะห์ธาตุเชิง พลังงาน (Energy dispersive spectroscopy, EDS) และเครื่องวัดการถ่ายเทความร้อน (Differential scanning calorimetry, DSC) ตามลำดับ



(ค)

ภาพที่ 3.16 ลักษณะของผิวฟิล์มนิทินอลบนโครงสร้างทองแดง (ก) ก่อนทำการอบ (ข) หลังจากทำ การอบด้วยเตาอบ (ก) หลังจากทำการอบและเกิดการปนเปือนและเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นขึ้น

| | | y | |
|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| a | ୍ ବର୍ଷ | ດ ຍ | <u> </u> |
| ตารางท 3.2 | พาราบตอรสาหรบกา | เรทดลองไบขบเตอบก | ารจาเพลบบบทบอล |
| FI 13 IN FI 3.2 | | | 130 D MEIN R MROE |

| พารามิเตอร์ | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 |
|---|------------|------------|------------|
| อุณหภูมิในการอบคงที่ (°C) | 500 | 600 | 650 |
| เวลาในการอบคงที่ (min) | 30 | | |
| อัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ (°C/min) | 10 | | |
| อัตราการลดของอุณหภูมิโดยเฉลี่ย (°C/min) | | 2.5 | |

3.3.1 การทดสอบด้วยเครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์

เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (รายละเอียดการใช้งานแสดงในภาคผนวก ข) เป็นเครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุโดยอาศัยการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์เพื่อตรวจสอบลักษณะ ของโครงสร้างของวัสดุรวมถึงระบุส่วนประกอบวัสดุได้ ในการทดสอบด้วยเครื่องวิเคราะห์ การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ในงานวิจัยนี้จะทำการทดสอบไมโครแอกชัวเอเตอร์ที่มีลักษณะเป็นคาน สองชั้นที่ประกอบด้วยนิทินอลกับทองแดงซ้อนทับกันที่ไม่ทำการอบและทำการอบที่อุณหภูมิต่างๆ คือ 500, 600 และ 650 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 30 นาที รวมทั้งหมด 4 ชิ้นงานเปรียบเทียบกัน

กราฟความสัมพันธ์ของสององศาที่ระบุเอกลักษณ์ของธาตุต่อค่าพลังงานแสดง ้ดังภาพที่ 3.17 เป็นกราฟแสดงผลของการวิเคราะห์คณสมบัติของไมโครแอคชัวเอเตอร์แบบโลหะ ผสมจำรูปที่มีลักษณะเป็นคานสองชั้นที่ประกอบด้วยนิทินอลกับทองแดงซ้อนทับกันที่ไม่ทำ การอบและที่ทำการอบ ณ อุณหภูมิต่างๆจากกราฟพบว่าโครงสร้างไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ไม่ทำ การอบและทำการอบที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียสจะไม่แสดงก่าสูงสุด (peak) ของพลังงานของ โครงสร้างผลึกของนิทินอล ซึ่งก่าสูงสุดของพลังงานของโครงสร้างผลึกของนิทินอลจะแสดงที่ 42.5 องศาในกราฟ ดังนั้นอาจจะสรุปได้ว่า ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ไม่ทำการอบและทำการอบที่ อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียสมีโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นอมอฟัส ในทางตรงกันข้ามโครงสร้างของ กราฟของไมโครแอคชั่วเอเตอร์ที่ทำการอบที่อุณหภูมิ 600 และ 650 องศาเซลเซียสจะแสดง ้ ก่าสูงสุดของพลังงานของโครงสร้างผลึกของนิทินอล นอกจากนี้ไมโครแอคชั่วเอเตอร์ที่ทำการอบ ที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียสจะมีโครงสร้างผลึกของนิทินอลที่มากกว่าไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำ การอบที่อณหภมิ 600 องศาเซลเซียสอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามที่การอบที่อณหภมิสงจะทำให้เกิด โครงสร้างนิกเกิลทองแคง (NiCu) เกิดขึ้น ซึ่งมีก่าสูงสุดของพลังงานของโครงสร้างผลึกของ ้นิกเกิลทองแคงที่ 44 องศาในกราฟ นอกจากนี้ภายในฟิล์มของนิทินอลที่ทำการอบนี้มีโอกาสที่จะมี โครงสร้างผลึกของนิกเกิลไตรไททาเนียม (Ni,Ti) เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งมีค่าสูงสุดของพลังงาน ของโครงสร้างผลึกของนิกเกิลไตรไททาเนียมที่ 43 องศาในกราฟและมีโครงสร้างผลึกของ นิกเกิลไตรไททาเนียมสูงกว่าการอบที่อุณหภูมิอื่นๆ [24][25]

จากผลการทดสอบดังกล่าว งานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะนำไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการอบ ที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียสและมีระยะเวลาในการอบ 30 นาทีไปใช้งานต่อเท่านั้น เนื่องจาก ใมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการอบที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลาในการอบ 30 นาทีนี้ สามารถทำให้โครงสร้างภายในของฟิล์มนิทินอลเปลี่ยนแปลงจากอมอฟัสเป็นโครงสร้างผลึกได้ มากที่สุดเมื่อเทียบกับการอบที่อุณหภูมิอื่นๆ โดยโครงสร้างผลึกของนิทินอลที่เกิดขึ้นหลังจาก การทำการอบที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียสนี้จะเป็นโครงสร้างผลึกแบบออสเทนในด์ ณ อุณหภูมิห้อง



ที่ทำการอบ ณ อุณหภูมิต่างๆ

3.3.2 การทดสอบฟิล์มนิทินอลด้วยเครื่องวิเคราะห์ชาตุเชิงพลังงาน

เครื่องวิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงาน (รายละเอียดการใช้งานแสดงในภาคผนวก ข) เป็น เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุทางเคมีของสารตัวอย่าง โดยอาศัยการวัดพลังงานของ รังสีเอ็กซ์ที่คายออกมา ซึ่งธาตุแต่ละธาตุจะมีการคายพลังงานที่แตกต่างกัน จากหลักการนี้จึง สามารถระบุได้ว่าสารตัวอย่างที่ทำการวิคราะห์นี้เป็นธาตุชนิดใด การทดสอบพื้นผิวฟิล์มนิทินอล ด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงานในงานวิจัยนี้จะทำการทดสอบพื้นผิวฟิล์มนิทินอลที่ไม่ทำ การอบและพื้นผิวฟิล์มนิทินอลที่ทำการอบที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 30 นาที เพื่อทำการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสองชิ้นงาน

ภาพที่ 3.18 แสดงการเปรียบเทียบลักษณะของพื้นผิวฟิล์มนิทินอลที่จะนำไปวิเคราะห์ พบว่า พื้นผิวฟิล์มนิทินอลที่ทำการอบที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 30 นาที จะมี ลักษณะพื้นผิวที่ค่อนข้างเรียบและไม่มีร่องลึกปรากฎ แต่พื้นผิวฟิล์มนิทินอลที่ไม่ทำการอบจะมี ร่องลึกที่ชัดเจนมากกว่า

หลังจากนั้นทำการวิเคราะห์ชาตุบนพื้นผิวฟิล์มนิทินอล กราฟแสดงความสัมพันธ์ของค่า พลังงานสำหรับชาตุต่างๆแสดงดังภาพที่ 3.19 และภาพที่ 3.20 ซึ่งเป็นผลการวิเคราะห์ชาตุของ พื้นผิวฟิล์มนิทินอลที่ไม่ทำการอบและที่ทำการอบที่อุณหภูมิ 650 องศา ตามลำดับ จากกราฟทั้งสอง พบว่า พื้นผิวฟิล์มนิทินอลที่ไม่ทำการอบจะประกอบด้วยนิทินอลและไททาเนียมเป็นหลัก แต่ พื้นผิวของฟิล์มนิทินอลที่ทำการอบจะประกอบด้วยนิทินอล ไททาเนียมและมีออกซิเจนเพิ่มมากขึ้น

้ในการทคสอบพื้นผิวฟิล์มนิทินอลด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตเชิงพลังงานจะทำการวิเคราะห์ ธาตุของพื้นผิวฟิล์มนิทินอลอย่างละสามตำแหน่งที่ต่างกันแล้วนำผลการทคสอบมาทำการเฉลี่ย จาก ้การทดสอบพื้นผิวฟิล์มนิทินอลพบว่า อัตราส่วนของธาตุโดยเฉลี่ยของพื้นผิวฟิล์มนิทินอลที่ไม่ทำ การอบจะมี 38.9% ของไททาเนียมและ 61.1%ของนิกเกิลหลังจากทำการอบที่อุณหภูมิ 650 ้องศาเซลเซียสแล้วจะมี 38%ของไททาเนียม 33.5%ของนิกเกิลและ 28.5%ของออกซิเจน ซึ่ง ้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าในขั้นตอนการอบฟิล์มนิทินอลด้วยเตาอบแบบหลอดควอทซ์โดยมี ้ก๊าซอาร์กอนไหลผ่านจะมีปฏิกิริยาออกซิเคชั่นเกิดขึ้นระหว่างการอบหรืออีกนัยหนึ่งคือ การปล่อย ้ก๊าซอาร์กอนไหลผ่านไม่สามารถกำจัดก๊าซออกซิเจนภายในหลอดควอทซ์ได้หมด จึงทำให้ ้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นขึ้น นอกจากนี้เมื่อทำการพิจารณาอัตราส่วนระหว่างไททาเนียมกับนิกเกิล ้งองพื้นผิวฟิล์มนิทินอลที่ไม่ทำการอบกับพื้นผิวฟิล์มนิทินอลที่ทำการอบที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 30 นาที จะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนของธาตุโดยเฉลี่ยจาก Ti:Ni เป็น 38.9:61.1 ไปเป็น 53.1:46.9 ซึ่งจะเห็นได้ว่า นิกเกิลของพื้นผิวฟิล์มนิทินอลมีอัตราส่วนที่ลุคลง หลังจากทำการอบที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส สาเหตุหนึ่งที่มีความเป็นไปได้คือ นิกเกิลของ ้พื้นผิวฟิล์มนิทินอลอาจมีการแพร่ลงไปในโครงสร้างทองแคงจึงทำให้นิกเกิลบนพื้นผิวของฟิล์ม นิทินอลลคลง อีกทั้งยังมีการรวมตัวระหว่างนิกเกิลกับทองแคงซึ่งทำให้โครงสร้างนิกเกิลทองแคง ้เกิดขึ้น ซึ่งผลการทดสอบนี้สอดกล้องกับผลการทดสอบด้วยเครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของ รังสีเอ็กซ์ของไมโครแอคชั่วเอเตอร์ข้างต้น

นอกจากนั้นในงานวิจัยนี้ได้ทำการวิเคราะห์ธาตุของพื้นผิวฟิล์มนิทินอลด้านตัดขวาง (cross-section) ของไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่มีลักษณะเป็นคานสองชั้นที่ประกอบด้วยนิทินอลกับ ทองแดง ในการทดสอบนี้ทำการทดสอบไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ไม่ทำการอบและทำการอบที่ อุณหภูมิ 650 องสาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 30 นาที ตัวอย่างละ 2 ชิ้นเปรียบเทียบกันด้วย โดยจะทำ การวิเคราะห์ธาตุ ณ จุดบริเวณพื้นที่ด้านตัดขวางของฟิล์มนิทินอล ตัวอย่างละ 7 จุด โดยมีตำแหน่ง ในการวิเคราะห์ธาตุงองไมโครแอคชัวเอเตอร์ทั้งสองแบบห่างกันประมาณ 0.5 ไมโครเมตร ดังแสดงในภาพที่ 3.21(ก) และ ภาพที่ 3.21(ง) ตามลำดับ

กราฟแสดงความสัมพันธ์ของตำแหน่งที่ทำการวิเคราะห์ต่ออัตราส่วนของธาตุบนด้าน ตัดขวางของฟิล์มนิทินอลแสดงในภาพที่ 3.22 และ ภาพที่ 3.23 ซึ่งเป็นผลการทดสอบด้วย เครื่องวิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงานของไมโครแอกชัวเอเตอร์ที่ไม่ทำการอบและทำการอบที่ 650 องสาเซลเซียส ตามลำดับจากกราฟทั้งสองพบว่า พื้นผิวฟิล์มนิทินอลด้านตัดขวางของไมโครแอกชัว เอเตอร์ที่ไม่ทำการอบประกอบด้วยไททาเนียม นิกเกิลและออกซิเจนทั่วบริเวณที่ทำการวิเคราะห์ธาตุ และมีอัตราส่วนของไททาเนียมกับนิกเกิลที่ใกล้เคียงกันตลอดทั้งแนวตัดขวาง ในทางตรงกันข้าม ฟิล์มนิทินอลของไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการอบที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 30 นาทีจะประกอบด้วยไททาเนียม นิกเกิล ทองแดงและออกซิเจน โดยที่ออกซิเจนที่เกิดขึ้นจะมี ปริมาณที่มากกว่าพื้นผิวฟิล์มนิทินอลด้านขวางของไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ไม่ทำการอบ อีกทั้งใน ส่วนของทองแดงที่มีการแพร่เข้าไปในนิทินอลและมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเมื่อฟิล์มนิทินอลใกล้กับชั้น ทองแดง นอกจากนี้อัตราส่วนไททาเนียมและนิกเกิลของไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการอบที่ อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียสจะมีอัตราส่วนที่ไม่คงที่ โดยจุดที่ 1 และ 2 ฟิล์มนิทินอลจะมีอัตราส่วน ของนิกเกิลมากกว่าไททาเนียม แต่ตั้งแต่จุดที่ 3 ลงไป ฟิล์มนิทินอลจะมีอัตราส่วนของไททาเนียม มากกว่านิกเกิลแต่เป็นอัตราส่วนที่ไม่สม่ำเสมอ

จากผลการทดสอบด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงานทั้งบนพื้นผิวบนฟิล์มนิทินอลและ พื้นผิวฟิล์มนิทินอลด้านตัดขวางสามารถสรุปได้ว่า เมื่อทำการอบไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่มีลักษณะ เป็นคานสองชั้นที่ประกอบด้วยนิทินอลกับทองแดงที่อุณหภูมิสูงจะทำให้เกิดออกไซด์บนพื้นผิว มากขึ้น และยังทำให้ทองแดงแพร่เข้าไปในชั้นฟิล์มนิทินอลซึ่งอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลาย อย่างที่เกิดขึ้นอย่างไม่สม่ำเสมอ ตัวอย่างเช่น ออกซิเจนบนพื้นผิวของฟิล์มนิทินอลอาจเข้าไป รวมตัวกับไททาเนียมที่อุณหภูมิสูงทำให้เกิดโครงสร้างผลึกของไททาเนียมไดออกไซด์ขึ้นซึ่งอาจ ส่งผลทำให้พื้นผิวฟิล์มนิทินอลบริเวณนั้นมีอัตราส่วนของนิกเกิลที่มากกว่า หรือปรากฎการณ์ การแพร่ของทองแดงเข้าไปในชั้นฟิล์มนิทินอลและเข้าไปรวมตัวกับนิกเกิลทำให้เกิดโครงสร้าง ผลึกของนิกเกิลทองแดงขึ้นซึ่งอาจส่งผลทำให้พื้นผิวฟิล์มนิทินอลบริเวณนั้นมีอัตราส่วนของ ไททาเนียมมากกว่าเป็นต้น



ภาพที่ 3.18 พื้นผิวของฟิล์มนิทินอล (ก) ผิวฟิล์มนิทินอลที่ไม่ทำการอบ (ข) ผิวฟิล์มนิทินอลที่ทำ การอบที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส



ภาพที่ 3.19 ผลการทคสอบด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงานของฟิล์มนิทินอลที่ไม่ทำการอบ



ภาพที่ 3.20 ผลการทคสอบด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงานของฟิล์มนิทินอลที่ทำการอบที่ อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 30 นาที





ภาพที่ 3.21 แสดงตำแหน่งการทดสอบด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงานที่ด้านตัดขวางของ ใม โครแอกชัวเอเตอร์ (ก) ที่ไม่ทำการอบ (ข) ที่ทำการอบที่ 650 องศาเซลเซียส



ภาพที่ 3.22 อัตราส่วนของธาตุบนด้านตัดขวางของฟิล์มนิทินอลที่ไม่ทำการอบ ณ ตำแหน่งต่างๆ (ภาพที่ 3.21(ก))



ภาพที่ 3.23 อัตราส่วนของธาตุบนด้านตัดขวางของฟิล์มนิทินอลที่ทำการอบที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 30 นาที ณ ตำปหน่งต่างๆ (ภาพที่ 3.21(ข))

3.3.3 การทดสอบฟิล์มนิทินอลด้วยเครื่องวัดการถ่ายเทความร้อน

เครื่องวัดการถ่ายเทความร้อน (รายละเอียดการใช้งานแสดงในภาคผนวก ข) เป็นเครื่องที่ใช้ เทคนิคในการวิเคราะห์วัสดุด้วยการเปรียบเทียบค่าพลังงานที่ใช้เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของ สารตัวอย่างและสารมาตราฐานจากการวัดการถ่ายเทความร้อน โดยค่าพลังงานที่ใช้เปลี่ยนแปลง อุณหภูมิของทั้งสองสารจะมีค่าแตกต่างกันต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือการ เปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยพื้นที่ภายในกราฟของการทดสอบที่เกิดขึ้นจะมีความสัมพันธ์กับ การเปลี่ยนแปลงความร้อนและโครงสร้างภายในของสารตัวอย่างด้วยเช่นกัน

กราฟแสดงความสัมพันธ์ของอุณหภูมิที่ทำการทดสอบต่อก่าพลังงานความร้อนที่ เปรียบเทียบกับสารตัวอย่างของฟิล์มนิทินอลทำการเปรียบเทียบระหว่างฟิล์มนิทินอลที่ไม่ทำ การอบและทำการอบที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 30 นาทีแสดงในภาพที่ 3.24 และ กราฟแสดงความสัมพันธ์ของอุณหภูมิที่ทำการทดสอบต่อก่าพลังงานความร้อนที่เปรียบเทียบกับ สารตัวอย่างของฟิล์มนิทินอลที่ไม่ทำการอบและทำการอบที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียสเป็น ระยะเวลา 30 นาทีแสดงในภาพที่ 3.25(ก) และภาพที่ 3.25(ข) ตามลำคับ ซึ่งฟิล์มที่ใช้ในการ ทดสอบได้จากการสปัตเตอริงฟิล์มนิทินอลบนกระจกและเนื่องจากการยึดเกาะบนกระจกไม่ดีทำให้ สามารถลอกฟิล์มดังกล่าวออกมาได้ หลังจากนั้นจึงนำฟิล์มนิทินอลที่ลอกออกมาไปอบที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 30 นาทีและนำมาทดสอบด้วยเกรื่องวัดการถ่ายเทความร้อนนี้ เปรียบเทียบกับฟิล์มนิทินอลที่ไม่ทำการอบ

จากภาพที่ 3.24 พบว่าฟิล์มนิทินอลที่ทำการอบมีค่าพลังงานความร้อนในการเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิที่ต่ำกว่าค่าพลังงานความร้อนในการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของฟิล์มนิทินอลที่ไม่ทำการอบ เนื่องจากฟิล์มนิทินอลที่ทำการอบที่อุณหภูมิสูงฟิล์มนั้นจะมีสารประกอบอื่นเกิดขึ้นบนฟิล์มนิ ทินอล ตัวอย่างเช่น ไททาเนียมไดออกไซด์ นิกเกิลออกไซด์ เป็นต้นจึงทำให้ฟิล์มนิทินอลที่ทำการ อบมีค่าความจุความร้อนจำเพาะที่สูงกว่า เมื่อทำการทดสอบฟิล์มนิทินอลที่ทำการอบจะมีการคาย พลังงานมากกว่าฟิล์มนิทินอลที่ไม่ทำการอบจึงทำให้ฟิล์มนิทินอลที่ทำการอบมีความชันในกราฟที่ ติดลบมากกว่านั้นก็คือมีการใช้พลังงานในการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่น้อยกว่า

จากภาพที่ 3.25 พบว่าฟิล์มนิทินอลที่ไม่ทำการอบมีช่วงอุณหภูมิในการเปลี่ยนแปลง โกรงสร้างภายในอยู่ในช่วง -82.40 องศาเซลเซียสและ 76.51 องศาเซลเซียส ในทางตรงกันข้าม ฟิล์มนิทินอลที่ทำการอบจะมีช่วงอุณหภูมิในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในอยู่ใน ช่วง -107.96 องศาเซลเซียสและสิ้นสุด 97.75 องศาเซลเซียสซึ่งจะเห็นได้ว่า ฟิล์มทั้งสองชนิคมี ช่วงอุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงค่าพลังงานอยู่ในช่วงที่ใกล้เคียงกันแต่ฟิล์มนิทินอลที่ทำการอบจะมี ค่าพลังงานที่น้อยกว่า โดยพื้นที่ภายในกราฟของฟิล์มนิทินอลที่ทำการอบจะมีพื้นที่มากกว่าพื้นที่ ภายในกราฟของฟิล์มนิทินอลที่ไม่ทำการอบซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ภายในกราฟถึง 60% เนื่องจากฟิล์มนิทินอลที่ทำการอบที่อุณหภูมิสูงจะทำให้มีโครงสร้างผลึกนิทินอลมากขึ้น เมื่อทำการ ทดสอบฟิล์มนิทินอลที่ทำการอบจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในมากกว่าฟิล์มนิทินอลที่ไม่ ทำการอบถึง 60%

จากผลการทดสอบสามารถสรุปได้ว่าฟิล์มนิทินอลที่ทำการอบที่อุณหภูมิ 650 องสาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 30 นาทีจะใช้พลังงานในเพิ่มอุณหภูมิน้อยกว่าฟิล์มนิทินอลที่ไม่ทำ การอบเนื่องจากหลังจากการอบที่อุณหภูมิสูงฟิล์มนิทินอลจะมีโครงสร้างผลึกที่มากกว่าฟิล์ม นิทินอลถึง 60% โดยที่ฟิล์มนิทินอลที่ทำการอบจะมีการกายพลังงานจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ จึงทำให้ใช้พลังงานที่น้อยกว่าเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ โดยผลการทดสอบด้วยเครื่องวัด การถ่ายเทความร้อนนี้จะมีผลที่สอดกล้องกับผลการทดสอบด้วยเกรื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของ รังสีเอ็กซ์และเครื่องวิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงานคือ ฟิล์มนิทินอลที่ทำการอบที่อุณหภูมิสูงจะมี โครงสร้างผลึกที่มากกว่าจึงจำเป็นด้องใช้ก่าพลังงานที่สูงในการเปลี่ยนอุณหภูมิ แต่ช่วงอุณหภูมิที่มี การเปลี่ยนแปลงก่าพลังงานจะเริ่มตั้งแต่อุณหภูมิที่ต่ำกว่าอุณหภูมิห้องและสิ้นสุดที่อุณหภูมิสูงกว่า อุณหภูมิห้องซึ่งเป็นกุณสมบัติของนิทินอลที่มีอัตราส่วนของนิกเกิลมากกว่าไททาเนียม (Ni-rich)



ภาพที่ 3.24 ผลทคสอบเปรียบเทียบการถ่ายเทความร้อนของฟิล์มนิทินอลที่ไม่ทำการอบและ ทำการอบที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 30 นาที


ภาพที่ 3.25 ผลการทคสอบการถ่ายเทความร้อนของฟิล์มนิทินอล (ก) ที่ไม่ทำการอบ (ข) ที่ทำการอบที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 30 นาที

3.4 สรุปผลการสร้างใมโครแอคชั่วเอเตอร์แบบใหม่

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการเสนอกระบวนการสร้างไมโครแอคชัวเอเตอร์แบบใหม่โดยไม่ใช้ แผ่นซิลิกอนโดยประกอบด้วยกระบวนการในการสร้างเพียงสองขั้นตอนหลักคือ กระบวนการ สร้างโครงสร้างทองแดงแบบลอยตัวและกระบวนการเคลือบผิวด้านบนของโครงสร้างทองแดง แบบลอยตัวด้วยนิทินอล ซึ่งรายละเอียดในการสร้างไมโครแอกชัวเอเตอร์แบบโลหะผสมจำรูปที่มี ลักษณะเป็นคานสองชั้นได้แสดงไว้ในตารางที่ 3.3 ถึงตารางที่ 3.5 นอกจากนี้ได้ทำการศึกษาเพื่อหา พารามิเตอร์ที่เหมาะสม ข้อจำกัดต่างๆร่วมทั้งข้อเสนอแนะในกระบวนการสร้างไมโครแอกชัวเอเตอร์ แบบใหม่โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

- ขั้นตอนการสร้างแบบหล่อมีก่าความผิดพลาดในการสร้างแบบหล่อ 1% โดยเปรียบเทียบ จากงนาดงองไมโครแอคชัวเอเตอร์บนแผ่นลวดลายกับงนาดไมโครแอคชัวเอเตอร์บน แบบหล่อซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานต่อได้ดี แต่อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้แนะนำให้ เปลี่ยนโปรแกรมในการวาดลวดลาย เนื่องจากโปรแกรม solid work อาจจะเป็นโปรแกรม ที่ไม่เหมาะสมสำหรับการวาดลวดลายในระดับไมโครสเกล ซึ่งจากการตรวจวัดจะมี ค่าความผิดพลาดในการออกแบบ 320% จากกงนาดที่ตั้งใจออกแบบไว้
- 2. ขั้นตอนการชุบโลหะด้วยกระบวนการไฟฟ้าเคมีด้องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่ำกว่า 0.5 แอมแปร์ สำหรับระยะห่างระหว่างขั้วแกโทดและแอโนดเท่ากับ 14 เซนติเมตรเพื่อลดความเล้นที่จะ เกิดขึ้นระหว่างการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าเคมีและลดความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายต่อ ใมโครแอคชัวเอเตอร์ สำหรับในงานวิจัยนี้สามารถสร้างโครงสร้างทองแดงตามที่ต้องการ ใด้โดยใช้พารามิเตอร์ต่างๆดังนี้คือ ค่ากระแสไฟฟ้าต่อหน่วยพื้นที่เท่ากับ 44.1 มิลลิแอมแปร์ต่อตารางเซนติเมตร ซึ่งมีอัตราการปลูกฟิล์มของทองแดงเท่ากับ 9.82 ใมโครเมตรต่อชั่วโมง และโครงสร้างทองแดงแบบลอยตัวที่สร้างได้มีโครงสร้างที่แข็งแรง และมีความหนาที่เหมาะสมสำหรับนำมาใช้งาน
- ขั้นตอนการเกลือบผิวด้วยนิทินอล (Ti:Ni = 50:50) สามารถสร้างฟิล์มนิทินอลที่มีความ หนาเท่ากับ 5.8 ไมโครเมตร โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.4 ไมโครเมตร จากค่าความ เบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่า ในขั้นตอนการเกลือบผิวด้วยนิทินอลทำให้เกิดฟิล์มนิทินอล ที่ไม่สม่ำเสมอ แต่อย่างไรก็ตามฟิล์มนิทินอลที่ทำการปลูกบนโครงสร้างทองแดงมีการยึด ติดที่ดี โดยมีนิกเกิลเป็นธาตุส่วนใหญ่ในฟิล์มนิทินอล

4. การอบฟิล์มนิทินอลด้วยเตาอบแบบหลอดควอทซ์โดยมีก๊าซอาร์กอนไหลผ่านที่อุณหภูมิ 600 และ 650 องสาเซลเซียสเป็นเวลา 30 นาที สามารถทำให้โครงสร้างของนิทินอลเปลี่ยน จากอมอฟัสเป็นโครงสร้างผลึกได้และมีแนวโน้มที่โครงสร้างผลึกจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อทำ การอบที่อุณหภูมิสูงขึ้น นอกจากนี้เมื่อทำการเปรียบเทียบฟิล์มนิทินอลที่ไม่ทำการอบกับ ทำการอบที่อุณหภูมิสูง จะเห็นได้ว่า ฟิล์มนิทินอลที่ทำการอบที่อุณหภูมิสูงจะมีโครงสร้าง ผลึกของนิทินอลที่มากกว่านิทินอลที่ไม่ทำการอบ อัตราส่วนของธาตุของฟิล์มนิทินอลที่ ทำการอบจะเปลี่ยนไปโดยจะมีออกซิเจนและทองแดงเกิดขึ้นในฟิล์มนิทินอล ซึ่งทองแดง รวมตัวกับนิกเกิลในชั้นฟิล์มนิทินอลจะส่งผลทำให้มีสมบัติในการถ่ายเทความร้อนที่ดีขึ้น

| a | 9/ | ~ ¥ | v | |
|-----------------------|------------------|---|--------------------------------|----|
| <u>ຕາ ຕາ ຈາທີ 7 7</u> | ດແຜ່ງປາງເຄາແຜ່ຊາ | າໄລຮາຜ'ະາ | 990 ລ 911 ລ 911 9191 ລ ລ ຍເສ / | h |
| 9113 INVE 3.3 | 11401144114614 | 1 | | d. |
| | | | | - |

| ขั้นตอน | รายละเอียด | จุดประสงค์ | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| 1. การเตรียมแผ่น | กระดาษทรายน้ำที่ใช้ในการขัด โดย | เพื่อลดพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่าง | | |
| สเตนเลส | เริ่มจากเบอร์หยาบไปจนถึงเบอร์ | ทองแคงกับแผ่นสเตนเลส | | |
| | ละเอียด (เบอร์ 800, 1000, 1200, | | | |
| | 1500 และ 2000 ตามลำคับ), | | | |
| | แผ่นสเตนเลสมีก่ากวามขรุขระ | | | |
| | เท่ากับ 0.112 ใมโกรเมตร | | | |
| 2. การติดฟิล์มโฟโด้ | อุณหภูมิเครื่องรีคฟิล์มไวแสง 90 | เพื่อทำให้โฟโด้รีซิสติคกับ | | |
| ริซิส | องศาเซลเซียส | แผ่นสเตนเลสได้ดีขึ้น | | |
| 3. การสร้างแบบหล่อ | | | | |
| - ฉายแสงยูวี | ฉายแสงยูวีด้วยกล่องฉายยูวี 20 | เพื่อให้ส่วนที่ถูกแสงไม่ทำปฏิกิริยา | | |
| | วินาที | กับสารละลายโซเดียม | | |
| | | ใบการ์บอเนต | | |
| - ถ้างโฟโต้รีซิสด้วย | อัตราส่วนผสมของสารละลาย | เพื่อกำจัดโฟโต้รีซิสที่ไม่ถูกแสง | | |
| สารละลายโซเคียม | โซเดียมใบการ์บอเนต | ออก | | |
| ใบคาร์บอเนต | 1กรัม:น้ำ 100 มิลลิลิตร | | | |
| - อบ | อุณหภูมิบนเครื่องฮอตแพลต 120 | เพื่อระเหยน้ำที่อยู่บนแผ่นสเตนเลส | | |
| | องศาเซลเซียสเป็นเวลา 7 นาที | ออกและเป็นการทำให้ฟิล์ม | | |
| | | โฟโต้รีซิสแข็งตัวและยึดติดกับ | | |
| | | แผ่นสเตนเลสได้ดีขึ้น | | |
| 4. การชุบโลหะด้วยกระบ | วนการไฟฟ้าเคมี | | | |
| - กำหนดค่า | ใช้กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 0.5 | เพื่อปลูกฟิล์มทองแคงลงบน | | |
| กระแสไฟฟ้า | แอมแปร์ ที่ระยะห่างระหว่างขั้ว | แผ่นสเตนเลส | | |
| | แคโทคและแอโนคเท่ากับ 14 | | | |
| | เซนติเมตร | | | |
| - ถ้างโฟโต้รีซิสด้วย | ความเข้มข้นของสารละลาย | | | |
| สารละลายโซเคียม | โซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 0.5 | | | |
| ไฮครอกไซค์ | โมลาร์ | | | |

ตารางที่ 3.4 ขั้นตอนการเกลือบผิวด้วยนิทินอล

| ขั้นตอน | รายละเอียด |
|---------------------------------------|---|
| 1. ลดความคันภายในเครื่องสปัตเตอริง | ความคันภายในเครื่องสปัตเตอริง 10⁻๎ มิลลิบาร์ |
| 2. ปล่อยก๊าซอาร์กอนเข้าไปใน | หลังจากปล่อยก๊าซอาร์กอนความคันภายใน |
| เกรื่องสปัตเตอริง | เครื่องสปัตเตอริงเท่ากับ 3x10 ⁻³ มิลลิบาร์ |
| 3. ทำความสะอาคชิ้นงาน | เปิด RF clean ที่กำลัง 75 วัตต์ เป็นเวลา 5 นาที |
| 4. ทำความสะอาดแผ่นทินินอล (nitinol | เปิด DC magnetron sputtering ด้วยกระแสไฟฟ้า |
| target) | 0.2 แอมแปร์ เป็นเวลา 5 นาที หลังจากนั้นเปิด |
| | ชัตเตอร์เกท |
| 5. สร้างฟิล์มนิทินอลบนโครงสร้างทองแคง | อัตราการปลูกฟิล์มของนิทินอล 1 ใมโครเมตรต่อ |
| ลอยตัว | 1 ชั่วโมง |

ตารางที่ 3.5 ขั้นตอนการอบฟิล์มนิทินอล

| ขั้นตอน | รายละเอียด |
|--------------------------------------|--|
| 1. นำไมโครแอคชั่วเอเตอร์เข้ำเตาอบแบบ | นำใมโครแอคชั่วเอเตอร์วางภายในแบบหล่อ |
| หลอดควอทซ์ | คอนกรีตแล้วนำเข้าไปวางไว้บริเวณตรงกลาง |
| | เตาอบ |
| 2. ทำการกำจัดอากาศภายในหลอดควอทซ์ | เปิดปั้มดูดทำให้ภายในหลอดกวอทซ์มีกวามดัน |
| (ซ้ำ 3 รอบ) | เป็นลบ หลังจากนั้นทำปิดปั๊มดูดแล้วทำการปล่อย |
| | ถ้าซอาร์กอนเข้าไปในหลอดควอทซ์ทำให้ความ |
| | ดันภายในหลอดควอทซ์เป็นบวก จากนั้นหยุด |
| | ปล่อยก๊าซอาร์กอนแล้วทำการเปิดปั๊มดูคเพื่อทำซ้ำ |
| | โดยทำซ้ำ 3 รอบ |
| 3. ทำการปล่อยก๊าซอาร์กอนตลอดขั้นตอน | ปล่อยก๊าซอาร์กอนให้ความคันภายในหลอค |
| การอบ | ควอทซ์เป็นบวกตลอดขั้นตอนการอบ |
| 4. ทำการอบฟิล์มนิทินอล | ใช้อัตราการเพิ่มอุณหภูมิที่ 10 องศาเซลเซียสต่อ 1 |
| | นาที และทำการรักษาที่อุณหภูมิเป้าหมาย 30 นาที |
| | จากนั้นทำการปิคเตาอบ รอจนอุณหภูมิเย็นลงแล้ว |
| | จึงนำไมโครแอคชั่วเอเตอร์ออกจากเตาอบ |

บทที่ 4 การทดสอบไมโครแอคชัวเอเตอร์

งานวิจัยนี้ทำการสร้างไมโครแอคชัวเอเตอร์แบบโลหะผสมจำรูปที่มีลักษณะเป็นคาน สองชั้นที่ประกอบด้วยนิทินอลกับทองแดงซ้อนทับกัน และมีความหนา 5.8 และ 12.2 ไมโครเมตร ตามลำคับ ซึ่งวิธีการสร้างไมโครแอคชัวเอเตอร์แบบใหม่นี้มีการนำเทคนิคการชุบโลหะด้วย ไฟฟ้าเคมีและเทคนิคการสปัตเตอริงมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการสร้างโดยไมโครแอคชัวเอเตอร์ แบบโลหะผสมจำรูปที่มีลักษณะเป็นคานสองชั้นที่สร้างขึ้นจะมีลักษณะจะมีรูปร่างคล้ายตัวยูคว่ำ ประกอบด้วยขาของไมโครแอคชัวเอเตอร์ 2 ข้างขนาคกว้าง 0.25 มิลลิเมตร ยาว 22 มิลลิเมตรและ ส่วนปลายและส่วนฐาน มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 3 มิลลิเมตร

ในบทนี้จะทำการทดสอบไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ได้ทำการสร้างขึ้น โดยไมโครแอคชัวเอเตอร์ ที่นำมาทดสอบนี้จะเป็นไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ไม่ทำการอบและไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการอบ ฟิล์มนิทินอลที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 30 นาที ในแบบหล่อคอนกรีตที่มีลักษณะ แตกต่างกันสองลักษณะคือ แบบหล่อคอนกรีตที่มีลักษณะแบนราบและแบบหล่อคอนกรีตที่มี ลักษณะโค้ง (รัศมีความโค้งเท่ากับ 22 มิลลิเมตร) โดยจะทำการทดสอบไมโครแอคชัวเอเตอร์ ชนิดละ 2 ชิ้นงาน แล้วนำผลการทดสอบที่ได้มาทำการเฉลี่ยในแต่ละชนิดและนำมาใช้เปรียบเทียบ คุณสมบัติเชิงกลของไมโครแอคชัวเอเตอร์ทั้งสามแบบ

ในการทดสอบไมโครแอคชัวเอเตอร์ทำการประกอบไมโครแอคชัวเอเตอร์เพื่อทำให้มี กวามสะดวกในการทดสอบโดยจะทำการจับยึดไมโครแอคชัวเอเตอร์ด้วยกระจก (glass slide) 2 แผ่นประกอบติดกับไมโครแอคชัวเอเตอร์ให้ได้ความยาว 22.5 มิลลิเมตร ซึ่งกระจกได้ใช้การกัด ด้วย HF เพื่อเซาะร่องบนกระจกให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ หลังจากนั้นจึงนำกระจกสองแผ่นมาจับ ยึดชิ้นงานคล้ายแซนวิช พร้อมทั้งใช้ตัวหนีบช่วยในการจับยึดเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของอุปกรณ์ ลักษณะในการจับยึดไมโครแอคชัวเอเตอร์นี้แสดงดังภาพที่ 4.1 ในงานวิจัยนี้จะทำการทดสอบ ไมโครแอคชัวเอเตอร์ด้วยการวัดระยะกระดกของไมโครแอคชัวเอเตอร์และความเร็วในการ ตอบสนองของไมโครแอคชัวเอเตอร์ ในการทดสอบไมโครแอคชัวเอเตอร์นี้จะแบ่งการทดสอบเป็น สองส่วนคือ การทดสอบการตอบสนองเชิงสถิตย์ (static test) และการทดสอบการตอบสนอง เชิงจลน์ (dynamic test)



ภาพที่ 4.1 ลักษณะในการจับยึดไมโครแอคชั่วเอเตอร์สำหรับในการทดสอบ

4.1 การทดสอบการตอบสนองเชิงสถิตย์

การทดสอบการตอบสนองเชิงสถิตย์ในงานวิจัยนี้จะทำการวัดระยะกระดกและทำการวัด อุณหภูมิของไมโครแอคชัวเอเตอร์แบบโลหะผสมจำรูปในขณะที่ทำการใส่ความร้อนให้กับ ไมโครแอคชัวเอเตอร์เพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้น สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบการตอบสนอง เชิงสถิตย์แสดงดังภาพที่ 4.2 (รายละเอียดการใช้งานแสดงในภากผนวก ง) ซึ่งประกอบด้วยเครื่อง ฮอตเพลต เครื่องออสซิลโลสโคป เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์และมิเตอร์พร้อมทั้งเครื่อง จ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์และอินฟาเรคเทอร์โมมิเตอร์

ในการทดสอบนี้จะทำการต่ออุปกรณ์ต่างๆและทำการติดตั้งไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำ การจับยึดด้วยกระจกแล้วบนเครื่องฮอตเพลต หลังจากนั้นทำการเปิดเครื่องฮอตเพลตเพื่อทำการเพิ่ม กวามร้อนให้กับไมโครแอคชัวเอเตอร์โดยตรงและทำการวัดระยะกระดกของไมโกรแอคชัวเอเตอร์ ด้วยเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์มิเตอร์ที่ติดตั้งไว้ด้านบนของไมโครแอคชัวเอเตอร์และต่อเข้ากับ ตัวเลเซอร์มิเตอร์ ซึ่งสามารถอ่านระยะกระคกได้จากหน้าจอของมิเตอร์และบันทึกข้อมูลใน เครื่องออสซิลสโคปได้ นอกจากนั้นในการทดสอบนี้จะทำการวัดอุณหภูมิของไมโครแอคชัวเอเตอร์ ด้วยอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ด้วย โดยทำการวัดที่บริเวณปลายของไมโครแอคชัวเอเตอร์ เพราะ หากทำการวัดอุณหภูมิของไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่บริเวณฐานที่ทำการยึดติดกับแผ่นกระจก จะเป็น การวัดอุณหภูมิแผ่นกระจกแทน เนื่องจากแผ่นกระจกมีอัตราการแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศ ภายนอกที่ช้าและมีการเก็บสะสมความร้อนได้ดี จึงทำให้มีการถ่ายเทความร้อนให้กับฐานของ ไมโกรแอคชัวเอเตอร์ตลอดเวลา และทำให้บริเวณฐานของไมโครแอคชัวเอเตอร์มีอุณหภูมิเท่ากับ อุณหภูมิของแผ่นกระจก ข้อมูลของอุณหภูมิจะถูกส่งไปบันทึกข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการทดสอบการตอบสนองเชิงสถิตย์มีความแม่นยำในการวัดระยะกระดกของไมโครแอคชัวเอเตอร์ อยู่ที่ 0.5 ไมโครเมตร และมีความเร็วในการเก็บข้อมูลอยู่ที่ 1,000 ค่าต่อไมโครวินาที และมี ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิของไมโครแอคชัวเอเตอร์อยู่ที่ 0.1 องศาเซลเซียส และมีความเร็วใน การเก็บข้อมูลอยู่ที่ 10 ค่าต่อวินาที



ภาพที่ 4.2 อุปกรณ์ในการทคสอบการตอบสนองเชิงสถิติ

การทดสอบการตอบสนองเชิงสถิตย์ในงานวิจัยนี้จะทำการเพิ่มอุณหภูมิให้กับ ใมโครแอคชัวเอเตอร์โดยตรงด้วยเครื่องฮอตแพลต ที่อัตราการเพิ่มของอุณหภูมิเท่ากับ 2 องสาเซลเซียสต่อวินาที พร้อมทั้งทำการวัดระยะกระดกของไมโครแอคชัวเอเตอร์แล้วเก็บค่า ระยะกระดกในออสซิลโลสโคปและทำการวัดอุณหภูมิของไมโครแอคชัวเอเตอร์แล้วเก็บค่า อุณหภูมิในคอมพิวเตอร์ หลังจากทำการทดสอบเสร็จสิ้นจึงดึงข้อมูลมาวิเคราะห์ผ่านแฟลชไคร์ฟ และนำไปเปิดด้วยโปรแกรมเอ็กเซล ทำการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและพล๊อตกราฟของ ระยะกระดกของไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่อุณหภูมิต่างๆ ภาพถ่ายของการกระดกของ ไมโครแอคชัวเอเตอร์ต่างๆหลังจากทำการเพิ่มอุณหภูมิได้แสดงในภาพที่ 4.3

กราฟแสดงความสัมพันธ์ของอุณหภูมิของไมโครแอคชั่วเตอร์ต่อระยะกระดกของ ใมโครแอกชั่วเอเตอร์แสดงดังภาพที่ 4.4(ก) ถึงภาพที่ 4.4(ค) ซึ่งเป็นผลการทดสอบการตอบสนอง เชิงสถิตย์ที่ได้ทำการเฉลี่ยทั้งสองชิ้นงานของไมโครแอกชั่วเอเตอร์ที่ไม่ทำการอบ ใมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการอบด้วยแบบหล่อคอนกรีตที่มีลักษณะแบบราบและ ใมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการอบด้วยแบบหล่อคอนกรีตที่มีลักษณะโค้ง ตามลำดับ จากผล การทคสอบพบว่า เมื่อทำการเพิ่มอุณหภูมิให้กับไมโครแอคชัวเอเตอร์ ไมโครแอคชัวเอเตอร์จะเกิด การกระดกขึ้นไปในทิศทางของนิทินอล และเมื่อไมโครแอคชัวเอเตอร์มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทำให้ ระยะกระดกของไมโครแอคชัวเอเตอร์สูงขึ้นเช่นกัน ในทางตรงกันข้ามเมื่อทำการหยุดให้ความร้อน กับไมโครแอคชัวเอเตอร์อุณหภูมิของไมโครแอคชัวเอเตอร์จะลดลง ไมโครแอคชัวเอเตอร์จะมี ระยะกระดกที่ลดลง แต่จากกราฟทั้งสามจะปรากฎฮิสเตอร์ริซิส (hysteresis) ขึ้น โดยที่ ค่าฮิสเตอร์ริซิสของไมโครแอคชัวเอเตอร์แต่ละชนิดมีก่าดังนี้ ค่าฮิสเตอร์ริซิสสูงสุดของ ระยะกระดกของไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ไม่ทำการอบเท่ากับ 0.23 มิลลิเมตร ก่าฮิสเตอร์ริซิสของ ระยะกระดกไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการอบด้วยแบบหล่อที่มีลักษณะแบนราบและโค้งเท่ากับ 0.46 และ 0.33 มิลลิเมตร ตามลำดับ

กราฟแสดงกวามสัมพันธ์ของอุณหภูมิของไมโกรแอกชัวเอเตอร์แต่ละชนิดต่อระยะกระดก ของไมโกรแอกชัวเอเตอร์ในช่วงอุณหภูมิเพิ่มขึ้นถึง 80 องสาเซลเซียสแสดงดังภาพที่ 4.5 จะเห็นได้ ว่าเมื่อทำการเปรียบเทียบระยะกระดกของไมโกรแอกชัวเอเตอร์แต่ละชนิดที่อุณหภูมิที่เท่ากัน ไมโกรแอกชัวเอเตอร์ที่ทำการอบที่อุณหภูมิ 650 องสาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 30 นาที จะมี ระยะกระดกที่สูงกว่าไมโครแอกชัวเอเตอร์ที่ไม่ทำการอบอย่างเห็นได้ชัดเจน เนื่องจาก ไมโกรแอกชัวเอเตอร์ที่ทำการอบจะมีโกรงสร้างผลึกของนิทินอลที่มากกว่าไมโครแอกชัวเอเตอร์ที่ ใม่อบ ทำให้ไมโกรแอกชัวเอเตอร์ที่ทำการอบจะมีคุณสมบัติการเปลี่ยนรูปและกืนรูปได้ของ นิทินอลเกิดขึ้นดีกว่า จึงทำให้ก่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวของนิทินอลกับทองแดงยิ่งมีความแตกต่าง กันมากขึ้น และมีผลโดยตรงต่อกวามสามารถในการกระดกของไมโครแอกชัวเอเตอร์แบบ โลหะผสมจำรูปที่มีลักษณะเป็นกานสองชั้นนี้

จากผลการทดสอบได้ทำการเปรียบเทียบระยะกระดกของไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำ การอบด้วยแบบหล่อคอนกรีตที่มีลักษณะแบนราบกับไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการอบด้วย แบบหล่อคอนกรีตที่มีลักษณะโก้งจะเห็นได้ว่าระยะกระดกของไมโครแอคชัวเอเตอร์ทั้งสองชนิดนี้ มีระยะกระดกที่ใกล้เกียงกันโดยที่ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการอบโดยใช้แบบหล่อคอนกรีตที่มี ลักษณะแบนราบจะมีระยะกระดกสูงกว่าเพียงเล็กน้อย และที่อุณหภูมิของไมโครแอคชัวเอเตอร์ เท่ากับ 80 องศาเซลเซียสจะทำให้ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ไม่ทำการอบไมโครแอคชัวเอเตอร์ กี่ทำ การอบด้วยแบบหล่อที่มีลักษณะแบนราบและโค้งมีระยะกระดกเท่ากับ 0.57, 0.94 และ 0.84 มิลลิเมตร ตามลำดับ นอกจากนั้นงานวิจัยนี้ได้ทำการเปรียบเทียบระยะกระดกของไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำ การอบที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 30 นาทีกับระยะกระดกของคานจากระเบียบวิธี การไฟในต์อิลิเมนต์ที่ความหนาของทองแดงและอุณหภูมิของไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ใกล้เคียงกัน จะเห็นได้ว่าระยะกระดกของคานจากระเบียบวิธีการไฟในต์อิลิเมนต์จะมีค่าที่สูงกว่าระยะกระดก ของไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการอบในการทดสอบประมาณ 150% เนื่องจากฟิล์มนิทินอลที่สร้าง ขึ้นอาจจะมีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนที่น้อยกว่าในการศึกษาในบทที่ 2 ดังนั้นจึงทำ ให้ระยะกระดกในการทดสอบจึงมีค่าที่น้อยกว่าระยะกระดกจากระเบียบวิธีการไฟไนต์อิลิเมนต์

4.2 สรุปผลการทดสอบการตอบสนองเชิงสถิตย์

ในการทดสอบการตอบสนองเชิงสถิตย์นี้จะทำการเพิ่มอุณหภูมิให้กับไมโครแอคชัวเอเตอร์ โดยตรง พร้อมด้วยทำการวัดระยะกระดกและทำการวัดอุณหภูมิของไมโครแอคชัวเอเตอร์ โดยมี ความแม่นยำในการวัดระยะกระดกของไมโครแอคชัวเอเตอร์อยู่ที่ 0.5 ไมโครแมตร และมีความเร็ว ในการเก็บข้อมูลอยู่ที่ 1,000 ด่าต่อไมโครวินาที และมีความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิของ ไมโครแอคชัวเอเตอร์อยู่ที่ 0.1 องสาเซลเซียส และมีความเร็วในการเก็บข้อมูลอยู่ที่ 10 ค่าต่อวินาที จากผลการทดสอบสามารถสรุปได้ว่า ขั้นตอนการอบฟิล์มนิทินอลมีผลต่อระยะกระดกของ ไมโครแอคชัวเอเตอร์ โดยที่ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการอบจะมีระยะกระดกที่สูงกว่า แต่อย่างไร ก็ตามลักษณะในการอบด้วยแบบหล่อคอนกรีตที่มีลักษณะแบนราบกับโก้งจะมีผลเพียงเล็กน้อยต่อ ระยะกระดกของไมโครแอคชัวเอเตอร์ นอกจากนี้ในการทดสอบการตอบสนองเชิงสถิตย์พบว่า ขณะที่ทำการเพิ่มอุณหภูมิให้กับไมโครแอคชัวเอเตอร์ด้วยเครื่องฮอตเพลต ไมโครแอคชัวเอเตอร์จะ มีการแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาสภายนอกด้วยซึ่งส่งผลทำให้ไมโครแอคชัวเอเตอร์จะเกิด การสั่นขึ้นลงด้วยระยะกระดกน้อยเมื่อเทียบกับการเคลื่อนที่ของไมโครแอคชัวเอเตอร์อย่างรวดเร็ว

ตารางที่ 4.1 แสดงการเพิ่มพลังงานให้กับขาของไมโครแอกชัวเอเตอร์จากการกำนวณการ ถ่ายเทความร้อนของขาของไมโครแอกชัวเอเตอร์ในกรณีต่างๆพบว่า การเพิ่มอุณหภูมิให้กับ ไมโครแอกชัวเอเตอร์ด้วยเครื่องฮอตเพลตนี้มีก่าความร้อนที่ถ่ายเทให้กับขาของไมโครแอกชัวเอเตอร์ เท่ากับ 0.51 วัตต์ และความร้อนที่แลกเปลี่ยนกับอากาศภายนอกเท่ากับ 24 วัตต์ จะเห็นได้ว่ามี ความแตกต่างกันถึง 47 เท่า ซึ่งเมื่อทำการเพิ่มพลังงานให้กับขาของไมโครแอกชัวเอเตอร์ด้วย เครื่องฮอตเพลตแล้วไมโครแอกชัวเอเตอร์จะกระดกขึ้น แต่ในช่วงเวลาสั้นๆถัดมาขาของ ไมโครแอกชัวเอเตอร์จะแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศภายนอกทันทีจึงทำให้อุณหภูมิของ ใมโครแอกชัวเอเตอร์ลดลงและตัวไมโครแอกชัวเอเตอร์จึงกระดกลง ซึ่งกระบวนการใน การถ่ายเทแลกเปลี่ยนความร้อนของขาของไมโครแอกชัวเอเตอร์จะเกิดขึ้นพร้อมๆกัน จึงทำให้ ใมโครแอคชัวเอเตอร์เกิดการสั่นขึ้นลงด้วยระยะทางสั้นๆอย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตามใน การทดสอบการตอบสนองเชิงสถิตย์นี้สามารถหาแนวโน้มและความสัมพันธ์ระหว่างระยะกระดก ของไมโกรแอคชัวเอเตอร์กับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของไมโกรแอคชัวเอเตอร์ได้



(ก)



(ป)



ภาพที่ 4.3 ลักษณะการกระคกของไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่อุณหภูมิ 25 และ 90 องศาเซลเซียส (ก) ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ไม่ทำการอบ (ข) ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการอบด้วยแบบหล่อที่มี ลักษณะแบนราบ (ค) ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการอบด้วยแบบหล่อที่มีลักษณะโค้ง



ภาพที่ 4.4 ระยะกระดกของไมโครแอคชัวเอเตอร์เมื่อทำการเพิ่ม-ลดอุณหภูมิด้วยเกรื่องฮอตเพลต (ก) ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ไม่ทำการอบ (ข) ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการอบด้วยแบบหล่อที่มี ลักษณะแบนราบ (ก) ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการอบด้วยแบบหล่อที่มีลักษณะโค้ง



ภาพที่ 4.5 การเปรียบเทียบระยะกระคกต่ออุณหภูมิของไมโครแอคชัวเอเตอร์แบบต่างๆ

| ตารางที่ 4.1 | การเปรียบเที | ยบความร้อนเ | ี ่ถ่ายเทระห | ว่างขาของ | ไมโครแอค | เช้วเอเตอร์เ | กับฮอตเพลต |
|--------------|--------------|-------------|---------------------|-----------|----------|--------------|------------|
| และอากาศภ | ายนอก | | | | | | |

| | Generated energy by hot plate, Static test | Force convection heat transfer, Static test | Generated energy by applied current, Dynamic test |
|--------------------------------------|---|--|---|
| Formula | $q = \frac{mc_p \Delta T}{t}$ | $q = hA\Delta T$ | $q = I^2 R$ |
| Room temperature (°C) | | 20 | |
| Heat transfer (mW) | 0.51 | -24 | 78 |
| หมายเหตุ: c _p = 1.22x10-3 | $h = 100 \text{ W/m}^2.\text{K}$ | $T_{actautor} = 82.7 \ ^{\circ}C$ | $R = 0.137 \Omega$ |
| m = 0.557 mg | $A = 3.9 \text{ mm}^2$ | $T_{room} = 20 \text{ oC}$ | I = 0.75 A |

4.3 การทดสอบการตอบสนองเชิงจลน์

การทดสอบการตอบสนองเชิงจลน์ในงานวิจัยนี้จะทำการวัดระยะกระดกของ ใมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ไม่ทำการอบและทำการอบที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 30 นาที ที่ลักษณะการอบต่างๆ ในการทำการทดลองจะจ่ายกระแสไฟฟ้าที่มีรูปคลื่นสี่เหลี่ยมที่ความถึ่ ต่างๆ สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบการตอบสนองเชิงจลน์แสดงดังภาพที่ 4.6 (รายละเอียด การใช้งานแสดงในภาคผนวก ง) ซึ่งประกอบด้วยเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับไมโกรแอกชัวเอเตอร์ เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า เครื่องออสซิลโลสโคป เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์และมิเตอร์พร้อม ทั้งเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์

ในการทดสอบนี้จะทำการต่ออุปกรณ์ต่างๆและทำการติดตั้งไมโครแอกชัวเอเตอร์ที่ทำ การยึดจับด้วยกระจกแล้วบนฐาน หลังจากนั้นทำการทดสอบโดยการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ ใมโครแอกชัวเอเตอร์โดยมีการเปลี่ยนแปลงก่ากระแสไฟฟ้า 4 ก่าคือ 0.50, 0.75, 1.00 และ 1.25 แอมแปร์ ร่วมกับทำการเปลี่ยนแปลงกวามถี่ในการจ่ายกระแสไฟฟ้า 3 ก่าคือ 0.5, 1.0 และ 2.5 เฮิร์ทซ พร้อมทั้งทำการวัดระยะกระดกของไมโครแอกชัวเอเตอร์ด้วยเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์มิเตอร์ที่ ติดตั้งไว้ด้านบนของไมโครแอกชัวเอเตอร์และต่อเข้ากับตัวเลเซอร์มิเตอร์ ซึ่งสามารถอ่านระยะ กระดกได้จากหน้าจอของมิเตอร์และบันทึกข้อมูลในเครื่องออสซิลสโคปได้ ในการทดสอบ การตอบสนองเชิงจลน์มีกวามแม่นยำในการวัดระยะกระดกของไมโครแอกชัวเอเตอร์อยู่ที่ 0.5 ไมโกรเมตร และมีกวามเร็วในการเก็บข้อมูลอยู่ที่ 1,000 ก่าต่อไมโกรวินาที พารามิเตอร์ใน การทดสอบการตอบสนองเชิงจลน์นี้แสดงดังตารางที่ 4.2



ภาพที่ 4.6 อุปกรณ์ในการทดสอบการตอบสนองเชิงจลน์

| ชนิดของไมโครแอคชัวเอ เตอร์ที่ใช้ในการทดสอบ | กระแสไฟฟ้าที่ทำการจ่ายให้กับ ไมโครแอคชัวเอเตอร์ (แอมแปร์) | | | | ความถี่ที่ใช้ในการจ่าย กระแสไฟฟ้าให้กับไมโคร แอคชัวเอเตอร์ (เฮิร์ทช) | | |
|---|--|------|------|------|--|-----|-----|
| ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ไม่ทำ | | | | | | | |
| การอบ | | | | | | | |
| ไมโครแอคชั่วเอเตอร์ที่ทำการ | | | | | | | |
| อบด้วยแบบหล่อคอนกรีตที่มี | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 0.5 | 1.0 | 2.5 |
| ลักษณะแบนราบ | | | | | | | |
| ไมโครแอคชั่วเอเตอร์ ที่ทำการ | | | | | | | |
| อบด้วยแบบหล่อคอนกรีตที่มี | | | | | | | |
| ลักษณะ โค้ง | | | | | | | |

ตารางที่ 4.2 พารามิเตอร์ในการทคสอบการตอบสนองเชิงจลน์

การทคสอบการตอบสนองเชิงจลน์ในงานวิจัยนี้จะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ ใมโครแอคชัวเอเตอร์ทำให้ไมโครแอคชัวเอเตอร์มีอุณหภูมิสูงขึ้นและทำให้ไมโครแอคชัวเอเตอร์ เกิดการกระดกขึ้น โดยในการต่อวงจรในการทคสอบนี้จะทำการต่อสายไฟจากเครื่องกำเนิด กระแสไฟฟ้าที่ควบคุมความถี่ในการจ่ายกระสไฟฟ้าไปยังฐานของไมโครแอคชัวเอเตอร์ในแต่ละ ข้างโดยมีลักษณะการต่อแบบอนุกรม พร้อมทั้งทำการวัดระยะกระดกของไมโครแอคชัวเอเตอร์ แล้วเก็บค่าระยะกระดกในออสซิลโลสโคป หลังจากทำการทดสอบเสร็จสิ้นจึงดึงข้อมูลมาวิเคราะห์ ผ่านแฟลชไดร์ฟและนำไปเปิดด้วยโปรแกรมเอ็กเซล ทำการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและ พล๊อตกราฟของระยะกระดกของไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ก่ากระแสไฟฟ้าและก่าความถี่ใน การจ่ายกระแสไฟฟ้าต่างๆ

กราฟแสดงความสัมพันธ์ของเวลาในการทดสอบและระยะกระดกของ ใมโครแอคชัวเอเตอร์ เมื่อง่ายกระแสไฟฟ้าให้กับไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ความถี่ 0.5 เฮิร์ทซที่ขนาด กระแสไฟฟ้าต่างๆ แสดงดังภาพที่ 4.7(ก) ถึงภาพที่ 4.7(ค) ซึ่งกราฟทั้งสามเป็นผลการทดสอบ การตอบสนองเชิงจลน์ที่ได้ทำการเฉลี่ยทั้งสองชิ้นงานของไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ไม่ทำการอบ ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการอบด้วยแบบหล่อคอนกรีตที่มีลักษณะแบบราบและ ใมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการอบด้วยแบบหล่อคอนกรีตที่มีลักษณะแบบราบและ พบว่า เมื่อทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับไมโครแอคชัวเอเตอร์ แล้วไมโครแอคชัวเอเตอร์จะเกิด การกระดกขึ้นทันทีไปในทิศทางของนิทินอลและเมื่อหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้า ไมโครแอคชัวเอเตอร์ จะกระดกกลับสู่ที่เดิม ระยะกระดกของไมโครแอคชัวเอเตอร์จะมีแนวโน้มมากขึ้นเมื่อมีค่า กระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับไมโครแอคชัวเอเตอร์สูงขึ้น ภาพถ่ายของการกระดกของ ไมโครแอคชัวเอเตอร์หลังจากการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่เวลาต่างๆได้แสดงในภาพที่ 4.8

้นอกจากนั้นในงานวิจัยได้ทำการพิจารณาระยะกระดกระหว่างระยะกระดกสูงสุดและระยะ กระดกต่ำสุดของใมโครแอคชั่วเอเตอร์หรือแอมพลิจูด (Amplitude) ของใมโครแอคชั่วเอเตอร์ (รายละเอียดการจัดการข้อมูลจะแสดงในภาคผนวก ง) โดยทำการวัดแอมพลิจูดของ ใมโครแอคชัวเอเตอร์ชนิดต่างๆ ที่ได้รับการง่ายกระแสไฟฟ้าและความถึ่ง่ายกระแสไฟฟ้าต่างๆ ้จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับไมโครแอคหัวเอเตอร์และความถี่ใน การจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อแอมพลิจูดของไมโครแอกชัวเอเตอร์แสดงดังภาพที่ 4.9(ก) ถึงภาพที่ 4.9(ค) พบว่าแอมพลิจูดของใมโครแอกชั่วเอเตอร์ที่กวามถี่ในการง่ายกระแสไฟฟ้าที่ต่ำจะมีค่ามากกว่า แอมพลิจูดของไมโครแอกชั่วเอเตอร์ที่ความถี่ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ต่ำซึ่งหากเพิ่มความถี่ใน การจ่ายกระแสไฟฟ้าสูงขึ้นแนวโน้มของแอมพลิจุดของไมโครแอคชั่วเอเตอร์จะมีค่าต่ำลง เนื่องจาก ้ที่ความถี่ต่ำกว่า ไมโครแอคชัวเอเตอร์สามารถเก็บสะสมพลังงานได้นานทำให้ไมโครแอคชัวเอเตอร์ ้มีอุณหภูมิสูงกว่า และส่งผลทำให้แอมพลิจูดของไมโครแอคชั่วเอเตอร์มีค่าสูง นอกจากนี้แอมพลิจุด ้ของไมโครแอคชั่วเอเตอร์ที่ทำการอบจะมีค่าแอมพลิจูดมากกว่าไมโครแอคชั่วเอเตอร์ที่ไม่ทำ ้การอบ แต่อย่างไรก็ตามไมโครแอคชั่วเอเตอร์ที่ทำการอบด้วยแบบหล่อที่มีลักษณะแบนราบกับ ้ใมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการอบด้วยแบบหล่อที่มีลักษณะโค้งจะมีแอมพลิจูดที่ใกล้เคียงกัน โดยที่ แอมพลิจูดของไมโครแอคชั่วเอเตอร์ที่ไม่ทำการอบ ไมโครแอคชั่วเอเตอร์ที่ทำการอบด้วยแบบหล่อ ที่มีลักษณะแบนราบและ โค้งจะมีค่าเท่ากับ 0.12. 1.7 และ 1.3 มิลลิเมตร ตามลำคับ

จากผลการทดสอบจะเห็นได้ว่า ที่ความถี่ 2.5 เฮิร์ทซ ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการอบจะมี แอมพลิจูดที่สูงกว่าไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ไม่ทำการอบ ตัวอย่างเช่น เมื่อทำการจ่ายกระแสไฟฟ้า 1.25 แอมแปร์ที่ความถี่ 2.5 เฮิร์ทซ ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการอบมีแอมพิลจูดประมาณ 0.5 มิลลิเมตร ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายในทางตรงกันข้ามที่สภาวะเดียวกัน ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ไม่ทำการอบมีแอมพิลจูดน้อยกว่า 0.1 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นค่าแอมพลิจูดที่น้อย ที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานหรือจำเป็นต้องนำไปประยุกต์ใช้งานที่จำเพาะมากขึ้น

นอกจากนี้ในการทคสอบการตอบสนองเชิงจลน์จะทำการทำนายอุณหภูมิของ ใมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำให้ไมโครแอคชัวเอเตอร์กระคกขึ้นเมื่อทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากผล การทคสอบการตอบสนองเชิงสถิตย์ โดยจะทำการทำนายเฉพาะไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการอบ ด้วยแบบหล่อทีมีลักษณะแบนราบและโค้งเท่านั้น เนื่องจากมีระยะกระสูงทำให้ความไม่แน่นอนใน การทำนายค่อนข้างต่ำ ในการทำนายนี้จะพิจารณาจากกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้า ที่จ่ายให้กับไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ความถี่ 0.5 เฮิร์ทซและแอมพลิจูดของไมโครแอคชัวเอเตอร์ซึ่ง แสดงในตารางที่ 4.3 โดยพิจารณาจากระยะกระดกของการทดสอบทั้งสองและนำมาเปรียบเทียบ กัน ตัวอย่างเป็นดังนี้เมื่อทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ 1.00 แอมแปร์ที่ความถี่ 0.5 เฮิร์ทซ ใมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการอบด้วยแบบหล่อที่มีลักษณะแบนราบและโค้งที่มีแอมพลิจูดเท่ากับ 1.1 และ 0.85 มิลลิเมตร ซึ่งเมื่อทำไปเปรียบเทียบกับผลการทดสอบการตอบสนองเชิงสลิตย์ที่ ระยะกระดกเดียวกันจะทำนายได้ว่าอุณหภูมิของไมโครแอคชัวเอเตอร์มีค่าประมาณ 65 และ 60 องศาเซลเซียสที่ไมโครแอคชัวเอเตอร์ทั้งสองแบบ ตามลำดับ

4.4 สรุปผลการทดสอบการตอบสนองเชิงจลน์

ในการทดสอบการตอบสนองเชิงจลน์นี้จะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับไมโครแอคชัวเอเตอร์ พร้อมกับทำการวัดระยะกระดกของไมโครแอคชัวเอเตอร์ โดยมีความแม่นยำในการวัดระยะกระดก ของไมโครแอคชัวเอเตอร์อยู่ที่ 0.5 ไมโครเมตร และมีความเร็วในการเก็บข้อมูลอยู่ที่ 1,000 ค่าต่อ ไมโครวินาที จากผลการทดสอบสามารถสรุปได้ว่า ขั้นตอนการอบฟิล์มนิทินอลมีผลต่อ ระยะกระดกและความเร็วในการตอบสนองของไมโครแอคชัวเอเตอร์ โดยที่ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ ทำการอบจะมีระยะกระดกและมีแอมพลิจูดที่สูงกว่าไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ไม่ทำการอบ แต่ อย่างไรก็ตามลักษณะในการอบด้วยแบบหล่อคอนกรีตของไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ไม่ทำการอบ แต่ แอมพลิจูดเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ในงานวิจัยนี้ได้ทำการสอบเทียบเพื่อทำการหาอุณหภูมิของ ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ได้รับการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ความถี่ 0.5 เฮิร์ทซสำหรับไมโครแอคชัวเอเตอร์ ที่ทำการอบโดยผลการสอบเทียบอุณหภูมิแสดงในตารางที่ 4.3 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ที่กระแสไฟฟ้า 1.25 แอมแปร์ และความถี่ 0.5 เฮิร์ทซ จะมีอุณหภูมิในระดับ 80-85 องศาเซลเซียส

จากการทคสอบการตอบเชิงจลน์พบว่า ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการทคสอบจะไม่เกิด การสั่นขึ้นลงอย่างรวคเร็วเหมือนในการทคสอบการตอบสนองเชิงสถิตย์ เนื่องจากการถ่ายเท ความร้อนให้กับไมโครแอคชัวเอเตอร์ด้วยการจ่ายกระแสไฟฟ้าจะมีค่ามากกว่าการแลกเปลี่ยน ความร้อนกับอากาศภายนอกมาก ซึ่งจะเห็นได้จากการกำนวณการแลกเปลี่ยนความร้อนของ ไมโครแอกชัวเอเตอร์แสดงดังตารางที่ 4.1



ภาพที่ 4.7 ระยะกระดกของไมโครแอคชัวอเตอร์เมื่อทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ ใมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ความถี่ 0.5 เฮิร์ทซ ด้วยขนาดของกระแสไฟฟ้าคลื่นสี่เหลี่ยมต่างๆ (ก) ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ไม่ทำการอบ (ข) ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการอบด้วยแบบหล่อที่มี ลักษณะแบนราบ (ค) ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการอบด้วยแบบหล่อที่มีลักษณะโค้ง



(ก)



(ป)



(ค)

ภาพที่ 4.8 ลักษณะการกระคกของไมโครแอคชัวเอเตอร์หลังจากการจ่ายกระแสไฟฟ้า 1.00 แอมแปร์ ที่ความถี่ 0.5 เฮิร์ทซ (ก) ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ไม่ทำการอบ (ง) ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ ทำการอบด้วยแบบหล่อที่มีลักษณะแบนราบ (ค) ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการอบด้วย แบบหล่อที่มีลักษณะโก้ง



ภาพที่ 4.9 ระยะกระดกของไมโครแอคชัวเอเตอร์เมื่อทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ความถี่ต่างๆ (ก) ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ไม่ทำการอบ (ข) ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการอบด้วยแบบหล่อที่มี ลักษณะแบนราบ (ค) ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการอบด้วยแบบหล่อที่มีลักษณะโค้ง

| | อุณหภูมิของไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ได้รับการจ่ายกระแสไฟฟ้า | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------|-------|-------|--|--|--|
| ชนิดของไมโครแอคชั่วเอเตอร์ | ต่างๆ (องศาเซลเซียส) | | | | | | |
| | 0.50A | 0.75A | 1.00A | 1.25A | | | |
| ใมโครแอคชั่วเอเตอร์ที่ทำการ | | | | | | | |
| อบด้วยแบบหล่อที่มีลักษณะ | 15 | 35 | 65 | 85 | | | |
| แบนราบ | | | | | | | |
| ใมโครแอคชั่วเอเตอร์ที่ทำการ | | | | | | | |
| อบด้วยแบบหล่อที่มีลักษณะ | 10 | 30 | 60 | 80 | | | |
| โด้ง | | | | | | | |

ตารางที่ 4.3 อุณหภูมิของไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการอบเมื่อได้รับการจ่ายกระแสไฟฟ้าต่างๆที่ ความถี่ 0.5 เฮิร์ทซ

4.5 การประยุกต์ใช้งานไมโครแอคชั่วเอเตอร์ที่สร้างขึ้น

งานวิจัยนี้ได้นำไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการอบที่อุณหภูมิ 650 องสาเซลเซียสเป็น ระยะเวลา 30 นาทีสร้างขึ้นมาประยุกต์ใช้งานในรูปแบบอุปกรณ์หยิบจับขนาดเล็กประกอบด้วย ไมโครแอคชัวเอเตอร์ 2 ชิ้นและตัวหนีบที่ต่อขั้วนำไฟฟ้า แสดงในภาพที่ 4.10 โดย ไมโครแอคชัวเอเตอร์ทั้งสองชิ้นที่นำมาประกอบนั้นจะหันด้านของฟิล์มนิทินอลซึ่งจะมีหลักการ การใช้งานแสดงในภาพที่ 4.11 โดยเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์หยิบจับไมโครแอคชัวเอเตอร์ ทั้งสองชิ้นจะกางออกพร้อมที่จะจับชิ้นงาน และเมื่อหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าไมโครแอคชัวเอเตอร์ทั้ง สองจะหุบกลับเพื่อทำการหยิบชิ้นงานที่ต้องการได้

ภาพที่ 4.12 แสดงลักษณะการจับเม็ดโฟมด้วยอุปกรณ์หยิบขนาดเล็กที่มีไมโครแอกชัวเอเตอร์ ที่สร้างขึ้นเป็นส่วนประกอบซึ่งจะเห็นได้ว่า อุปกรณ์หยิบจับที่สร้างขึ้นสามารถจับเม็ดโฟมที่มี น้ำหนักเท่ากับ 0.5 มิลลิกรัมขึ้นมาได้ แต่เมื่อนำอุปกรณ์หยิบจับมาทำการจับชิ้นพลาสติกขนาดเล็ก ที่มีน้ำหนักเท่ากับ 10 มิลลิกรัม อุปกรณ์หยิบจับที่สร้างขึ้นไม่สามารถที่จะจับชิ้นพลาสติกนี้ขึ้นมา ได้แสดงในภาพที่ 4.13 เนื่องจากคุณสมบัติ trade off ของอุปกรณ์หยิบจับขนาดเล็กซึ่งจะเห็นได้ว่า หากทำการออกแบบอุปกรณ์หยิบจับที่มีระยะกระดกมาก อุปกรณ์หยิบจับนั้นจะมีแรงในการใช้งาน ที่น้อย แต่หากทำการออกแบบอุปกรณ์หยิบจับที่มีระยะกระดกน้อย อุปกรณ์หยิบจับนั้นจะมีแรงในการใช้งาน



ภาพที่ 4.10 อุปกรณ์หยิบจับงนาคเล็กที่สร้างขึ้น (ก) ใคอะแกรม (ข) ภาพถ่ายจริง













(ค)

ภาพที่ 4.12 การจับเม็คโฟม (ก) ก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้า (ข) จ่ายกระแสไฟฟ้า (ก) จับเม็คโฟม (ง) ยกเม็คโฟม







(ค)

ภาพที่ 4.13 การจับชิ้นพลาสติก

(ก) ก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้า (ข) จ่ายกระแสไฟฟ้า (ค) จับชิ้นพลาสติก (ง) ยกชิ้นพลาสติก (ไม่สำเร็จ)

สรุปผลการทดสอบใมโครแอคชั่วเอเตอร์ 4.6

ในงานวิจัยนี้ทำการทคสอบไมโครแอคชัวเอเตอร์แบบโลหะผสมจำรูปที่มีลักษณะเป็น ้คานสองชั้นที่ประกอบด้วยนิทินอลกับทองแดงซ้อนทับกันโดยมีความหนา 5.8 และ 12 ้ไมโครเมตรตามลำคับ ในการทดสอบนี้ไมโครแอกชัวเอเตอร์ที่ทำการอบฟิล์มนิทินอลที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 30 นาที จะถูกอบในแบบหล่อคอนกรีตที่มีลักษณะแตกต่างกันคือ แบบหล่อคอนกรีตที่มีลักษณะแบนราบและแบบหล่อคอนกรีตที่มีลักษณะ โค้ง ในการทดสอบจะมี ้ไมโครแอคชั่วเอเตอร์แบบที่ไม่อบและแบบอบทั้งสองรูปแบบถูกนำมาทำการทดสอบชนิดละ 2 ้ชิ้นงานรวมทั้งหมด 6 ชิ้นงาน ซึ่งในงานวิจัยนี้จะแบ่งการทดสอบไมโครแอคชัวเอเตอร์ออกเป็น ้สองการทคสอบคือ การทคสอบการตอบสนองเชิงสถิตย์และการทคสอบการตอบสนองเชิงจลน์ ซึ่งจากการทคสอบไมโครแอคชั่วเอเตอร์สามารถสรปได้ดังนี้

- 1. จากการทำการทดสอบไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่สร้างขึ้นจะเห็นได้ว่า ไมโครแอคชัวเอเตอร์ ที่สร้างขึ้นจะมีคุณสมบัติเชิงกลที่แตกต่างกันทั้งระยะกระดกและความเร็วใน การตอบสนองของไมโครแอคชั่วเอเตอร์
- 2. ในการทคสอบการตอบสนองเชิงสถิตย์ของไมโครแอคชัวเอเตอร์จะใช้การส่งความร้อน เข้าสู่โครงสร้างของไมโครแอคชัวเอเตอร์โดยตรงและสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่าง การเพิ่มอุณหภูมิกับระยะกระดกของใมโครแอคชัวเอเตอร์ได้ โดยที่ไมโครแอคชัวเอเตอร์

ที่ทำการอบที่อุณหภูมิสูงจะมีระยะกระดกที่มากกว่าไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ไม่ทำการอบ ซึ่งจะมีระยะกระดกมากกว่าประมาณ 1.5 เท่าที่อุณหภูมิของไมโครแอคชัวเอเตอร์เท่ากับ 80 องศาเซลเซียส

- 3. ในการทดสอบการตอบสนองเชิงจลน์ของไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่สร้างขึ้นจะให้การจ่าย กระแสไฟฟ้ารูปคลื่นสี่เหลี่ยม ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการอบที่อุณหภูมิสูงมีแอมพลิจูด ของระยะกระดกที่มากกว่าไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ไม่ทำการอบ นอกจากนี้ที่ความถี่การจ่าย ไฟฟ้าที่สูงกว่าไมโครแอคชัวเอเตอร์ทุกชนิดจะมีระยะการะดกลดลงเพราะว่าความร้อนที่ ถ่ายเทไปสู่โครงสร้างของไมโครแอคชัวเอเตอร์จะเกิดขึ้นไม่ทันทำให้อุณหภูมิของ ไมโครแอคชัวเอเตอร์ต่ำกว่ากรณีที่จ่ายกระแสไฟฟ้าที่ความถี่ต่ำกว่า
- ในงานวิจัยนี้ทำการศึกษาลักษณะการอบไมโครแอคชัวเอเตอร์สองแบบคือ การอบที่ ลักษณะแบนราบและการอบที่ลักษณะโค้ง (รัศมีความโค้ง 22 มิลลิเมตร) จากการศึกษา พบว่ามีผลต่อระยะกระคกและความเร็วในการตอบสนองของไมโครแอคชัวเอเตอร์เพียง เล็กน้อยโคยที่การอบที่ลักษณะแบนราบจะมีแนวโน้มของคุณสมบัติเชิงกลที่ดีกว่า
- 5. งานวิจัยนี้สามารถนำไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการอบที่อุณหภูมิ 650 องสาเซลเซียสเป็น ระยะเวลา 30 นาทีมาประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์หยิบจับขนาดเล็กได้แต่สามารถจับวัสดุที่มี น้ำหนักเบา เนื่องจากอุปกรณ์หยิบจับขนาดเล็กที่สร้างขึ้นนี้มีการออกแบบให้มี ระยะกระดกมากเพื่อที่จะสามารถหยิบวัสดุที่มีขนาดใหญ่ได้แต่ไม่สามารถหยิบวัสดุที่มี น้ำหนักมากได้

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย

ในงานวิจัยนี้สนใจในไมโครแอคชัวเอเตอร์ในเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าเครื่องกลจุลภาคโดย ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ให้ความสนใจจะมีลักษณะเป็นคานสองชั้น เนื่องจากมีโครงสร้างที่ ไม่ซับซ้อนและมีคุณสมบัติเชิงกลที่ดี และใช้หลักการโลหะผสมจำรูป เนื่องจากหลักการโลหะผสม จำรูปเป็นหลักการที่มีรูปแบบที่กระทัดรัดเนื่องจากไม่ต้องมีอุปกรณ์ควบคุมจำนวนมากโครงสร้าง ที่ไม่ซับซ้อนทำให้สะควกต่อการประกอบอุปกรณ์และการควบคุมในการใช้งานทำได้ง่าย ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะทำการสร้างไมโครแอคชัวเตอร์แบบโลหะผสมจำรูปที่มีลักษณะเป็น คานสองชั้นระหว่างวัสดุโลหะผสมจำรูปคือ นิทินอลซึ่งเป็นวัสดุโลหะผสมจำรูปที่มีลักษณะเป็น คานสองชั้นระหว่างวัสดุโลหะผสมจำรูปคือ นิทินอลซึ่งเป็นวัสดุโลหะผสมจำรูปชนิดอื่น เช่น อุณหภูมิในการใช้งานที่ไม่สูงนัก มีระยะขยับที่สูง มีแรงกระทำใช้งานที่สูง ทนต่อการกัดกร่อนและ มีความต้านทานทางไฟฟ้าที่สูง เป็นต้น และวัสดุอีกชนิดหนึ่งที่นำมาซ้อนทับกันคือทองแดง เนื่องจากทองแดงเป็นโลหะที่มีราคาถูก มีคุณสมบัติเชิงกลที่ดีและสามารถนำมาใช้ในกระบวนการ ผลิตได้หลากหลายวิธี

จากงานวิจัยที่ผ่านมา กระบวนการสร้างไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่มีลักษณะคานสองชั้นจะ ก่อนข้างมีกระบวนการสร้างที่ซับซ้อน และเกิดการเสียหายไมโครแอคชัวเอเตอร์หรือชิ้นงาน ระหว่างทำการสร้างได้ง่าย เนื่องจากกระบวนการสร้างโดยทั่วไปจำเป็นต้องสร้างบนแผ่นซิลิกอน และต้องอาศัยการกัดชิ้นงานจากด้านล่างในการสร้างไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่มีลักษณะเป็นคานสอง ชั้น ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะทำการพัฒนากระบวนการสร้างไมโครแอคชัวเตอร์แบบโลหะผสมจำรูป ที่มีลักษณะเป็นคานสองชั้นด้วยวิธีการที่ง่ายไม่ซับซ้อนโดยไม่ใช้ซิลิกอน เพื่อหลีกเลี่ยง กระบวนการสร้างที่ซับซ้อนและการเกิดความเสียหายของไมโครแอคชัวเอเตอร์หรือชิ้นงานเอง

เริ่มแรกงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาพารามิเตอร์ที่มีผลต่อสมรรถนะของไมโครแอคชัวเอเตอร์ แบบโลหะผสมจำรูปที่มีลักษณะแบบคานสองชั้นก่อนทำการสร้างไมโครแอคชัวเอเตอร์ โดยแบ่ง การศึกษาออกเป็นสองการศึกษาคือ การศึกษาระยะกระดกของไมโครแอคชัวเอเตอร์ด้วยระเบียบ วิธีการทางไฟในต์อิลิเมนต์และการศึกษาการถ่ายเทความร้อนของไมโครแอคชัวเอเตอร์แบบโลหะ ผสมจำรูปที่มีลักษณะเป็นคานสองชั้นโดยมีพารามิเตอร์ที่ทำการเปลี่ยนแปลงคือก่าความหนาของ ทองแดง จากการศึกษาทั้งสองการศึกษานี้สามารถสรุปได้ว่าไมโครแอคชัวเอเตอร์แบบ โลหะผสมจำรูปที่มีลักษณะเป็นคานสองชั้นที่มีความหนาของทองแดงที่บางจะทำให้ ใมโครแอคชั่วเอเตอร์มีระยะกระดกที่ดีและมีการถ่ายเทความร้อนหรือความถี่ในการใช้งาน ที่สูงด้วย

จากนั้นงานวิจัยได้ทำการสร้างไมโครแอคชัวเอเตอร์แบบโลหะผสมจำรูปที่มีลักษณะเป็น คานสองชั้นที่ประกอบด้วยนิทินอลกับทองแดงซ้อนทับกันด้วยกระบวนการสร้าง ใมโครแอคชัวเอเตอร์แบบใหม่โดยไม่ใช้แผ่นซิลิกอน เพื่อหลีกเลี่ยงกระบวนการสร้างที่ซับซ้อน และการเกิดความเสียหายของตัวไมโครแอคชัวเอเตอร์หรือชิ้นงานเอง กระบวนการสร้าง ไมโครแอคชัวเอเตอร์แบบใหม่จะประกอบด้วยกระบวนในการสร้างเพียงสองขั้นตอนหลักคือ กระบวนการสร้างโครงสร้างทองแดงแบบลอยตัวและกระบวนการเคลือบผิวด้านบน ของโครงสร้าง

กระบวนการสร้างโครงสร้างทองแดงลอยตัวเป็นการสร้างโครงสร้างทองแดงด้วยเทคนิค การชุบโลหะด้วยไฟฟ้าเคมืองบนแผ่นสเตนเอสที่มีการสร้างแบบหอ่อตามอวดอายที่ด้องการ โดย กระบวนการสร้างโครงสร้างทองแดงแบบออยตัวนี้สามารถแบ่งออกได้เป็นสองขั้นตอนย่อยคือ ขั้นตอนการสร้างแบบหอ่อเป็นขั้นตอนการสร้างแบบหอ่อที่มีอวดอายที่ด้องการองบนแผ่น ซับสเตรตโดยนำกระบวนการสร้างอวดอายด้วยแสงเพื่อทำการสร้างแบบหอ่อที่มีขนาดอยู่ในระดับ ใมโครสเกล และขั้นตอนการชุบโอหะด้วยไฟฟ้าเคมีเป็นขั้นตอนการเคลือบโอหะองบนแผ่น ซับสเตรตศักยนำกระบวนการสร้างอาดอายด้วยแสงเพื่อทำการสร้างแบบหอ่อที่มีขนาดอยู่ในระดับ ใมโครสเกล และขั้นตอนการชุบโอหะด้วยไฟฟ้าเคมีเป็นขั้นตอนการเคลือบโอหะองบนแผ่น ซับสเตรตตามอวดอายที่มีการสร้างขึ้นโดยที่อิเล็กตรอนจะวิ่งจากขั้วแอโนดผ่านไปยังขั้วแคโทด ทำให้ไอออนบวกจากขั้วแอโนดที่เป็นทองแดงวิ่งผ่านสารอะอายอิเล็กโตรไอท์มาเกาะยังแผ่น ซับสเตรตที่ขั้วแคโทดได้ จากระบวนการสร้างนี้สามารถสร้างโครงสร้างทองแดงออยตัวที่มีความ แข็งแรงและมีความหนาที่บางขึ้นมาได้โดยโครงสร้างทองแดงที่สร้างขึ้นนี้มีความหนาประมาณ 12.2 ไมโครเมตร แต่อย่างไรก็ตามในการสร้างโครงสร้างทองแดงออยตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ขั้นตอนการชุบโอหะด้วยไฟฟ้าเกมีจำเป็นต้องกำนึงถึงกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับระบบโดยการจ่าย กระแสไฟฟ้านี้ควงว่ายกระแสไฟฟ้าน้อยกว่า 0.5 แอมแปร์หรือก่ากรแสไฟฟ้าต่อหน่วยพื้นที่น้อย กว่า 45 มิอลิแอมแปร์ต่อตารางเซนติเมตร เพื่ออดกวามเด้นที่เกิดขึ้นระหว่างการชุบโอหะด้วยไฟฟ้า เกมีซึ่งจะทำให้โครงสร้างทองแดงอเตอตัวที่สร้างขึ้นเกิดการเสียรูปร่างได้

กระบวนการเคลือบผิวด้านบนของโครงสร้างทองแดงด้วยนิทินอลเป็นกระบวนการปลูก ฟิล์มนิทินอลบนทองแดงโดยกระบวนการเคลือบผิวด้านบนของโครงสร้างทองแดงด้วยนิทินอลนี้ สามารถแบ่งเป็นสองขั้นตอนย่อยคือ ขั้นตอนการเคลือบผิวด้วยนิทินอลการเคลือบผิวด้วยนิทินอล ด้วยเครื่องสปัตเตอริงตามเทคนิคการสปัตเตอริงซึ่งสามารถปลูกฟิล์มนิทินอลที่มีความหนาเท่ากับ 5.8±0.4 ใมโครแอคชัวเอเตอร์ และขั้นตอนการอบฟิล์มนิทินอลเป็นเป็นการอบฟิล์มนิทินอลที่ อุณหภูมิสูงทำให้โครงสร้างภายในนิทินอลเปลี่ยนแปลงจากอมอฟัสเป็นโครงสร้างผลึก โดย งานวิจัยนี้จะทำการอบฟิล์มนิทินอลด้วยเตาอบแบบหลอดควอทซ์โดยมีก๊าซอาร์กอนไหลผ่าน ้เนื่องจากเตาอบแบบหลอดควอทซ์เป็นเตาอบที่ง่ายต่อการใช้งานและเป็นเตาอบที่มีการควบคุมที่ไม่ ซับซ้อน โดยในขั้นตอนการอบฟิล์มนิทินอลนี้จะมีการอบด้วยแบบหล่อคอนกรีตสองลักษณะคือ ้แบบหล่อที่มีลักษณะแบนราบและแบบหล่อที่มีลักษณะ โค้ง พร้อมทั้งยังทำการทคลองเปลี่ยน อุณหภูมิในงานอบไมโครแอคชั่วเอเตอร์เพื่อหาอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สามารถทำให้โครงสร้าง ภายในนิทินอลเปลี่ยนแปลงด้วยเตาอบแบบหลอดควอทซ์โดยมีก๊าซอาร์กอนไหลผ่านนี้ โดยใน การทดลองมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในการอบฟิล์มนิทินอล 3 ค่าคือ 500, 600 และ 650 ้องศาเซลเซียส โดยมีระยะเวลาการอบคงที่เท่ากับ 30 นาที จากการทดลองสามารถสรุปได้ว่า การอบ ้ฟิล์มนิทินอลด้วยเตาอบแบบหลอดควอทซ์โดยมีก๊าซอาร์กอนไหลผ่านที่อุณหภูมิ 600 และ 650 ้องศาเซลเซียสเป็นเวลา 30 นาที สามารถทำให้โครงสร้างของนิทินอลเปลี่ยนจากอมอพัสเป็น ้โครงสร้างผลึกได้และมีแนวโน้มที่โครงสร้างผลึกจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อทำการอบที่อุณหภูมิที่สูงขึ้น นอกจากนี้เมื่อทำการเปรียบเทียบฟิล์มนิทินอลที่ไม่ทำการอบกับทำการอบที่อุณหภูมิ 650 ้องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 30 นาที่จะเห็นได้ว่า ฟิล์มนิทินอลที่ทำการอบที่อุณหภูมิสูงจะมี ้โครงสร้างผลึกทั้งนิทินอล ไททาเนียมไดออกไซด์ นิกเกิลทองแดงหรืออื่นๆที่มากกว่าฟิล์มนิทินอล ้ไม่ทำการอบ โคยโครงสร้างผลึกของฟิล์มนิทินอลที่เกิดขึ้นหลังจากการอบที่อุณหภูมิ 650 ้องศาเซลเซียสนี้จะมีเพิ่มขึ้นถึงร้อย 60 จากปริมาณโครงสร้างผลึกของฟิล์มนิทินอลที่ไม่ทำการอบ รวมทั้งอัตราส่วนของธาตุของฟิล์มนิทินอลที่ทำการอบที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 30 ้นาที่จะเปลี่ยนไปเช่นกัน โคยฟิล์มนิทินอลที่ทำการอบจะมีออกซิเจนและทองแคงเกิคขึ้น ซึ่ง ้ทองแดงนี้ได้รวมตัวกับนิกเกิลในชั้นฟิล์มนิทินอลเป็นนิกเกิลทองแดงซึ่งส่งผลทำให้ฟิล์มนิทินอลมี สมบัติในการถ่ายเทความร้อนที่ดีขึ้น

หลังจากสามารถสร้างไมโครแอคชัวเอเตอร์แบบโลหะผสมจำรูปที่มีลักษณะเป็นคาน สองชั้นที่ประกอบด้วยนิทินอลความหนา 5.8 ไมโครเมตรและทองแดงความหนา 12.2 ไมโครเมตร ได้สำเร็จ งานวิจัยนี้ได้ทำการทดสอบไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่สร้างขึ้นนี้ โดยจะทำการทดสอบ ไมโครแอคชัวเอเตอร์ทั้งหมดสามชนิดคือ ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ไม่ทำการอบและไมโครชัวเอเตอร์ ที่ทำการอบฟิล์มนิทินอลที่อุณหภูมิ 650 องสาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 30 นาทีด้วยแบบหล่อ กอนกรีตที่มีลักษณะแตกต่างกันสองลักษณะคือ ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการอบโดยใช้แบบหล่อ กอนกรีตที่มีลักษณะแตกต่างกันสองลักษณะคือ ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการอบโดยใช้แบบหล่อ กอนกรีตที่มีลักษณะแบนราบและไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการอบโดยใช้แบบหล่อคอนกรีตที่มี ลักษณะโด้งและนำผลการทดสอบมาทำการเปรียบเทียบคุณสมบัติเชิงกล สำหรับการทดสอบ ไมโครแอคชัวเอเตอร์นี้จะแบ่งการทดสอบเป็นสองส่วนคือ การทดสอบการตอบสนองเชิงสถิตย์และ การทดสอบการตอบสนองเชิงลน์

การทคสอบการตอบสนองเชิงสถิตย์นี้จะทำการวัคระยะกระคกและทำการวัคอุณหภูมิของ ้ไมโครแอคชั่วเอเตอร์ชนิดต่างๆ ในขณะที่ทำการเพิ่มอุณหภูมิ จากการทดสอบพบว่า เมื่อทำการเพิ่ม ้อุณหภูมิให้กับไมโครแอคชั่วเอเตอร์ ไมโครแอคชั่วเอเตอร์จะเกิดการกระดกขึ้นไปในทิศทางของ นิทินอล และเมื่อไมโครแอคชั่วเอเตอร์มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทำให้ระยะกระคกของ ้ไมโครแอคชั่วเอเตอร์ก็จะสูงขึ้นเช่นกัน ในทางตรงกันข้ามเมื่อทำการหยุดให้ความร้อนกับ ใมโครแอคชั่วเอเตอร์ ใมโครแอคชั่วเอเตอร์จะมีระยะกระคกที่ลคลงเมื่ออุณหภูมิของ ้ไมโครแอกชัวเอเตอร์ถคลง แต่จะปรากฏฮิสเตอร์ริซิสของระยะกระคกขึ้น โคยที่ไมโกรแอกชัวเอเตอร์ ที่ทำการอบที่อุณหภูมิสูงจะมีระยะกระคกที่มากกว่าไมโครแอคชัวเอเตอร์ไม่ทำการอบ ซึ่งจะมี ระยะกระดกมากกว่าประมาณ 1.5 เท่า นอกจากนี้เมื่อทำการเปรียบเทียบระยะกระดกของ ้ไมโครแอคชั่วเอเตอร์แต่ละชนิดที่อุณหภูมิที่เท่ากัน ไมโครแอคชั่วเอเตอร์ที่ทำการอบที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 30 นาที จะมีระยะกระคกที่สูงกว่าไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ไม่ทำ การอบอย่างเห็นได้ชัดเจน แต่เมื่อทำการเปรียบเทียบระยะกระดกของไมโครแอกชัวเอเตอร์ที่ทำการ อบด้วยแบบหล่อกอนกรีตที่มีลักษณะแบนราบกับไมโกรแอกชัวเอเตอร์ที่ทำการอบด้วยแบบหล่อ ้คอนกรีตที่มีลักษณะ โค้งจะเห็น ได้ว่าระยะกระดกของ ไม โครแอคชัวเอเตอร์ของทั้งสองชนิดนี้มี ระยะกระดกที่ใกล้เคียงกัน โดยที่ระยะกระดกของไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ไม่ทำการอบกับ ้ไมโครแอคชั่วเอเตอร์ที่ทำการอบด้วยแบบหล่อแบนราบและโค้งที่อณหภมิ 80 องศาเซลเซียส จะมี ้ค่าเท่ากับ 0.57, 0.94 และ 0.84 มิลลิเมตร ตามลำคับ โดยเมื่อทำการเปรียบเทียบระยะกระดกของ ใมโครแอคชั่วเอเตอร์ที่ทำการอบที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 30 นาทีกับระยะ กระดกของคานจากระเบียบวิธีการไฟในต์อิลิเมนต์ที่ความหนาของทองแดงและอุณหภูมิของ ้ไมโครแอคชั่วเอเตอร์ที่ใกล้เคียงกันจะเห็นได้ว่าระยะกระดกของคานจากระเบียบวิธีการไฟไนต์ อิลิเมนต์จะมีค่าที่สูงกว่าระยะกระคกของไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการอบในการทคสอบประมาณ 150% เนื่องจากฟิล์มนิทินอลที่สร้างขึ้นอาจจะมีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนที่น้อยกว่า ในการศึกษาในบทที่ 2 หรือในการทดสอบไมโครแอคชั่วเอเตอร์มีการแลกเปลี่ยนความร้อนกับ ้อากาศตลอดเวลาจึงทำให้ระยะกระดกในการทดสอบจึงมีก่าที่น้อยกว่าระยะกระดกจากระเบียบ วิธีการไฟในต์อิลิเมนต์

การทดสอบการตอบสนองเชิงจลน์นี้จะทำการวัดระยะกระดกของไมโครแอคชัวเอเตอร์ แบบโลหะผสมจำรูปที่ไม่ทำการอบและทำการอบที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 30 นาที ที่ลักษณะการอบต่างๆในขณะที่ค่ากระแสไฟฟ้าและความถี่ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าต่างๆ จาก การทดสอบพบว่า เมื่อทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับไมโครแอคชัวเอเตอร์ ไมโครแอคชัวเอเตอร์จะ เกิดการกระดกขึ้นทันทีไปในทิศทางของนิทินอลและเมื่อหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้า ใมโครแอคชัวเอเตอร์จะกระดกกลับสู่ที่เดิม ระยะกระดกของไมโกรแอคชัวเอเตอร์จะมีแนวโน้ม มากขึ้นเมื่อมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่สูงขึ้น โดยในการทดสอบจะทำ การพิจารณาแอมพลิจูดของไมโครแอคชัวเอเตอร์ชนิดต่างๆที่ได้รับการจ่ายกระแสไฟฟ้าและ ความถี่ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าต่างๆพบว่า แอมพลิจูดของไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ความถี่ในการจ่าย กระแสไฟฟ้าที่ต่ำจะมีค่ามากกว่าแอมพลิจูดของไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ความถี่ในการจ่าย กระแสไฟฟ้าที่ต่ำจะมีค่ามากกว่าแอมพลิจูดของไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ความถี่ในการจ่าย กระแสไฟฟ้าที่ต่ำจะมีค่ามากกว่าแอมพลิจูดของไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ความถี่ในการจ่าย กระแสไฟฟ้าที่ต่ำซึ่งหากเพิ่มความถี่ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าสูงขึ้นแนวโน้มของแอมพลิจูดของ ใมโครแอคชัวเอเตอร์จะมีค่าต่ำลง และนอกจากนี้แอมพลิจูดของไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการอบ จะมีค่าแอมพลิจูดที่มากกว่าไมโครแอคชัวเอเตอร์ไม่ทำการอบ แต่ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการอบ ด้วยแบบหล่อที่มีลักษณะแบนราบกับไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการอบด้วยแบบหล่อที่มีลักษณะ ไก้งจะมีแอมพลิจูดที่ใกล้เคียงกัน โดยที่ระยะระหว่างระยะกระคกสูงสุดกับระยะกระคกต่ำสุดของ ใมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ไม่ทำการอบกับไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่อบด้วยแบบหล่อแบนราบและโค้ง ที่กระแสไฟฟ้า 1.25 แอมแปร์ และกวามถี่ 0.5 เฮิร์ทซ จะมีค่าเท่ากับ 0.12, 1.7 และ 1.3 มิลลิเมตร ตามถำดับ

จากการทดสอบไมโครแอคชัวเอเตอร์ทั้งสองการทดสอบนี้สามารถสรุปได้ว่า ขั้นตอน การอบฟิล์มนิทินอลมีผลต่อระยะกระดกและความเร็วในการตอบสนองของไมโครแอคชัวเอเตอร์ โดยที่ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการอบจะมีระยะกระดกและแอมพลิจูดที่สูงกว่าไมโครแอคชัวเอเตอร์ ที่ไม่ทำการอบ แต่ลักษณะในการอบด้วยแบบหล่อกอนกรีตของไมโครแอกชัวเอเตอร์ ซึ่งงานวิจัยนี้ ใช้แบบหล่อที่มีลักษณะแบนราบกับโค้งในการอบ จะส่งผลต่อระยะกระดกและแอมพลิจูดของ ไมโครแอกชัวเอเตอร์เพียงเล็กน้อย

นอกจากนี้ในงานวิจัยได้นำไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการอบสร้างขึ้นมาประยุกต์ใช้งานใน รูปแบบอุปกรณ์หยิบจับขนาดเล็ก ซึ่งจะมีหลักการการดังนี้คือเมื่อง่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ หยิบจับ ไมโครแอคชัวเอเตอร์ทั้งสองชิ้นจะกางออกพร้อมที่จะจับชิ้นงาน และเมื่อหยุดง่าย กระแสไฟฟ้า ไมโครแอคชัวเอเตอร์ทั้งสองจะหุบกลับเพื่อทำการหยิบชิ้นงานที่ต้องการได้ โดย อุปกรณ์หยิบจับขนาดเล็กที่สร้างขึ้นนี้สามารถจับเพียงเม็คโฟมที่มีน้ำหนักเท่ากับ 0.5 มิลลิกรัม ขึ้นมาได้เท่านั้น เนื่องจากคุณสมบัติ trade off ของอุปกรณ์หยิบจับขนาดเล็ก แต่อย่างไรก็ตามหาก ต้องการอุปกรณ์หยิบจับขนาดเล็กที่สามารถหยิบวัสดุที่มีน้ำหนักมากกว่านี้จำเป็นต้องทำการอบ

แบบให้อุปกรณ์หยิบจับขนาดเล็กมีระยะกระดกที่น้อยลงเพื่อแลกกับแรงที่สามารถใช้งานที่มากขึ้น จากการทำงานวิจัยสามารถสรุปได้ว่า งานวิจัยนี้สามารถสร้างไมโครแอคชัวเอเตอร์แบบ โลหะผสมจำรูปที่มีลักษณะเป็นกานสองชั้นด้วยกระบวนการสร้างไมโครแอคชัวเอเตอร์แบบใหม่ โดยไม่ใช้แผ่นซิลิกอนได้สำหรับ โดยกระบวนการสร้างไมโครแอคชัวเอเตอร์แบบใหม่นี้จะ ประกอบด้วยกระบวนในการสร้างเพียงสองขั้นตอนหลักคือกระบวนการสร้างโครงสร้างทองแดง แบบลอยตัวและกระบวนการเคลือบผิวด้านบนของโครงสร้าง โดยขั้นตอนการอบฟิล์มนิทินอลใน กระบวนการเคลือบผิวด้านบนของโครงสร้างนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของนิทินอลจาก อมอฟัสเป็นโครงสร้างผลึกได้ด้วยการอบฟิล์มนิทินอลด้วยเตาอบแบบหลอดควอทซ์โดยมี ก๊าซอาร์กอนไหลผ่านได้ซึ่งต้องทำการอบที่อุณหภูมิที่สูงกว่า 600 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 30 นาที โดยที่ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการอบที่อุณหภูมินี้จะมีระยะกระดกและแอมพลิจูดที่สูง ซึ่งส่งผล ให้ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการอบที่อุณหภูมินี้จะมีระยะกระดกและแอมพลิจูดที่สูง ซึ่งส่งผล ให้ไมโครแอคชัวเอเตอร์แบบโลหะผสมจำรูปที่มีลักษณะเป็นคานสองชั้นที่สร้างขึ้นด้วย กระบวนการสร้างไมโครแอคชัวเอเตอร์แบบใหม่นี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ อย่างหลากหลาย

รายการอ้างอิง

- Bell, D.J., Lu, T.J., Fleck, N.A., Spearing, S.M. 2005. Observations on their performance and selection for purpose. <u>J. Micromech. Microeng.</u> 15: S153-S164.
- [2] Nespoli, A., Besseghini, S., Pittaccio, S., Villa, E., Viscuso, S. 2012. The high potential of shape memory alloy in developing miniature mechanical devices: A review on shape memory alloy mini-actuators. <u>Sensors and Actuators A</u> 158: 149-160.
- [3] Krulevitch, P., Lee, A.P., Ramsey, P.B., Trevino, J.C., Hamilton, J., Northrup, M.A.
 1996. Thin film shape memory alloy microactuators. <u>J.</u> <u>Microelectromechanical Systems 5</u>: 270-282.
- [4] Fu, Y., Du, H., Huang, W., Zhang, S., Hu, M. 2004. TiNi-based thin films in MEMS applications a review. <u>Sensors and Actuators A</u> 112: 395-408.
- [5] Makino, E., Mitsuya, T., Shibata, T. 2001. Fabrication of TiNi shape memory micropump. <u>Sensors and Actuators A</u> 88: 256-262.
- [6] Kohl, M., Dittmann, D., Quandt, E., Winzek, B., Miyazaki, S., Allen, D.M. 1999. Shape memory microvalves based on thin films or rolled sheets. <u>Materials</u> <u>Science and Engineering</u> A273-275: 784-788.
- [7] Sassa, F., Al-Zain, Y., Ginoza, T., Miyazaki, S., Suzuki, H. 2012. Miniaturized shape memory alloy pumps for stepping microfluidic transport. <u>Sensors and</u> <u>Actuators B</u> 165: 157-163.
- [8] Takeuchi, S., Shimoyama, I. 2000. A three-dimensional shape memory alloy microelectrode with clipping structure for insert neural recording. <u>J.</u> <u>Microelectromechanical Systems</u> 9: 24-31.

- [9] Luo, J.K., He, J.H., Fu, Y.Q., Flewitt, A.J., Spearing, S.M., Fleck, N.A., Milne, W.I. 2005. Fabrication and characterization of diamond-like carbon - Ni bimorph normally closed microcages. <u>J. Micromech. Microeng.</u> 15: 1406-1413.
- [10] Makino, E., Mineta, T., Mitsunaga, T., Kawashima, T., Shibata, T. 2011. Sphincter actuator fabricated with PDMS-SMA bimorph cantilevers. <u>Microelectronic</u> <u>Engineering</u> 88: 2662-2665.
- [11] Gill, J.J., Chang, D.T., Momoda, L.A., Carman, G.P. 2001. Manufacturing issues of thin film NiTi microwrapper. <u>Sensors and Actuators A</u> 93: 148-156.
- [12] Kim, D.H., Park, Y.C., Park, S. 2010. Design and fabrication of twisting-type thermal actuation mechanism for micromirrors. <u>Sensors and Actuators A</u> 159: 79-87.
- [13] Qu, X.X., Zhang, Q.X., Zou, Q.B., Balasubramanian, N., Yang, P., Zeng, K.Y. 2002. Characterization of TiAl alloy films for potential application in MEMS bimorph actuators. <u>Materials Science in Semiconductor Processing</u> 5: 35-38.
- [14] Lin, I., Zhang, X., Zhang, Y. 2011. Inelastic deformation of bilayer microcantilevers with nanoscale coating. <u>Sensors and Actuators A</u> 168: 1-9.
- [15] Bullen, D., Wang, X., Zou, J., Chung, S., Mirkin, C.A., Liu, C. 2004. Design, Fabrication, and Characterization of Thermally Actuated Probe Arrays for Dip Pen Nanolithography. J. Microelectromechanical Systems 13: 594-602.
- [16] Chung, C.Y., Chan, P.M. 2011. NiTi shape memory alloy thin film micro-cantilever array. <u>Thin Solid Films</u> 519: 5307-5309.
- [17] Fu, Y.Q., Luo, J.K., Ong, S.E., Zhang, S., Flewitt, A.J., Milne, W.I. 2008. A shape memory alloy microcage of TiNi/DLC films for biological applications. <u>J.</u> <u>Micromech. Microeng.</u> 18: 1-8.

- [18] Wang, X., Bellouard, Y., Vlassak, J.J. 2005. Laser annealing of amorphous NiTi shape memory alloy thin films to locally induce shape memory properties. <u>Acta</u> <u>Materialia</u> 53: 4955-4961.
- [19] กฤษณ์กร ประไพพิทยาคุณ. 2554. การพัฒนาไมโครแอคชัวเอเตอร์แบบโลหะผสมจำรูป สำหรับการจับยึดหัวอ่านฮาร์ดดิสก์. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- [20] ภากร นนทิวัฒน์วณิช. 2553. <u>กระบวนการสร้างเมมเบรนฝังไมโครคอยล์และการศึกษา</u> <u>สมรรถนะในการใช้งานเป็นแอคชัวเอเตอร์แบบแม่เหล็กไฟฟ้า</u>. วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- [21] Francisco, M., Fernandes, B., Martins, R., Nogueira, M.T., Silva, R.J.C., Nunes, P., Costa, D., Ferreira, I., Martins, R. 2002. Structural characterization of NiTi thin film shape memory alloys. <u>Sensors and Actuators A</u> 99: 55-58.
- [22] Chan, P.M., Chung, C.Y., Ng., K.C. 2008. NiTi shape memory alloy thin film sensor micro-array for detection of infrared radiation. <u>J. Alloys and Compounds</u> 449: 148-151.
- [23] Ho, K.K., Carman, G.P. 2000. Sputter deposition of NiTi thin film shape memory alloy using a heated target. <u>Thin Solid Films.</u> 370: 18-29.
- [24] Zhang, L., Xie, C., Wu, J. 2007. Oxidation behavior of sputter-deposited Ti-Ni thin films at elevated temperatures. <u>Materials Characterization</u> 58: 471-478.
- [25] Sanjabi, S., Barber, Z.H. 2010. The effect of thin film composition on the structure and mechanical properties of NiTi shape memory thin films. <u>Surface Coatings Tech.</u> 204: 1299-1304.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก วัสดุอุปกรณ์ในกระบวนการสร้างไมโครแอคชัวเอเตอร์

ฟิล์มโฟโต้รีซิส

ในขั้นตอนการสร้างแบบหล่อใช้กระบวนการสร้างลวดลายด้วยแสง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ เปลี่ยนคุณสมบัติของฟิล์มโฟโด้รีซิสโดยการฉายแสง งานวิจัยนี้ใช้ฟิล์มโฟโด้รีซิสแบบเนกาทีฟ ซึ่ง มีหลักการในการใช้คือ เมื่อทำการฉายแสงลงบนฟิล์มโฟโด้รีซิสแบบเนกาทีฟ ฟิล์มส่วนที่โดนแสง จะมีคุณสมบัติของฟิล์มที่เปลี่ยนไปทำให้ทนต่อตัวทำละลาย ในทางตรงกันข้ามส่วนของฟิล์มที่ไม่ โดนแสงจะมีคุณสมบัติเหมือนเดิม ฟิล์มจะหลุดออกเมื่อทำการล้างฟิล์มด้วยตัวทำละลาย ซึ่ง หลังจากการฉายแสงสามารถสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างฟิล์มที่โดนแสงและไม่โดนแสงได้ ดังภาพที่ก.1 โดยในงานวิจัยนี้จะใช้ฟิล์มแบบเนกาทีฟที่มีลักษณะเป็นฟิล์มแข็ง ของบริษัทวาร์ฟ กอร์ปอเรชั่น จำกัด (Warf corporation Co., Ltd.) ดังภาพที่ ก.2 โดยฟิล์มโฟโตรีซิสของบริษัทนี้ ประกอบด้วยฟิล์ม 3 ชั้น ฟิล์มโฟโต้รีซิสจะอยู่ชั้นกลางระหว่างแผ่นฟิล์มพลาสติกประกบทั้ง สองข้าง เพื่อป้องกันฟิล์มโฟโด้รีซิสจากสิ่งสกปรกภายนอก โดยแผ่นฟิล์มพลาสติกด้านหนึ่งมี ลักษณะเป็นแผ่นใส อีกด้านหนึ่งเป็นแผ่นขุ่น ดังภาพที่ ก.3



ภาพที่ก.1 ลักษณะฟิล์มหลังจากการฉายแสง


ภาพที่ ก.2 ฟิล์มแบบเนกาทีฟที่มีลักษณะเป็นฟิล์มแข็ง



ภาพที่ ก.3 ลักษณะการลอกฟิล์มโฟโต้รีซิส

เครื่องรีดฟิล์มไวแสง

ในขั้นตอนการการสร้างแบบหล่อจำเป็นต้องมีการรีดฟิล์ม โฟโต้รีซิสเพื่อให้ติดกับ แผ่นสเตนเลส สำหรับเกรื่องมือที่นำมาใช้งานในการติดฟิล์มในงานวิจัยนี้มีชื่อว่า เกรื่องรีดฟิล์ม ไวแสง รุ่น LAM-150 แสดงดังภาพที่ก.4 ของบริษัทวาร์ฟ กอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยในผนวกนี้จะ กล่าวถึงวิธีการใช้งานของเครื่องรีดฟิล์มไวแสงและขั้นตอนการติดฟิล์มลงบนสเตนเลส ซึ่งมี รายละเอียดดังนี้ วิธีการใช้งานของเครื่องรีคฟิล์มไวแสง

จากภาพที่ก.5 เครื่องรีดฟิล์มไวแสงจะประกอบด้วย ช่องป้อนแผ่นสเตรเลส ฝาครอบซึ่งใต้ ฝาครอบจะมีลูกกลิ้งสำหรับรีดฟิล์มและฮิตเตอร์ และแผงควบคุม โดยรายละเอียดของแผงควบคุมมี ดังนี้

- สวิทซ์เปิด/ปิดเครื่อง ใช้สำหรับการเปิด/ปิดเครื่องฟิล์มไวแสง เมื่อทำการเปิดเครื่อง หลอดไฟสีแสงด้านบน "POWER" จะติดขึ้น
- สวิทซ์เปิด/ปิดมอเตอร์ ใช้สำหรับเปิด/ปิดการทำงานของมอเตอร์ภายในเครื่อง ซึ่งทำให้ ลูกกลิ้งหมุนและพร้อมใช้งาน เมื่อทำการเปิดมอเตอร์ หลอดไฟด้านบน "MOTOR" จะติด ขึ้น
- ปุ่มปรับควบคุมอุณหภูมิ ใช้สำหรับควบคุมอุณหภูมิของฮิตเตอร์ โดยสามารถปรับได้ด้วย การหมุนปุ่มปรับควบคุมอุณหภูมิตามที่ต้องการ เมื่อหมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิ ฮิตเตอร์จะ เริ่มทำงาน โดยจะมีหลอดไฟด้านบน "READY" บอกสถานะดังนี้

| "สว่าง" | แสดงว่าอุณหภูมิของฮิตเตอร์สูงกว่าอุณหภูมิ ที่ตั้งไว้ |
|-----------|---|
| "คับ" | แสดงว่าอุณหภูมิของฮิตเตอร์ต่ำกว่าอุณหภูมิ ที่ตั้งไว้ |
| "กระพริบ" | แสดงว่าอุณหภูมิตรงตามที่กำหนด |



ภาพที่ก.4 เครื่องรีคฟิล์มไวแสง รุ่น LAM-150



ช่องป้อนแผ่นสเตนเลส

ภาพที่ก.5 ส่วนประกอบของเครื่องรีดฟิล์มไวแสงที่ในขั้นตอนการสร้างแบบหล่อ

ขั้นตอนการติดฟิล์มลงบนสเตนเลส

- 1. เปิดเครื่องรีดฟิล์มไวแสงและมอเตอร์ พร้อมปรับอุณหภูมิไว้ที่ 90 องศาเซลเซียส
- เตรียมฟิล์มโฟโต้รีซิส โดยการตัดฟิล์มให้มีขนาดใหญ่กว่าแผ่นสเตนเลสเล็กน้อย จากนั้น ทำการลอกแผ่นพลาสติกขุ่นออกเพียงหนึ่งในสี่ของฟิล์ม
- คว่ำฟิล์มโฟโต้รีซิสและนำไปติดบริเวณด้านบนของแผ่นสเตนเลส แล้วจึงป้อนเข้าเครื่อง รีดฟิล์มไวแสง เครื่องจะเริ่มดึงแผ่นสเตนเลสเข้าไปพร้อมกับฟิล์ม ให้ทำการจับแผ่น พลาสติกขุ่นไว้ให้ก่อยๆลอกออกจากฟิล์มโฟโด้รีซิส จนเครื่องรีดฟิล์มไวแสงดึงแผ่น สเตนเลสเข้าไปจนหมด ดังภาพที่ ก.6
- นำแผ่นสเตนเลสที่มีฟิล์มโฟโต้รีซิสติดอยู่ด้านบนเข้าเครื่องรีดฟิล์มไวแสงรีดซ้ำทั้งหมด
 4 รอบ เพื่อให้ฟิล์มโฟโต้รีซิสติดแน่นกับแผ่นสเตนเลส หลังจากนั้นปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นและ
 ติดฟิล์มโฟโต้รีซิสส่วนเกินออก ดังภาพที่ ก.7 พร้อมนำไปใช้งานในขั้นตอนต่อไป



ภาพที่ ก.6 ลักษณะการป้อนแผ่นสเตนเลสเข้าเกรื่องรีคฟิล์มไวแสง



ภาพที่ ก.7 แผ่นสเตนเลสที่ทำการติคฟิล์ม โฟโต้รีซิสแล้ว

กล่องยูวี

ในขั้นตอนการสร้างแบบหล่อใช้กระบวนการสร้างลวดลายด้วยแสง โดยในงานวิจัยนี้ใช้ กล่องฉายยูวีที่จัดทำขึ้นเองในการฉายแสง โดยกล่องฉายยูวีที่จัดทำขึ้นเองนี้จะประกอบด้วย หลอด ยูวีขนาด 10 วัตต์จำนวน 4 หลอด ซึ่งกล่องฉายยูวีนี้สามารถเลือกระยะห่างระหว่างชิ้นงานกับ ต้นกำเนิดแสงได้ ดังภาพที่ ก.8 โดยในงานวิจัยนี้จะใช้ระยะห่างระหว่างชิ้นงานกับต้นกำเนิดแสง เท่ากับ 3.25 เซนติเมตรและมีแรงกดดันที่มากกว่า 0.9 กิโลนิวตันต่อตารางเมตร [20]



ภาพที่ ก.8 กล่องฉายยูวี

การชุบโลหะด้วยกระบวนการไฟฟ้าเคมี

ในกระบวนการสร้างโครงสร้างทองแคงแบบลอยตัวใช้วิธีการชุบโลหะด้วยกระบวนการ ไฟฟ้าเคมี ซึ่งเป็นวิธีการเคลือบโลหะจากอิเล็กโทรดหนึ่งลงบนอิเล็กโทรดอีกฝั่งหนึ่งที่จุ่มอยู่ใน สารละลายอิเล็กโตรไลท์และมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับระบบ ภาพที่ 3.6 แสดงไดอะแกรม การปลูกฟิล์มโลหะด้วยวิธีการไฟฟ้าเคมีซึ่งอิเล็กตรอนจะวิ่งจากขั้วแอโนดที่เป็นชิ้นโลหะผ่าน สายไฟไปยังขั้วแกโทดที่เป็นชิ้นงานที่ต้องการปลูกโลหะ ทำให้ไอออนบวกจากขั้วแอโนดวิ่งผ่าน สารละลายอิเล็กโตรไลท์มาเกาะยังชิ้นงานที่ขั้วแกโทดได้

กระบวนการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าเคมีในงานวิจัยนี้ใช้ชิ้นงานทองแดงเป็นขั้วแอโนด แผ่นสเตนเลสที่ผ่านการสร้างแบบหล่อเป็นขั้วแคโทดและสารละลายคอปเปอร์ซัฟเฟตเป็น สารละลายอิเล็กโตรไลท์ ซึ่งกระบวนการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าเคมีในงานวิจัยนี้ได้แสดง ดังภาพที่ ก.9 ซึ่งประกอบด้วย ปั้มลม แท่งทองแดง แผ่นสเตนเลสที่ทำแบบหล่อตามลวดลายที่ ต้องการแล้ว อ่างสำหรับใส่สารละลายคอปเปอร์ซัตเฟต เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยในภาคผนวกนี้ จะกล่าวถึงขั้นตอนในการทำการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าเกมี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- 1. ติดตั้งอุปกรณ์ในการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าเคมีดังภาพที่ ก.9
- 2. นำชิ้นทองแคงจุ่มลงในสารละลายคอปเปอร์ซัตเฟต
- นำแผ่นสเตนเลสที่ผ่านการสร้างแบบหล่อมาหนีบกับแผ่นทองแคง ดังภาพที่ ก.10 แล้วนำ แผ่นสเตนเลสจุ่มลงในสารละลายคอปเปอร์ซัตเฟต
- 4. ต่อสายไฟขั้วบวกกับชิ้นทองแคงและต่อสายไฟขั้วลบกับแผ่นสเตนเลส
- ติดตั้งสายยางที่ต่อกับปั้มลมให้ปลายของสายยางอยู่บริเวณตรงกลางระหว่างชิ้นทองแดง กับแผ่นสเตนเลส เพื่อกวนสารละลายให้เกิดความปั่นป่วน ทำให้การปลูกทองแดงลงบน พื้นผิวของชิ้นงานมีความสม่ำเสมอมากขึ้น
- เปิดเครื่องง่ายกระแสไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อง่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ ทองแดงจะเริ่ม เคลือบลงบนแผ่นสเตนเลส รอจนกระทั่งได้ความหนาตามที่ต้องการจึงปิด เครื่องง่ายกระแสไฟฟ้า



ภาพที่ ก.9 การติดตั้งอุปกรณีในการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าเกมี



ภาพที่ ก.10 ลักษณะในการจับยึดแผ่นสเตนเลสในการชุบ โลหะด้วยไฟฟ้าเคมี

สำหรับกระแสไฟฟ้าที่ง่ายเข้าสู่ระบบและระยะเวลาในการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าเคมี ในงานวิจัยนี้ได้นำแนวคิดในการง่ายกระแสไฟฟ้าในการชุบโลหะไฟฟ้าจากความสัมพันธ์ระหว่าง ค่ากระแสไฟฟ้าต่อหน่วยพื้นที่ในหน่วยมิลลิแอมแปร์ต่อตารางเซนติเมตรกับอัตราการปลูกฟิล์ม ของทองแดงในหน่วยไมโครเมตรต่อชั่วโมง ของการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าเคมีในงานวิจัยของภากร นนทิวัฒน์วณิช (2010) มาประยุกต์ใช้งาน โดยในงานวิจัยนี้สามารถสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าวได้ ดังภาพที่ ก.11 ซึ่งสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ตามสมการข้างล่าง จากสมการนี้สามารถนำมาหา กระแสไฟฟ้าและระยะเวลาในการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าเคมีเพื่อนำมาใช้ในการสร้างโครงสร้าง ทองแดงของงานวิจัยนี้ได้

$$y = 0.0934x + 5.7051$$

y คืออัตราการปลูกฟิล์มของทองแดง (ไมโครเมตรต่อชั่วโมง)
 x คือค่ากระแสไฟฟ้าต่อหน่วยพื้นที่ (มิลลิแอมแปร์ต่อตารางเซนติเมตร)



ภาพที่ ก.11 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากระแสไฟฟ้าต่อหน่วยพื้นที่กับอัตราการปลูกฟิล์ม ของทองแดง

เครื่องสปัตเตอริง

ในขั้นตอนการเคลือบผิวด้วยนิทินอล ในงานวิจัยนี้จะใช้เทคนิคการสปัตเตอริง ซึ่งเป็น วิธีการเร่งประจุของก๊าซอาร์กอนไปชนกับนิทินอลภายใต้สภาวะสูญญากาศ ทำให้นิทินอลแตกตัว เป็นอนุภาคและกระเด็นลงมาเคลือบบนโครงสร้างทองแดง โดยในงานวิจัยนี้ทำการเคลือบผิว นิทินอลด้วยเครื่องสปัตเตอริง ดังภาพที่ ก.12 ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ (NECTEC) โดยในภาคผนวกนี้จะกล่าวถึงส่วนประกอบของเครื่องสปัตเตอริงและ ขั้นตอนในการเตรียมเครื่องสปัตเตอริงสำหรับการเคลือบผิวด้วยนิทินอล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนประกอบของเครื่องสปัตเตอริง

- ห้องใส่ชิ้นงานสูญญากาศ สำหรับใส่ชิ้นงานที่ต้องการทำการเคลือบลงไป โดยด้านบนของ ห้องสูญญากาศเป็นส่วนที่ต้องบรรจุส่วนของ target บริเวณฝาปิดของห้องใส่ชิ้นงาน สูญญากาศ ดังภาพที่ ก.13 และ ภาพที่ ก.14 ตามลำดับ
- 2. มาตรวัคสูญญากาศภายในห้องสูญญากาศ
- มาตรวัดอัตราการใหลของก๊าซ เพื่อวัดอัตราการใหลของก๊าซอาร์กอนที่ใช้ในการเคลือบผิว ด้วยนิทินอล ซึ่งสามารถหมุนปรับอัตราการใหลของก๊าซตามที่ต้องการได้

- 4. เครื่องควบคุม RF sputtering ใช้ในการควบคุมการสปัตเตอริงด้วย RF ซึ่งในงานวิจัยนี้ใช้ สำหรับการทำความสะอาคชิ้นงานภายในห้องใส่ชิ้นงานสูญญากาศ
- เครื่องควบคุม DC magnetron sputtering เพื่อควบคุมกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการสร้าง สนามแม่เหล็กภายในห้องใส่ชิ้นงานสูญญากาศเพื่อเหนี่ยวนำให้อนุภาคของนิทินอลไป เคลือบยังผิวของชิ้นงาน



ภาพที่ ก.12 เครื่องสปัตเตอริงที่ใช้ในกระบวนการเคลือบผิวด้วยนิทินอล ณ สูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ



ภาพที่ ก.13 ส่วนที่ต้องบรรจุส่วนของ target ของเกรื่องสปัตเตอริง



ภาพที่ ก.14 ลักษณะภายในเครื่องสปัตเตอริง

ขั้นตอนในการเตรียมเครื่องสปัตเตอริงสำหรับการเกลือบผิวด้วยนิทินอล

- เปิดห้องใส่ชิ้นงานสูญญากาศและวางฐานที่มีชิ้นงานวางอยู่ด้านบนลงบนตำแหน่งวางฐาน ภายในห้องใส่ชิ้นงานบริเวณตรงกึ่งกลาง
- ทำการเปลี่ยน target ที่ต้องการทำการเคลือบผิว บริเวณด้านบนของฝาปิดห้องใส่ชิ้นงาน สูญญากาศ โดยในงานวิจัยนี้ใช้ target เป็นนิทินอล อัตราส่วน 50:50 (Ni:Ti) ตรวจสอบว่า target ติดกับตัวระบายความร้อนแนบสนิท หลังจากนั้นทำการล๊อค target และขันน๊อตให้ แน่น
- ปิดฝาห้องใส่ชิ้นงานสูญญากาศและทำการเปิดปั๊มสูญญากาศและรอจนถึงความคันที่ ต้องการ ในงานวิจัยนี้จะทำการเคลือบผิวที่ความคัน 10⁻⁵ มิลลิบาร์ (ใช้เวลาในการรอ ประมาณ 1 ชั่วโมง)
- 4. เปิดเกรื่องควบคุมและปรับอัตราการใหลของก๊าซอาร์กอนจนได้ความดันที่ต้องการ
- เปิดเครื่องควบกุม RF sputtering และตั้งเวลาสำหรับทำความสะอาดชิ้นงานภายในห้องใส่ ชิ้นงานสูญญากาศ แล้วกดสวิทซ์เริ่มต้นทำความสะอาดชิ้นงาน หลังจากทำความสะอาด เสร็จจึงปิดเครื่อง RF sputtering

- เปิดเครื่องควบคุม DC magnetron sputtering และตั้งเวลาในเคลือบผิว หลังจากนั้นกด สวิทซ์เริ่มทำการเคลือบผิวและปรับกระแสตามที่ต้องการ เมื่อทำการเคลือบผิวเสร็จ ทำการ ปิดเครื่องควบคุม DC magnetron sputtering และก๊าซอาร์กอน
- ปิดปั้มสูญญากาศ รอจนกว่ารอบของปั้มลดลงต่ำกว่า 600 รอบต่อนาที แล้วจึงปิดระบบปั้ม ทั้งหมด
- 8. เปิดฝาห้องใส่ชิ้นงานสูญญากาศและนำฐานที่มีชิ้นงานด้านบนอยู่ออกมา

เตาอบแบบหลอดควอทซ์โดยมีก๊าซไหลผ่าน

การสร้างฟิล์มนิทินอลประกอบด้วย 2 กระบวนการกือ กระบวนการเกลือบผิวด้วยนิทินอล กับกระบวนการอบหลังการเกลือบผิวด้วยนิทินอล โดยกระบวนการอบหลังการเกลือบผิวด้วย นิทินอลหรือขั้นตอนในการอบฟิล์มนิทินอลนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่ทำให้โครงสร้างภายใน ของนิทินอลเปลี่ยนแปลงจากอมอฟ์สเป็นโครงสร้างผลึก ซึ่งทำให้ฟิล์มนิทินอลที่ผ่านการอบมี คุณสมบัติการเปลี่ยนแปลงรูปและกืนรูปได้และสภาพยึดหยุ่นยิ่งยวด เป็นต้น โดยทั่วไปในขั้นตอน การอบฟิล์มนิทินอลนี้จะทำการอบที่อุณหภูมิสูงกว่า 450 องสาเซลเซียสเพื่อทำให้โครงสร้างภายใน ของฟิล์มนิทินอลนี้จะทำการอบที่อุณหภูมิสูงกว่า 450 องสาเซลเซียสเพื่อทำให้โครงสร้างภายใน ของฟิล์มนิทินอลมีการเปลี่ยนแปลง โดยในงานวิจัยนี้จะทำขั้นตอนการอบฟิล์มนิทินอลด้วยเตาอบ แบบหลอดควอทซ์โดยมีก๊าซไหลผ่าน สำหรับก๊าซที่ใช้ในการอบคือ ก๊าซอาร์กอน เพราะว่า ก๊าซอาร์กอนเป็นก๊าซที่มีราคาถูกและสามารถป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นภายใน หลอดควอทซ์ เตาอบที่ใช้งานนี้จะประกอบด้วย หลอดควอทซ์ เตาอบ ปั้มสูญญากาศและอุปกรณ์ กวบกุมอุณหภูมิในการอบ สำหรับเตาอบแบบหลอดกวอทซ์โดยมีก๊าซไหลผ่านนี้เป็นเตาอบของ ภากวิชาโลหะการ กณะวิสวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงดังภาพที่ ก.15



ภาพที่ ก.15 เตาอบแบบหลอดควอทซ์โดยมีก๊าซอาร์กอนไหลผ่าน

ภาคผนวก ข

เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบคุณลักษณะจำเพาะของใมโครแอคชัวเอเตอร์

เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาแฟกเตอร์ที่มีอิทธิผลต่อคุณลักษณะจำเพาะของนิทินอล หนึ่ง ในนั้นคือความเป็นโครงสร้างผลึกของนิทินอล โดยสามารถทำการศึกษาได้โดยใช้เครื่องวิเคราะห์ การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ ซึ่งเครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์นี้เป็นเครื่องวิเคราะห์ คุณสมบัติของวัสดุโดยอาศัยการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ แสดงดังภาพที่ ข.1 แสดงแท่นวางชิ้นงาน และภาพที่ ข.2 แสดงลักษณะของเครื่องมือ สำหรับชิ้นงานที่จะนำไปทำการทดสอบนั้นควรมีขนาด อย่างน้อย 1x1 ตารางเซนติเมตร เพื่อทำให้ได้ผลวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เครื่องวิเคราะห์ การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ที่ใช้ในการทดสอบไม โครแอคชัวเอเตอร์ในงานวิจัยนี้ ตั้งอยู่ที่ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถติดต่อเพื่อทำการทดสอบได้ที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เบอร์ 02-218-5443



ภาพที่ ข.1 ฐานวางชิ้นงานสำหรับทำการทคสอบค้วยเครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอ๊กซ์



ภาพที่ ข.2 เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เครื่องวิเคราะห์ชาตุเชิงพลังงาน

การศึกษาส่วนประกอบธาตุของตัวอย่างสามารถทำใด้จากใช้เครื่องวิเคราะห์ธาตุเชิง พลังงาน ซึ่งเครื่องวิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงานเป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุทางเคมี ของสารตัวอย่าง โดยอาศัยการวัดพลังงานของรังสีเอ็กซ์ที่คายออกมา ซึ่งธาตุแต่ละธาตุจะมีการคาย พลังงานที่แตกต่างกัน จากหลักการนี้จึงสามารถระบุใด้ว่าสารตัวอย่างที่ทำการวิกราะห์นี้เป็นธาตุ ชนิดใด ในการวิเคราะห์ธาตุของเครื่องวิเกราะห์ธาตุเชิงพลังงานจะสามารถกำหนดพื้นที่ในการ วิเกราะห์ได้โดยมีความลึกในการวิเกราะห์เพียง 1 ไมโกรเมตร ภาพที่ ข.3 แสดงปริมาตรที่ทำการ วิเกราะห์ธาตุด้วยเกรื่องวิเกราะห์ธาตุเชิงพลังงาน โดยในงานวิจัยนี้ใช้เกรื่องวิเกราะห์ธาตุเชิง พลังงานที่คณะวิทยาสาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถติดต่อเพื่อทำการทดสอบได้ที่ ศูนย์วิจัยทางฟิสิกส์ของฟิล์มบาง ภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เบอร์ โทรศัพท์ 02-218-5108



ภาพที่ ข.3 ลักษณะปริมาตรที่ทำการวิเคราะห์ธาตุด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงาน

เครื่องวัดการถ่ายเทความร้อน

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของนิทินอลได้จากใช้เครื่องวัดการถ่ายเทความร้อน ซึ่ง เครื่องวัดการถ่ายเทความร้อนเป็นเครื่องที่ใช้เทคนิคในการวิเคราะห์วัสดุด้วยการเปรียบเทียบ ก่าพลังงานที่ใช้เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสารตัวอย่างและสารมาตราฐานจากการวัดการถ่ายเท ความร้อน โดยค่าพลังงานที่ใช้เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของทั้งสองสารจะแตกต่างกันต่อเมื่อมี การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ซึ่งพื้นภายในกราฟของการทดสอบที่ เกิดขึ้นจะมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงความร้อนและ โครงสร้างภายในของสารตัวอย่างด้วย ในภาคผนวกนี้จะกล่าวถึงการเตรียมอุปกรณ์และตัวอย่างที่จะนำไปทำการทดสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ในการทดสอบด้วยเครื่องวัดการถ่ายเทความร้อนนี้สามารถเลือกช่วงในการทดสอบได้ หากต้องการทำการทดสอบตั้งแต่อุณหภูมิที่ต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง (25 องศาเซลเซียส) จนถึงอุณหภูมิ ที่ต้องการ เครื่องวัดการถ่ายเทความร้อนจำเป็นต้องใช้ก๊าซไนโตรเจนเหลวเพื่อทำให้อุณหภูมิของ ชิ้นงานที่ทำการทดสอบมีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิห้องด้วยเช่นกัน

การเตรียมชิ้นงานสำหรับทำการทคสอบด้วยเกรื่องวัดการถ่ายเทความร้อนนี้ จำเป็นต้องทำ การบรรจุตัวอย่างเข้าไปในภาชนะขนาดเล็ก ซึ่งเป็นภาชนะที่ใช้เฉพาะสำหรับการทคสอบด้วย เครื่องวัดการถ่ายเทความร้อนแสดงคังภาพที่ ข.4 โดยมีข้อกวรระวังคือ

- ควรระวังไม่ให้มีช่องอากาศระหว่างชิ้นงานที่ทำการบรรจุลงในภาชนะขนาดเล็ก เพื่อ ป้องการผลการทดสอบที่คลาดเคลื่อนเนื่องจากมีอากาศเข้าไปรบกวนในการทดสอบ
- ตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบควรมีน้ำหนักอย่างน้อย 5 มิลลิกรัม เพื่อทำให้ผล การทดสอบด้วยเครื่องวัดการถ่ายเทความร้อนมีความแม่นยำ

โดยในงานวิจัยนี้ใช้เครื่องวัดการถ่ายเทความร้อนที่ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถติดต่อเพื่อขอใช้เครื่องมือได้ จากอาจารย์ คร.วรัญ แต้ไพสิฐพงษ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย



ภาพที่ ข.4 ลักษณะภาชนะขนาดเล็กที่ใช้ในการทดสอบด้วยเครื่องวัดการถ่ายเทความร้อน

ภาคผนวก ค การทดสอบไมโครแอคชัวเอเตอร์เบื้องต้น

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการทดสอบไมโครแอคชัวเอเตอร์เบื้องต้น ซึ่งเป็นการทดสอบ การตอบสนองเชิงสถิตย์ โดยทำการทดสอบไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่มีลักษณะเป็นคานสองชั้นที่ ประกอบด้วยนิทินอลกับทองแดงซ้อนทับกันซึ่งมีความหนาเท่ากับ 5.5 และ 20 ไมโครเมตร ตามลำดับในการทดสอบจะทำการวัดระยะกระดกของไมโครแอคชัวเอเตอร์ทั้งสามชนิดคือ ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ไม่ทำการอบไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการอบด้วยแบบหล่อที่มีลักษณะ แบนราบและโค้งในขณะที่ทำการเพิ่มอุณหภูมิสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบการตอบสนอง เชิงสถิตย์เบื้องต้นแสดงดังภาพที่ ค.1 ซึ่งประกอบด้วย

- 1. เครื่องฮอตเพลต
- 2. กล่องกระจกสำหรับครอบชิ้นงานทคสอบ
- 3. กล้องวีดีโอไมโครสเกล (digital micro camera)
- อินฟาเรดเทอร์ โมมิเตอร์

ในการทดสอบการตอบสนองเชิงสถิตย์เบื้องต้นจะทำการทดสอบไมโครแอคชัวเอเตอร์ พร้อมกันทั้งสามชนิด โดยจะทำการจับยึดไมโครแอคชัวเอเตอร์ด้วยกระจกแล้วทำการติดตั้งบน เกรื่องฮอตเพลตและครอบด้วยกล่องกระจก จากนั้นทำการเปิดเครื่องฮอตเพลตเพื่อทำการเพิ่ม อุณหภูมิให้กับไมโครแอคชัวเอเตอร์ โดยจะทำการเพิ่มอุณหภูมิให้กับไมโครแอคชัวเอเตอร์ อย่างช้าๆ ที่อัตราการเพิ่มอุณหภูมิเท่ากับ 1.4 องสาเซลเซียสต่อนาที และลดอุณหภูมิอย่างช้าๆ ที่ อัตราการลดอุณหภูมิเท่ากับ 1.3 องสาเซลเซียสต่อนาที สำหรับการวัดระยะกระดกของ ไมโครแอคชัวเอเตอร์จะใช้เทคนิกการตัดต่อวิดีโอมาประยุกต์ใช้ โดยการบันทึกภาพการกระดกของ ใมโกรแอคชัวเอเตอร์ด้วยกล้องวีดีโอไมโครสเกลที่ทำการติดตั้งไว้ด้านบนของกล่องกระจกและทำ การหาระยะกระดกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Photoshop) อีกทั้งยังทำการวัดอุณหภูมิของ ใมโครแอคชัวเอเตอร์ด้วยอินฟาเรคเทอร์โมมิเตอร์พร้อมกันด้วย ซึ่งทำการวัดบนแผ่นกระจกและ อาจจะทำให้กวามผิดพลาดในการวัดเกิดขึ้นได้

ภาพที่ ค.2(ก) แสดงลักษณะในการยึดจับไมโครแอคชัวเอเตอร์ด้วยกระจกและเมื่อทำ การเปิดเครื่องฮอตแพลต ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่มีลักษณะเป็นคานสองชั้นที่ประกอบด้วยนิทินอล กับทองแดงซ้อนทับกันจะเกิดการกระดก โดยไมโครแอกชัวเอเตอร์ทั้งสามชนิดจะกระดกไปทาง ด้านขวาหรือไปในทิศทางนิทินอล ซึ่งในภาพที่ ค.2(ข) แสดงลักษณะการกระดกของ ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่อุณหภูมิ 125 องสาเซลเซียส กราฟแสดงความสัมพันธ์ของอุณหภูมิของ ไมโครแอคชัวเอเตอร์ค่อระยะกระคกของไมโครแอคชัวเอเตอร์แสดงดังภาพที่ ค.3 พบว่า เมื่อทำ การเพิ่มอุณหภูมิ ไมโครแอคชัวเอเตอร์จะเกิดการกระคกไปทางด้านขวา และเมื่อไมโครแอคชัวเอเตอร์ มีอุณหภูมิสูงขึ้น ระยะกระดกของไมโครแอคชัวเอเตอร์ก็สูงขึ้นเช่นกัน แต่เมื่อทำการหยุดให้ความ ร้อนจะทำให้อุณหภูมิต่ำลง ไมโครแอคชัวเอเตอร์จะกระคกกลับไปทางซ้ายหรือไมโครแอคชัวเอเตอร์ จะมีระยะกระคกที่ลดลงแล้วกลับมาอยู่ในคำแหน่งเดิมในที่สุด โดยไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำ การอบจะมีระยะกระคกที่มากกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจน แต่เมื่อทำการเปรียบเทียบระยะกระคกของ ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการอบด้วยแบบหล่อคอนกรีตที่มีลักษณะแบนราบกับไมโครแอคชัวเอเตอร์ ที่ทำการอบด้วยบบหล่อที่มีลักษณะโค้ง พบว่า ระยะกระคกของไมโครแอคชัวเอเตอร์ของทั้งสอง ชนิดนี้มีระยะกระคกที่ใกล้เกียงกัน โดยที่ที่อุณหภูมิเท่ากับ 125 องสาเซลเซียสจะทำให้ ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ไม่ทำการอบ ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการอบด้วยแบบหล่อที่มีลักษณะ แบนราบและโค้ง มีระยะกระคกเท่ากับ 2.3, 3.0 และ 3.6 มิลลิเมตร ตามลำดับ ดังนั้นจากผล การทดสอบไมโครแอคชัวเอเตอร์สามารถสรุปได้ว่า การอบพีล์มนิทินอลที่อุณหภูมิสูงมีผลต่อระยะ กระคกของไมโครแอคชัวเอเตอร์ แต่ลักษณะในการอบด้วยแบบหล่อคอนกรีตจะมีผลเพียงเล็กน้อย ต่อระยะกระดกของไมโครแอคชัวเอเตอร์

แต่อย่างไรก็ตามในการทดสอบการตอบสนองเชิงสถิตย์เบื้องต้นด้วยชุดการทดสอบนี้ ต้อง ใช้ระยะเวลาในการทดสอบที่นานและการวัดระยะกระดกของไมโครแอคชัวเอเตอร์ด้วยเทคนิก การตัดต่อวิดีโอนี้มีความแม่นยำก่อนข้างต่ำ เนื่องจากลักษณะในการบันทึกภาพด้วยกล้องวีดีโอ ไมโครคาเมร่าที่นำมาใช้งานนี้ มีความรายละเอียดในการบันทึกภาพที่ต่ำ ซึ่งอาจทำให้เกิดความ กลาดเกลื่อนในการหาระยะกระดกของไมโครแอคชัวเอเตอร์ได้ง่าย จากข้อเสียของชุดทดสอบ เบื้องต้นที่ได้กล่าวถึงนี้ งานวิจัยจึงมีการปรับปรุงชุดทดสอบเพื่อทำให้การทดสอบมีความแม่นยำ ยิ่งขึ้น



(ก)



(ป)

ภาพที่ ค.1 ชุดทคสอบไมโครแอกชัวเอเตอร์ในการทคสอบการตอบสนองเชิงสถิติเบื้องต้น (ก) ไคอะแกรมแสดงชุดทคสอบ (ข) ภาพถ่ายชุดทคสอบ



ภาพที่ ค.2 ลักษณะการกระดกของไมโครแอคชัวเอเตอร์ (ก) ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส (ข) ที่ อุณหภูมิ 125 องศาเซลเซียส โดย A: ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ไม่ทำการอบ B: ไมโครแอคชัวเอเตอร์ ที่ทำการอบด้วยแบบหล่อที่มีลักษณะแบนราบ C: ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการอบด้วยแบบหล่อที่ มีลักษณะโค้ง (รัศมีความโค้งเท่ากับ 22 มิลลิเมตร)



ภาพที่ ค.3 กราฟแสดงการเปรียบเทียบระยะกระดกต่ออุณหภูมิของไมโครแอคชัวเอเตอร์แบบ ต่างๆ

ภาคผนวก ง

ชุดอุปกรณ์และการจัดการผลในการทดสอบไมโครแอคชั่วเอเตอร์

การติดตั้งเครื่องมือในการทดสอบการตอบสนองเชิงสถิตย์

ในการทคสอบการตอบสนองเชิงสถิตย์นี้จะทำการวัคระยะกระคกของไมโครแอคชั่วเอเตอร์ แบบโลหะผสมจำรูปที่มีลักษณะเป็นคานสองชั้นที่ประกอบด้วยนิทินอลกับทองแดงซ้อนทับกันใน ขณะที่ทำการเพิ่มอุณหภูมิ พร้อมด้วยทำการวัดอุณหภูมิของไมโครแอคชั่วเอเตอร์ในขณะเดียวกัน โดยในผนวกนี้จะกล่าวถึงเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบและข้อควรระวังในการทดสอบ

เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบการตอบสนองเชิงสถิตย์แสดงดังภาพที่ ง.1 ประกอบด้วย อุปกรณ์ต่างๆดังนี้

- 1. เครื่องฮอตเพลต
- 2. เครื่องออสซิลโลสโคป
- 3. เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์และมิเตอร์
- 4. เกรื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์
- 5. อินฟาเรคเทอร์โมมิเตอร์



ภาพที่ ง.1 ชุดทคสอบไมโครแอกชั่วเอเตอร์ในการทคสอบการตอบสนองเชิงสถิตย์

ในการทคสอบการตอบสนองเชิงสถิตย์ของไมโครแอคชั่วเอเตอร์เป็นการทคสอบโคยมี การเพิ่มอุณหภูมิให้กับไมโครแอคชั่วเอเตอร์โดยตรงด้วยเครื่องฮอตเพลต จากการทคสอบมี ข้อควรระวังดังนี้

- ในการเพิ่มอุณหภูมิให้กับไมโครแอคชัวเอเตอร์ด้วยเครื่องฮอตเพลตจะทำโดยการหมุน สวิทซ์ปรับอุณหภูมิของเครื่องฮอตเพลตไปยังค่าค่าหนึ่งและเปิดเครื่องไว้ตามระยะเวลาที่ กำหนด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการทดสอบจำเป็น ด้องห้ามปรับอุณหภูมิเกิน 250 องสาเซลเซียสเป็นระยะเวลานานกว่า 2 นาที เนื่องจาก อุณหภูมิและเวลาดังกล่าวนี้สามารถทำให้ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ทำการทดสอบเกิด การเสียรูป หรือบิดงอ หรือเกิดการลุกใหม้ได้ สำหรับในการทดสอบการตอบสนอง เชิงสถิตย์ของงานวิจัยนี้ทำการหมุนสวิทซ์ปรับอุณหภูมิไปที่ 150 องสาเซลเซียสและเปิด เครื่องเป็นระยะเวลา 2 นาที
- ในระหว่างทำการทดสอบการตอบสนองเชิงสถิตย์โดยมีเครื่องฮอตแพลตใช้ในการเพิ่ม กวามร้อน ไมโครแอคชัวเอเตอร์จะเกิดการกระดกสั่นขึ้นลงได้ เนื่องจากไมโกรแอคชัวเอเตอร์ มีการแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศรอบๆ ไมโครแอคชัวเอเตอร์ตลอดเวลาและพลังงานที่ ให้กับ ไมโครแอคชัวเอเตอร์นี้มีอัตราในการจ่ายพลังงานที่ต่ำกว่า จึงทำให้ ไมโครแอคชัวเอเตอร์เกิดการสั่นขึ้นลงได้
- 3. การทดสอบการตอบสนองเชิงสถิตย์ของไมโครแอคชัวเอเตอร์นี้ จำเป็นต้องทำการวัด อุณหภูมิของไมโครแอคชัวเอเตอร์ โดยการวัคอุณหภูมิของไมโครแอคชัวเอเตอร์นี้ควรทำ การ วัคที่บริเวณปลายของไมโครแอคชัวเอเตอร์ เนื่องจากบริเวณปลายของ ไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่บอกถึงอุณหภูมิจริงของไมโครแอคชัวเอเตอร์ ซึ่งจะมี การแลกเปลี่ยนความร้อนของไมโครแอคชัวเอเตอร์อยู่ ในทางตรงกันข้ามหากทำการวัด อุณหภูมิของไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่บริเวณฐานที่ทำการยึดติดกับแผ่นกระจก จะเป็น การวัดอุณหภูมิแผ่นกระจกแทน เนื่องจากแผ่นกระจกมีอัตราการแลกเปลี่ยนความร้อนกับ อากาศภายนอกที่ช้าและมีการเก็บสะสมความร้อนได้ดี จึงทำให้มีการส่งความร้อนให้กับ ฐานของไมโครแอคชัวเอเตอร์ตลอดเวลา ซึ่งอุณหภูมิของฐานที่ถูกจับยึดด้วยแผ่นกระจก จะเท่ากับอุณหภูมิของแผ่นกระจกนั้นเอง ดังนั้นอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผลการทดสอบ ผิดได้หากทำการวัดผิดตำแหน่ง

การติดตั้งเครื่องมือในการทดสอบการตอบสนองเชิงจลน์

ในการทคสอบการตอบสนองเชิงจลน์นี้จะทำการวัดระยะกระคกของไมโครแอคชัวเอเตอร์ แบบโลหะผสมจำรูปที่มีลักษณะเป็นคานสองชั้นที่ประกอบด้วยนิทินอลกับทองแดงซ้อนทับกัน โดยการจ่ายกระแสไฟฟ้ากลื่นสี่เหลี่ยมที่มีขนาดต่างๆและความถิ่ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าต่างๆ โดย ในภาคผนวกนี้จะกล่าวถึงเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบและข้อควรระวังในการทดสอบ

เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบการตอบสนองเชิงจลน์แสดงดังภาพที่ ง.2 ประกอบด้วย อุปกรณ์ต่างๆดังนี้

- 1. เกรื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับไมโครแอคชัวเอเตอร์
- 2. เครื่องกำเนิคกระแสไฟฟ้า
- เครื่องออสซิลโลสโคป
- 4. เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์และมิเตอร์
- 5. เกรื่องง่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์



ภาพที่ ง.2 ชุดทดสอบไมโครแอกชัวเอเตอร์ในการทดสอบการตอบสนองเชิงจลน์

ในการทดสอบการตอบสนองเชิงจลน์ของงานวิจัยนี้เป็นการวัดระยะกระดกของ ใมโครแอกชัวเอเตอร์เมื่อทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าและมีความถี่ต่างๆ จากการทดสอบมีข้อกวรระวัง ดังนี้

- ในการจ่ายกระแส ไฟฟ้าให้กับ ไมโครแอคชัวเอเตอร์ ไม่ควรจ่ายกระแส ไฟฟ้าเกิน
 แอมแปร์ เนื่องจากการจ่ายกระแส ไฟฟ้าที่สูงจะทำให้เกิดการสะสมความร้อนภายใน
 ไมโครแอคชัวเอเตอร์อย่างรวดเร็วส่งผลให้ ไมโครแอคชัวเอเตอร์เกิดการเผาไหม้ หรือเกิด การเสียหายขึ้น จำเป็นต้องระวังเป็นอย่างยิ่ง
- 2. ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าไม่ควรจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ความถี่ต่ำจนเกินไป เนื่องจากที่ความถี่ต่ำ จะมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับไมโครแอคชัวเอเตอร์เป็นระยะเวลานาน ไมโครแอคชัวเอเตอร์ จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นและทำให้ระยะกระดกของไมโครแอคชัวเอเตอร์สูงขึ้นเรื่อยๆด้วย เช่นกัน ซึ่งอาจทำให้ไมโครแอคชัวเอเตอร์หลุดออกจากลำแสงของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์ เซนเซอร์ที่ใช้ในการวัดได้โดยในงานวิจัยนี้มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ 1.25 แอมแปร์ที่ ความถี่ต่ำที่สุดคือ 0.5 เฮิร์ทซ ซึ่งการจ่ายกระแสไฟฟ้าตามสภาวะดังกล่าวนี้ สามารถ วัดระยะกระดกของไมโครแอคชัวเอเตอร์ได้
- ในการทดสอบของงานวิจัยนี้จะทำการจับยึดไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่ความยาว 22.5 มิลลิเมตร โดยปกติเมื่อทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ความถี่สูงขึ้นเรื่อยๆไมโครแอคชัวเอเตอร์ จะมีระยะกระดกต่ำลงแต่จากการศึกษาจะพบกับความถี่ที่ทำให้เกิดระยะกระดกของ ใมโครแอคชัวเอเตอร์มีค่าสูงมากขึ้น ซึ่งความถี่นี้เป็นความถี่ธรรมชาติของ ใมโครแอคชัวเอเตอร์นั้นเองโดยความถี่เรโซแนนซ์ของไมโครแอคชัวเอเตอร์ที่มีความยาว 22.5 มิลลิเมตรเท่ากับ 20 เฮิร์ทซ

การคำนวณหาแอมพลิจูดของไมโครแอคชั่วเอเตอร์ในการทดสอบการตอบสนองเชิง จลน์

ในการการทดสอบการตอบสนองเชิงจลน์ในงานวิจัยนี้ ได้ทำการวัดระยะกระดกของ ไมโครแอกชัวเอเตอร์แบบโลหะผสมจำรูปที่มีลักษณะเป็นคานสองชั้นที่ประกอบด้วยนิทินอลกับ ทองแดงซ้อนทับกันที่ได้รับการจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ทำการเก็บค่า มาได้ง่ายขึ้น งานวิจัยนี้จึงมีแนวกิดในการนำข้อมูลการทดสอบนี้มาจัดการเพื่อทำการเปลี่ยนจาก ก่าระยะกระดกของไมโครแอกชัวเอเตอร์เป็นก่าแอมพลิจูดของไมโครแอกชัวเอเตอร์ด้วย การคำนวณหาแอมพถิจูดของไมโครแอคชั่วเอเตอร์แนวคิดในการหาค่าแอมพถิจูดแสดง ดังภาพที่ ง.3 โดยทำการวัดระยะกระดกสูงสุดของไมโครแอคชั่วเอเตอร์และวัดระยะต่ำสุดของ ไมโครแอคชั่วเอเตอร์จากนั้นนำมาหาระยะระหว่างระยะกระดกสูงสุดและระยะกระดกต่ำสุด ซึ่ง จากแนวคิดนี้สามารถทำให้กำนวณแอมพลิจูดของไมโครแอกชั่วเอเตอร์ได้จากสมการนี้

 $Amplitude = D_1 - D_2$



ภาพที่ ง.3 แนวกิคในการหาแอมพลิจูดของไม โครแอกชัวเอเตอร์

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นายเอกยุทธ ว่องวีระยุทธ์ เกิดเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ 2529 ที่จังหวัดพัทลุง เป็นบุตรคน กลางของนายไพบูลย์ ว่องวีระยุทธ์ และนางลัดดา ว่องวีระยุทธ์ สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรม ศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาลัยวิทยาลัยพระจอมเกล้า กรุงธนบุรี ปีการศึกษา 2552 และได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรมมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2553

<u>บทความที่ได้รับการตีพิมพ์</u>

- เอกยุทธ ว่องวีระยุทธ์, อลงกรณ์ พิมพ์พิณ, วีระยุทธ ศรีธุระวานิช. กระบวนการผลิต โครงสร้างคานสองชั้นแบบลอยตัวระหว่างนิทินอลกับทองแดงสำหรับแอคชัวเอเตอร์แบบ โลหะผสมจำรูป. <u>การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่</u> <u>25.</u> AMM72. 19 - 21 ตุลาคม 2554 โรงแรมอ่าวนาง วิลล่า รีสอร์ท จังหวัดกระบี่
- Eakayoot Wongweerayoot, Werayut Srituravanich, Alongkorn Pimpin. Parametric study of an annealing process for a fabrication of bimorph nitinol-copper cantilever using quartz tube furnace with argon overflow. <u>1st Mae Fah Luang University International</u> <u>Conference 2012.</u> O-SC-A-10. 29 Nov - 1 Dec 2012. Mae Fah Luang University, Chiang Rai.